

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

"ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ"

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΗΤΡΑΣ ΝΙ-Ρ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΙΟ₂

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε. Α. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ, Φεβρουάριος 2013



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

"ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ"

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΗΤΡΑΣ ΝΙ-Ρ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΙΟ₂

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Δ. Μανωλάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κ. Καραντώνης, Λέκτορας Ε.Μ.Π.

Ε. Παυλάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ, Φεβρουάριος 2013

Αφιερωμένη στον εαυτό μου, σε αυτούς που με πίστεψαν και σε αυτούς που με αμφισβήτησαν... Άμες Δε Γεσόμεθα, Πολλώ Κάρρονες

Σπαοτιατική οήση

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των ώ ο ίσαν και φυλάγουν Θεομοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κ' ευσπλαχνία γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και πεφισσότεφη τιμή τούς πφέπει όταν πφοβλέπουν (και πολλοί πφοβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ' οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Ευχαριστίες

Η εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Γενικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η ολοκλήφωση της μεταπτυχιακής εφγασίας κατέστη δυνατή χάφη στη βοήθεια και την συμβολή κάποιων ανθφώπων, τους οποίους θα ήθελα να ευχαφιστήσω.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Παυλάτου, η οποία ήταν η επιβλέπουσα της μεταπτυχιακής εργασίας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποστήριξή της, τη βοήθειά της και την καθοριστική συμβολή της κατά την ολοκλήρωση και τη διόρθωση αυτής της εργασίας.

Ευχαφιστώ θεφμά τα μέλη της εξεταστικής επιτφοπής της μεταπτυχιακής, τον Καθηγητή κ. Δ. Μανωλάκο και τον Λέκτοφα κ. Κ. Καφαντώνης για την τιμή που μου έκαναν να συμμετάσχουν στην εξεταστική επιτφοπή.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαφιστώ οφείλω στον Χημικό υποψήφιο διδάκτοφα Τσούκλεφη Δημήτφιο. Από την πφώτη έως την τελευταία στιγμή της πφοσπάθειας αυτής, ήταν δίπλα μου ουσιαστικά, πφοσφέφοντάς μου σημαντικότατη βοήθεια μέσα από, τις γνώσεις του, τις ιδέες του και την εμπειφία του. Επιπλέον, τον ευχαφιστώ ιδιαίτεφα για την καθοφιστική συμβολή του στην ολοκλήφωση της παφούσας εφγασίας, καθώς δεν δίστασε να θυσιάσει ακόμα και τον πφοσωπικό του χφόνο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σε αυτό το σημείο, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, τα πρόσωπα με τα οποία μοιράστηκα την καθημερινότητα του εργαστηρίου: Καλπακιώτη Βίκυ, Θωμαή Μακρή Ασπιώτη Κωνσταντίνο, Νικολίνα Χρονοπούλου Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χειριστή του S.Ε.Μ Πέτρο Σχοινά για την σημαντική βοήθειά του.

Τέλος, το πιο μεγάλο ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά μου, τη Ρούντη και τον Μπρούς και στους φίλους μου που χωρίς τη δική τους συναισθηματική υποστήριξη και υπομονή θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση αυτής της μεταπτυχιακής.

Περίληψη

Στις μέφες μας η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και οι απαιτήσεις που δημιουφγούνται από αυτή, επιβάλλουν τη βελτιστοποίηση τόσο των χημικών όσο και των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Στα πλαίσια επίτευξης του παφαπάνω στόχου η επιστήμη έχει επικεντφωθεί στις πφοσπάθειες ανάπτυξης υλικών με διαστάσεις στην πεφιοχή νανομέτφων.

Τα νανοσωματίδια αντιπροσωπεύουν το κομμάτι της ύλης στη μεταβατική περιοχή μεταξύ μορίων και άρτια δομημένων, εκτενών στερεών σωμάτων. Κατά συνέπεια, οι φυσικές και χημικές ιδιόητες των μεταλλικών επιφανειών είναι άμεσα εξαρτώμενες από το μέγεθος των νανοσωματιδίων και κλιμακώνονται από το επίπεδο μορίου σε επίπεδο στερεού (ημιαγωγικά υλικά).

Οι μεταλλικές επικαλύψεις με ενσωμάτωση νανο-υλικών, έχουν ποοσελκύσει το ενδιαφέοον τόσο σε ερευνητικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες και φαίνεται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τόσο για ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες, όπως υψηλή σκληρότητα και αντοχή σε τοιβή όσο και για ενισχυμένες ηλεκτοοοπτικές ιδιότητες όπως φωτοκαταλυτικές ιδιότητες.

Στην παφούσα μεταπτυχιακή εφγασία μελετήθηκε η παφασκευή σύνθετων ηλεκτφολυτικών επικαλύψεων μήτφας Ni-P με ενσωμάτωση νανοσωματιδίων εμποφικής τιτανία (TiO₂) με την εφαφμογή συνεχούς και παλμικού φεύματος σταθεφής φοφάς. Ακολούθησε η διεφεύνηση της επίδφασης των παφαμέτφων της ηλεκτφολυτικής διεφγασίας, και συγκεκφιμένα του είδους του εφαφμοζόμενου φεύματος (συνεχές ή παλμικό), της επιμέφους παφαμέτφου του παλμικού φεύματος, δηλαδή της συχνότητας του παλμού καθώς και της διεσπαφμένης ποσότητας TiO₂ στο λουτφό, πάνω στη σύσταση στη δομή και στη μοφφολογία των παραγόμενων σύνθετων επικαλύψεων με στόχο τη βελτίωση των ιδιοτήτων των νέων σύνθετων μεταλλικών επικαλύψεων.

Τα πειραματικά αποτελέσματα των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO2 εξάοτηση συναπόθεσης έδειξαν πως υπάρχει του ποσοστού νανοσωματιδίων TiO2 από τις επιβαλλόμενες συνθήκες ηλεκτρόλυσης. Συγκεκριμένα, αύξηση της ποσότητας της τιτανίας μέσα στο λουτρό και επιβολή παλμικού ρεύματος σε υψηλές συχνοτήτες παλμών, για τις ίδιες τιμές duty cycle και ταχύτητας περιστροφής της καθόδου, ευνοούν τη συναπόθεση του ενισχυτικού μέσου TiO2. Το υψηλότερο ποσοστό συναπόθεσης νανοσωματιδίων τιτανίας ίσο με ~5 wt.%, παρατηρήθηκε σε συνθήκες ν=100 Hz και 100g/L TiO2. Η μήτρα Ni-P των σύνθετων επικαλύψεων χαρακτηρίζεται ως άμορφη πριν τη θερμική κατεργασία τους, ενώ μετά τη θεομική κατεργασία στους 400°C κρυσταλλώνεται στις φάσεις Νι και Νi3P. Όσον αφορά στη μικροσκληρότητα των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2, διαπιστώθηκε ότι η επιβολή παλμικού ρεύματος επιφέρει αύξησή της και στις δύο περιπτώσεις ποσότητας ενισχυτικού μέσου στο λουτρό, 50 και 100g/L. Η θερμική κατεργασία έχει ευεργετική επίδραση στη μικροσκληρότητα των σύνθετων αποθεμάτων και στις δύο περιπτώσεις (50 και 100g/L TiO2) καθώς η μήτρα Ni-P κρυσταλλώνεται και Ni δημιουργούνται κούσταλλοι και Ni₃P με αποτέλεσμα η μικροσκληρότητα να λαμβάνει μέγιστη τιμή ~10.49 GPa -στην περίπτωση των 50g/L TiO₂ στο λουτοό, και ~10,00 GPa για ποσότητα TiO₂ στο λουτοό ίση με 100g/L.

Όσον αφορά στον συντελεστή τριβής ολίσθησης των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ η εφαρμογή παλμικού ρεύματος και η θερμική κατεργασία είχαν ως αποτέλεσμα την μείωσή του σε σχέση με αυτόν του συνεχούς ρεύματος, και στις δυο περιπτώσεις παρασκευής των σύνθετων αποθεμάτων (50 και 100g/L). Συγκρίνοντας επικαλύψεις μήτρας Ni και

απλών ηλεκτφολυτικών επικαλύψεων Ni-P καθώς και σύνθετων Ni-P/SiC αποθεμάτων πφοκύπτει ότι τη μεγαλύτεφη αντίσταση σε φθοφά εκτφιβής παφουσιάζουν οι επικαλύψεις Ni-P/TiO² που παφασκευάστηκαν σε συνθήκες παλμικού φεύματος και με 50g/L TiO² στο λουτφό. Και στις δυο πεφιπτώσεις παφασκευής των σύνθετων αποθεμάτων (50 και 100g/L) οι μηχανισμοί φθοφάς λογω τφιβής ολίσθησης που παφατηφούνται πφιν τη θεφμική τους κατεφγασία είναι οι : εκτφιβής, πφόσφυσης και οξείδωσης. Μετά την ανόπτησή τους στους 400°C ο μηχανισμός που κυφιαφχεί είναι ο μηχανισμός άφοσης.

Η φωτοκαταλυτική ικανότητα των σύνθετων μεταλλικών επικαλύψεων αξιολογήθηκε μέσω της χρήσης τους στην αποικοδόμηση του ούπου πορτοκαλόχρου του μεθυλίου (MO). Μελετήθηκαν οι κινητικές αποχοωματισμού ψευδοπρώτης τάξεως (σύμφωνα με το μοντέλο Langmuir - Hinselwood) του διαλύματος του αζωχρώματος - ρύπου, παρουσία διαφορετικών μεταλλικών επικαλύψεων. Αποδείχθηκε ότι οι μεταλλικές επικαλύψεις, οι οποίες παρασκευάστηκαν με εφαρμογή παλμικού ρεύματος σε v=100Hz και υπέστησαν θερμική κατεργασία, αποτελέσματα καλύτερα παρουσιάζουν τα όσον αφορά στη φωτοκαταλυτική δράση.

Abstract

Nowadays, the continuous technological development and demands necessitate the optimization of both chemical and mechanical properties. In order to achieve the above target, science has focused on developing nanomaterials.

Nanoparticles represent the piece of material at the unstable area between molecules and well-structured, extensive solid materials. Consequently, physical and chemical properties of the metal surfaces are directly dependent on the size of nanoparticles and escalated from the molecule scale to a solid material (semiconductor materials).

In the last two decades, metal coatings with embedded hard nanoparticles have attracted considerable interest in research and technological level and seem to satisfy the requirements for both enhanced mechanical properties, such as high hardness and abrasion resistance, and electro-optical properties such as photocatalytic properties.

In this thesis we studied the preparation of composite Ni-P matrix electrocoatings embedded with nano-structured commercial titanium dioxide (TiO₂) particles, by applying direct and pulse current conditions. Specifically, we studied the effect of parameters of the electrolytic process such as the type of the applied current (direct or pulse), the applied frequency of current pulses and the amount of the dispersed nano-TiO₂ in the bath, upon the composition, the structure and the morphology of the produced composite coatings aiming to the improvement of the metal coatings' properties.

The results have shown that the codeposition percentage of the TiO₂ nanoparticles is enhanced by increasing the TiO₂ load in the bath and applying high frequency current pulses. The highest incorporation TiO₂ percentage in the Ni-P matrix was 5 wt.%, that was achieved under pulse current conditions and high load of titania nanoparticles in the electrolytic

bath. The as deposited coatings were characterized by an amorphous structure, which was crystallized by thermal treatment at 400°C into the phases of Ni and Ni₃P. This thermal treatment led to increased microhardness values –almost double ones- in comparison to those observed for as deposited coatings.

The study of the tribological performance of the composite coatings realized by using an pin-on disc apparatus under dry conditions revealed that the lowest wear rate was observed for the coatings produced under pulse conditions (v=100 Hz) and 50g/L TiO₂ load.

The methyl orange (MO) pollutant was used in order to investigate the photocatalytic activity of Ni-P/TiO₂ composite coatings. The discoloration pseudo-first order kinetics (according to the Langmuir – Hinselwood model) of the solution of azo-dye was studied. It was experimentally demonstrated that the coatings prepared by applying pulse current conditions (100Hz) after thermal treatment exhibited the best photocatalytic action.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1º Ηλεκτρόλυση-Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις κράματος Ni-P

1.1 Ηλεκτρόλυση1
1.2 Νόμοι της ηλεκτρόλυσης2
1.3 Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση4
1.4Βασικές αρχές επιμετάλλωσης6
1.5 Εφαρμοζόμενη τάση κατά την ηλεκτρολυτική απόθεση8
1.6 Περιοδικά μεταβαλλόμενα/παλμικά ρεύματα10
1.7 Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις κράματος Ni-P16
1.7.1. Εισαγωγή16
1.7.2. Μέθοδοι παρασκευής17
1.7.3 Ηλεκτοοαπόθεση Ni-P19
1.7.3.1 Πλεονεκτήματα ηλεκτοοαπόθεσης Ni-P19
1.7.3.2 Μηχανισμοί ηλεκτφοαπόθεσης κφάματος Ni-P
1.7.3.3 Παράγοντες ηλεκτροαπόθεσης Ni-P23
1.7.3.4 Δομή κράματος Ni-P25
1.7.3.5 Λουτρά απόθεσης27
1.8 Θερμική κατεργασία κραμάτων Ni-P27
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1

Κεφάλαιο 2° Σύνθετες επικαλύψεις Ni-P

2.1 Σύνθετα Υλικά	32
2.2 Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μεταλλικής μήτρας	34
2.3 Ηλεκτρολυτική Συναπόθεση (electrolytic- codeposition)	35
2.3.1. Ορισμός	35
2.3.2. Παράμετροι που επηρεάζουν την ηλεκτρολυτική συναπόθεση	36

2.4 Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-P	42
2.4.1. Σύνθετες ηλεκτοολυτικές επικαλύψεις μήτοας Ni-P	43
2.4.1.1 Ενισχυτικά μέσα	43
2.4.1.2 Ιδιότητες	44
2.5 Χαρακτηριστικά Διοξειδίου του Τιτανίου (TiO ₂)	46
2.6 Στόχος της εργασίας	51
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 2	52

Κεφάλαιο 3ο Φωτοκατάλυση με TiO2

3.1 Γενική Περιγραφή Φωτοκαταλυτικής Δράσης5
3.2 Μηχανισμός Φωτοκατάλυσης Διοξειδίου του Τιτανίου5
3.3 Χημική Τροποποίηση Διοξειδίου του Τιτανίου - Φωτοκατάλυση6
3.4 Γενική προσέγγιση περιβαλλοντικών εφαρμογών μεταλλικών επικαλύψεων Ni-P/TiO2 7
3.5 Κινητική ανάλυση φωτοκαταλυτικής διεργασίας7
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 3

Κεφάλαιο 4°Πειραματική Διαδικασία

4.1 Πειραματική διάταξη παρασκευής επικαλύψεων	80
4.2 Συνθήκες παρασκευής σύνθετων επικαλύψεων μήτρας Ni-P	83
4.2.1 Ηλεκτρολυτικό λουτρό	83
4.2.2 Συνθήκες ηλεκτρόλυσης – πόλωσης ηλεκτρολυτικής κυψελίδας	85
4.2.3 Ενισχυτικό - Φωτοκαταλυτικό μέσο σύνθετων επικαλύψεων	85
4.2.3.1 Διοξείδιο του τιτανίου (TiO2)	85
4.2.4 Θερμική κατεργασία επικαλύψεων	86
4.3 Μέθοδοι χαρακτηρισμού δομής και μορφολογίας των επικαλύψεων	86
4.3.1 Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)	86

4.3.2 Ηλεκτφονική μικφοσκοπία σάφωσης (SEM) – Φασματοσκοπία	
διαχεόμενης ενέφγειας (EDS)	89
4.4 Μέθοδοι προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων	92
4.4.1 Μικοοσκληρότητα μεταλλικής επιφάνειας	92
4.4.2 Τριβολογική συμπεριφορά επικαλύψεων	95
4.4.2.1 Μέτοηση συντελεστή τοιβής ολίσθησης	95
4.4.2.2 Υπολογισμός συντελεστή όγκου φθοράς	97
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 4	99

Κεφάλαιο 5° Μελέτη σύστασης δομής – μο ρφολογίας των επικαλύψεων NiP/TiO2		
5.1 Διερεύνηση πειραματικών συνθηκών100		
5.2 Επίδραση πειραματικών παραμέτρων στο % w/w TiO ₂ 101		
5.2.1 Επίδραση παραμέτρων παλμικού ρεύματος στο ποσοστό συναπόθεσης TiO2102		
5.3 Δομή και μοφφολογία σύνθετων επικαλύψεων Ni-P /TiO2104		
5.3.1 Ποσοστό συναπόθεσης φωσφόρου στη μήτρα των αποθεμάτων Ni- P/TiO2		
5.3.2 Δομή των Ni-P/TiO2 επικαλύψεων106		
5.3.3 Μορφολογία Ni-P/TiO2 επικαλύψεων110		
5.4 Θερμική κατεργασία σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2113		
5.5 Συμπεράσματα117		
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 5		

Κεφάλαιο 6° Μηχανικές ιδιότητες σύνθετων επικαλύψεων μήτρας Ni-P

6.1	Μηχανικές ιδιότητες	.119
	6.1.1 Σκληφότητ <i>α</i>	.120
	6.1.2 Τοιβή	.121
	6.1.3 Φθοǫά (Wear)	.122

6.2 Μικροκληρότητα σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO ₂ 124
6.2.1 Μικροσκληρότητα πριν τη θερμική επεξεργασία των επικαλύψεων124
6.2.2 Επίδραση θερμικής κατεργασίας στη μικροσκληρότητα των επικαλύψεων Ni-P/TiO2126
6.3 Τριβολογική συμπεριφορά σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO ₂ 128
6.3.1 Συντελεστής τοιβής ολίσθησης128
6.3.1.1. Συντελεστής τοιβής ολίσθησης σύνθετων επικαλύψεων NiP/TiO2.128
6.3.2 Φθορά λόγω τριβής ολίσθησης132
6.3.3 Μηχανισμοί φθοράς τριβής λόγω ολίσθησης138
6.3.3.1 Μηχανισμοί Φθοράς επικαλύψεων NiP/TiO2138
6.4 Συμπεράσματα146
Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 6

Κεφάλαιο 7° Φωτοκατάλυση

7.1 Γενικές Πειραματικές Αρχές	150
7.2 Φωτοκατάλυση και αναλυτικός προσδιορισμός ρύπων	150
7.3 Φωτοκαταλυτική Αποικοδόμηση της Χρωστικής Πορτοκαλόχρουν του Μεθυλίου (Methyl Orange) με μεταλλικές επικαλύψεις Ni-P/TiO₂	152
7.3.1. Επιλογή του وύπου	152
7.4 Βελτιστοποίηση παραμέτρων παρασκευής μεταλλικών επικαλύψεων Ni-P/TiO2	156
7.5 Κινητική φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης Πορτοκαλόχρουν Μεθυλίου	157
7.6 Συμπεράσματα	160
Βιβλιογραφία κεφαλαίου 7	161

Κεφάλαιο 8° Συμπεράσματα – Προοπτικές

8.1 Συμπεράσματα	162
8.2 Προοπτικές	164

Κεφάλαιο 1º Ηλεκτρόλυση-Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις κράματος Ni-P

1.1 Ηλεκτρόλυση

Ηλεκτρόλυση ονομάζεται το φαινόμενο που δημιουργείται όταν ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από διάλυμα ή τήγμα ηλεκτρολύτη. Κατά το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης ο ηλεκτρολύτης διασπάται.

Η ηλεκτφόλυση πφαγματοποιείται σε ένα δοχείο που ονομάζεται *ηλεκτρολυτικό κελί*. Στο δοχείο αυτό τοποθετείται ο *ηλεκτρολύτης* (διάλυμα ή τήγμα ηλεκτφολύτη) και βυθίζονται δύο *ηλεκτρόδια* (από μέταλλο ή γφαφίτη) τα οποία ενώνονται με τους πόλους μιας ηλεκτφικής πηγής.

Στην μάζα του ηλεκτφολύτη υπάφχουν κατιόντα και ανιόντα ελεύθεφα να κινηθούν. Τα κατιόντα κινούνται πφος το αφνητικό ηλεκτφόδιο ενώ τα ανιόντα πφος το θετικό ηλεκτφόδιο.

Το αφνητικό ηλεκτφόδιο, που έλκει τα θετικά ιόντα (κατιόντα), ονομάζεται κάθοδος. Στην κάθοδο τα κατιόντα πφοσλαμβάνουν ηλεκτφόνια και εξουδετεφώνεται το φοφτίο τους. Συνεπώς από θετικά φοφτισμένα ιόντα μετατφέπονται σε ουδέτεφα άτομα με μηδενικό φοφτίο. Η μετατφοπή αυτή ονομάζεται αναγωγή. Αντίθετα, το θετικό ηλεκτφόδιο, που έλκει τα αφνητικά ιόντα (ανιόντα), ονομάζεται άνοδος. Στην άνοδο τα ανιόντα αποβάλλουν τα επιπλέον ηλεκτφόνια και αποφοφτίζονται και έτσι μετατφέπονται από αφνητικά φοφτισμένα ιόντα σε ουδέτεφα άτομα. Η μετατφοπή αυτή ονομάζεται οξείδωση.

Συνοψίζοντας, στην κάθοδο τα ιόντα ανάγονται (λαμβάνουν ηλεκτρόνια) ενώ στην άνοδο οξειδώνονται (δίνουν ηλεκτρόνια). Τα ουδέτερα άτομα που προκύπτουν είτε ενώνονται μεταξύ τους είτε αντιδρούν με το νερό ή και με τα ίδια τα ηλεκτρόδια. Σημειώνεται ότι οι

αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων ή στη γύρω περιοχή τους.

Εκτός από τα ιόντα γύρω από τα ηλεκτρόδια, υπάρχουν και μόρια νερού. Τα μόρια αυτά ανάγονται ή οξειδώνονται σύμφωνα με τις παρακάτω αντιδράσεις:

δύο μόρια νεφού προσλαμβάνουν δύο ηλεκτρόνια και παράγεται αέριο υδρογόνο και ιόντα υδροξυλίου και

$$H_2O + e^- → H^+ + \frac{1}{2}O_2$$
 οξείδωση (εξίσ. 1.2)

Ένα μόριο νερού αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και παράγει αέριο οξυγόνο και ιόντα υδρογόνου.

Τέλος, σημειώνεται ότι όταν τα ηλεκτρόδια δεν είναι κατασκευασμένα από αδρανές υλικό (π.χ. λευκόχρυσο) είναι πιθανό να οξειδωθεί η ίδια η άνοδος. Σε αυτού του είδους ηλεκτρολύσεων βασίζεται η ανοδίωση του αλουμινίου και ο ηλεκτρολυτικός καθαρισμός των μετάλλων [33].

1.2 Νόμοι της ηλεκτρόλυσης

Οι νόμοι που περιγράφουν το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης διατυπώθηκαν τον περασμένο αιώνα το 1833 από τον Faraday και είναι οι εξής δύο:

<u>1°ς Νόμος Faraday</u>

Η μάζα της ουσίας που αποτίθεται σε κάθε ηλεκτοόδιο είναι ανάλογη της ποσότητας του ηλεκτοισμού (ηλεκτοικού φοοτίου) που διέρχεται από τον ηλεκτοολυτικό αγωγό.

Το φοφτίο του ηλεκτφισμού είναι ίσο με το γινόμενο της έντασης του φεύματος και του χφόνου που το φεύμα αυτό διαφφέει το ηλεκτφικό κύκλωμα. Έτσι, όσο μεγαλύτεφη είναι η ένταση του φεύματος και όσο μεγαλύτεφος είναι ο χφόνος της ηλεκτφόλυσης τόσο μεγαλύτεφο είναι το ποσό των σωμάτων που αποτίθενται στην κάθοδο ή στην άνοδο. Επιπφόσθετα, για να αποτεθεί οφισμένη ποσότητα υλικού, όταν χφησιμοποιείται μεγάλη ένταση φεύματος χφειάζεται μικφότεφος χφόνος ενώ όταν η ένταση είναι μικφή ο χφόνος της ηλεκτφόλυσης αυξάνεται.

<u>2°ς Νόμος Faraday</u>

Οι μάζες των διαφορετικών ιόντων που αποτίθενται στα ηλεκτρόδια κατά τη δίοδο της ίδιας ποσότητας ηλεκτρισμού (ηλεκτρικού φορτίου) είναι χημικά ισοδύναμες, είναι δηλαδή ανάλογες προς τα γραμμοϊσοδύναμα (g-eq) αυτών.

Ένα γραμμοϊσοδύναμο (g-eq) ιόντος ισούται με το πηλίκο του mol αυτού δια του αριθμού των στοιχειωδών φορτίων αυτού. Δηλαδή, για ένα ιόν της μορφής Mⁿ⁺ έχουμε:

1ge-q=1mol/n.

Από τον νόμο αυτό ποοκύπτει η σχέση με την οποία υπολογίζονται οι ποσότητες των μετάλλων ή άλλων στοιχείων που ελευθερώνονται στα ηλεκτρόδια. Συνεπώς, η μάζα (m) του στοιχείου που αποτίθεται κατά την ηλεκτροαπόθεση είναι:

$$m = \left(\frac{A}{n}\right) \cdot \left(\frac{I \cdot t}{F}\right) \tag{exio. 1.3}$$

όπου, Α : ατομικό βάφος στοιχείου

n : φορτίο του ιόντος του στοιχείου

Ι: ένταση του ρεύματος (σε Α)

t :χρόνος της ηλεκτρόλυσης (σε sec)

F : σταθερά του Faraday ίση με 96.500 Cb [1]

1.3 Ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση

Ως επιμετάλλωση ή μεταλλική επικάλυψη χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μέθοδος επικάλυψης ή επιφανειακής επεξεργασίας, η οποία αποβλέπει στην απόθεση ενός στρώματος μετάλλου ή κράματος στην επιφάνεια κάποιου υλικού[1].

Έτσι, το επιφανειακό στρώμα συνιστά την επικάλυψη, ενώ το επικαλυπτόμενο υλικό χαρακτηρίζεται ως υπόστρωμα. Η επιφάνεια του υποστρώματος υποβάλλεται εν γένει σε επιμελημένη κατεργασία καθαρισμού και προετοιμασίας, πριν από τη διαδικασία της επιμετάλλωσης, η οποία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος του μετάλλου που πρόκειται να την επικαλύψει και την επιλεγόμενη μέθοδο επικάλυψης.

Έχει αναπτυχθεί μεγάλος αφιθμός μεθόδων μεταλλικών επικαλύψεων όπως είναι η επιμετάλλωση με χημικές μεθόδους, επιμετάλλωση με εμβάπτιση σε τήγματα μετάλλων, επιμετάλλωση υπό κενό. Η πιο διαδεδομένη, όμως, μέθοδος βιομηχανικής επιμετάλλωσης είναι η ηλεκτρολυτική επικάλυψη.

Λέγοντας ηλεκτρολυτική επικάλυψη εννοούμε την τεχνική με την οποία δημιουργείται ένα στρώμα από μέταλλα πάνω σε μία επιφάνεια, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος.[1]

Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες γίνεται η επικάλυψη είναι κυρίως μεταλλικές και ποιν χρησιμοποιηθούν έχουν υποστεί κατάλληλη κατεργασία. Η ηλεκτοολυτική επικάλυψη γνωστή και ως ηλεκτοοαπόθεση παρουσιάζει ευού φάσμα εφαρμογών και χρησιμοποιείται κυρίως:

- Στην μηχανολογία, για την ανάπτυξη επιφανειών μεγάλης σκληρότητας, ανθεκτικών σε φθορά λόγω τριβής οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική κ.ά.
- Στην χημική τεχνολογία, για την κατασκευή επικαλύψεων ανθεκτικών στη διάβρωση, πλακών ηλεκτρικών συσσωρευτών, κεραμικών υλικών υψηλής συνεκτικότητας, καταλυτών, κ.ά.
- Στη διακοσμητική,, με σκοπό τη βελτίωση της εμφάνισης μεταλλικών σκευών όπως σκεύη οικιακής χρήσης, προφυλακτήρες αυτοκινήτων, κοσμήματα μεταλλικά έπιπλά κ.ά.
- Στην ηλεκτοονική, για την κατασκευή αγωγών, ηλεκτοικών επαφών, αντιστάσεων και ηλεκτορμαγνητικών υλικών, φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοανιχνευτών, καθώς επίσης και υπεραγώγιμων υλικών. Αναφέρεται ακόμη και η χρήση διάφανων επικαλύψεων, ηλεκτρικά αγώγιμων σε οπτικό-ηλεκτρονικές διατάξεις και οι εφαρμογές μεταλλικών επικαλύψεων σε ηλεκτροθερμικές οθόνες και σε οθόνες υγρών κρυστάλλων.
- Στην οπτική, για την κατασκευή ανακλαστικών επιφανειών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διατάξεις ακτίνων λέιζερ (laser) ή στην αρχιτεκτονική για την κατασκευή κατόπτρων αυτοκινήτων καθώς και επιφανειών καθώς και επιφανειών που απορροφούν εκλεκτικά την ηλιακή ακτινοβολία.
- Σε διάφορους άλλους κλάδους της τεχνολογίας, όπως είναι η Τεχνολογία Τροφίμων και ειδικότερα η κονσερβοποιία και η

Πυρηνική Τεχνολογία για την επένδυση ή την επικάλυψη πυρηνικών καυσίμων. Τέλος, αναφέρονται και ορισμένες βιοϊατρικές χρήσεις που αφορούν στην κατασκευή καρδιακών βαλβίδων και διαφόρων τεχνητών οργάνων όπου απαιτείται βιοσυμβατότητα.

1.4 Βασικές αρχές επιμετάλλωσης

Μια τυπική απεικόνιση ηλεκτοολυτικής διάταξης απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα (βλ. Σχήμα 1.1). Μια τέτοια διάταξη αποτελείται από ένα δοχείο που καλείται «ηλεκτρολυτικό κελί», το οποίο περιέχει το κατάλληλο ηλεκτρολυτικό λουτρό (μπάνιο), ανάλογα κάθε φορά με το είδος της επιμετάλλωσης που πραγματοποιείται. Συνήθως, το λουτρό είναι υδατικό διάλυμα του άλατος του μετάλλου (Mⁿ⁺Aⁿ⁻) που πρόκειται να εναποτεθεί. Το άλας διίσταται στο νερό και βρίσκεται μέσα στην ηλεκτρολυτική κυψελίδα με τη μορφή θετικών ιόντων (κατιόντα) μετάλλου Mⁿ⁺ και αρνητικών ιόντων (ανιόντα) Aⁿ⁻ σύμφωνα με την αντίδραση διάστασης άλατος που ακολουθεί:

 $M^{n+}A^{n-} \rightarrow M^{n+} + A^{n-}$ (ηλεκτρολυτική διάσταση) (εξίσ. 1.4)



Σχήμα 1.1. Τυπική ηλεκτρολυτική κυψελίδα.

Μέσα στο ηλεκτφολυτικό λουτφό είναι βυθισμένα τα ηλεκτφόδια της ανόδου και της καθόδου. Το ηλεκτφόδιο της ανόδου είναι συνδεδεμένο με το θετικό πόλο και το ηλεκτφόδιο της καθόδου με τον αφνητικό πόλο μιας πηγής συνεχούς φεύματος. Η φοή του ηλεκτφικού φεύματος εξασφαλίζεται με τα ιόντα, τα οποία βφίσκονται μέσα στο διάλυμα.

Όταν εφαφμόζεται τάση στους πόλους της ηλεκτφολυτικής κυψελίδας τα ιόντα του μετάλλου Mⁿ⁺ μεταφέφονται μέσω του ηλεκτφολύτη πφος την κάθοδο. Εκεί πφοσλαμβάνουν (n) ηλεκτφόνια, και χάνουν το θετικό τους φοφτίο, δηλαδή ανάγονται και μετατφέπονται σε ουδέτεφα άτομα μετάλλου (M) σύμφωνα με την αντίδφαση που ακολουθεί:

$M^{n+} + ne^- \rightarrow M^0$ (ημιαντίδραση αναγωγής) (εξίσ. 1.5)

Κατ'επέκταση τα μεταλλικά άτομα αποτίθενται στη επιφάνεια της καθόδου και την επικαλύπτουν. Παράλληλα, τα ανιόντα Aⁿ⁺ του άλατος κινούνται με την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου προς την άνοδο. Εκεί, αποβάλλουν τα (n) ηλεκτρόνια που τους περισσεύουν και αποφορτίζονται, δηλαδή οξειδώνονται και μετατρέπονται σε ουδέτερα άτομα (Α) σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:

$$A^{n-}$$
 + ne⁻ → A^0 (ημιαντίδραση οξείδωσης) (εξίσ. 1.6)

Αν στις ηλεκτφολυτικές επιμεταλλώσεις η άνοδος αποτελείται από το μέταλλο (Μ), το οποίο πφόκειται να αποτεθεί, είναι δυνατόν εκτός από την οξείδωση των ανιόντων Αⁿ⁻ να εκδηλωθεί και οξείδωση του μετάλλου (Μ) της ανόδου. Το μέταλλο μετατφέπεται σε κατιόντα Mⁿ⁺ και εισέφχεται στο ηλεκτφολυτικό λουτφό, δηλαδή το μέταλλο διαλυτοποιείται σύμφωνα με την αντίδφαση:

$$M \rightarrow M^{n+} + ne^{-}$$
 ($\epsilon \xi i \sigma. 1.7$)

Κατά συνέπεια, σε ορισμένο αριθμό ιόντων μετάλλου Mⁿ⁺ που αποφορτίζονται και αποτίθενται στην κάθοδο, αντιστοιχεί ίσος αριθμός ιόντων μετάλλου (Μ) που οξειδώνονται στην άνοδο, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση των ιόντων του μετάλλου στο λουτρό να παραμένει σταθερή στη επιθυμητή κάθε φορά τιμή [1,2, 3, 4].

1.5 Εφαρμοζόμενη τάση κατά την ηλεκτρολυτική απόθεση

Για να γίνει ηλεκτοόλυση ποέπει στους πόλους του ηλεκτοολυτικού κελιού να εφαομοστεί ηλεκτοική τάση (V). Η τάση αυτή, ποοκειμένου να εκδηλωθεί το φαινόμενο της ηλεκτοόλυσης, είναι απαραίτητο να είναι ίση ή μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή που λέγεται τάση απόθεσης (Ε). Συνεπώς, το μέταλλο δε θα αποτεθεί αν η τάση της πηγής είναι μικοότερη από την τάση απόθεσης. Η τάση απόθεσης είναι διαφορετική για κάθε ηλεκτοοχημική αντίδραση.

Κατά την εκδήλωση του φαινόμενου της ηλεκτοόλυσης, οι μικοές ποσότητες των υλικών που αοχίζουν να αποτίθενται στα δύο ηλεκτοόδια δημιουογούν γαλβανικό στοιχείο, το οποίο εμφανίζει δυναμικό αντίθετο από την εξωτεοικά εφαομοζόμενη τάση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πόλωση των ηλεκτοοδίων. Τότε για να αρχίσει η ηλεκτοόλυση είναι αναγκαίο η τάση που εφαομόζεται να είναι μεγαλύτεοη από το δυναμικό του γαλβανικού στοιχείου.

Για παφάδειγμα, όταν γίνεται ηλεκτφόλυση διαλύματος υδφοχλωφίου (HCI), όπου στο λουτφό υπάφχουν κατιόντα H⁺ και ανιόντα CI⁻, στα ηλεκτφόδια παφατηφούνται φυσαλίδες H₂ και CI₂. Τα αέφια H₂ και CI₂ δημιουφγούν τότε γαλβανικό στοιχείο, που έχει δυναμικό ίσο με 1,36 Volt σε κανονικές συνθήκες. Η τιμή αυτή είναι η τάση διάσπασης (E) του υδφοχλωφικού οξέος ή αλλιώς η τάση απόθεσης των αεφίων υδφογόνου H₂ και χλωφίου CI₂. Μόλις το φεύμα αφχίσει να διαφφέει την κυψελίδα, παφατηφείται πτώση της τάσης που ασκείται στους πόλους της πηγής. Η πτώση αυτή οφείλεται στις εξής αιτίες:

- Στην πόλωση των ηλεκτοοδίων, η ποία δημιουογείται λόγω της αύξησης της συγκέντοωσης των ιόντων γύοω από αυτά. Για να πεοιοοιστεί η πόλωση, ποέπει να μειωθεί η πυκνότητα του οεύματος ή να αυξηθεί η θεομοκοασία του λουτοού. Επιπλέον, η πόλωση εξομαλύνεται και με την ανάδευση του λουτού, αφού με αυτόν τον τοόπο μειώνονται τα ιόντα που συγκεντοώνονται γύοω από τα ηλεκτοόδια.
- Στην ωμική πτώση της τάσης (I·R), που εμφανίζεται κατά τη δημιουργία αγώγιμων στρωμάτων στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων.

Για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρόλυση, πρέπει η τάση που εμφανίζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου να είναι τουλάχιστον ίση με:

όπου, Ε: η τάση απόθεσης ή διάσπασης

- Ι: η ένταση του φεύματος
- R : η αντίσταση του ηλεκτρικού λουτρού

Η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρητική τάση απόθεσης (Ε), για συγκεκριμένη αντίδραση, και στην τάση που εφαρμόζεται στην πραγματικότητα ονομάζεται υπέρταση. Η τιμή της εξαρτάται από το υλικό που είναι κατασκευασμένα τα ηλεκτρόδια και από την πυκνότητα του ρεύματος. Όταν στα ηλεκτρόδια ελευθερώνονται αέριες ενώσεις, η υπέρταση έχει μεγαλύτερη τιμή [5].

1.6 Περιοδικά μεταβαλλόμενα/παλμικά ρεύματα

Για πολλά χρόνια η βασική τεχνική βιομηχανικής επιμετάλλωσης για την ηλεκτρολυτική παρασκευή αποθεμάτων, ήταν η χρήση συνεχούς ρεύματος (direct current – D.C). Η ηλεκτροαπόθεση των μετάλλων με χρήση συνεχούς ρεύματος πραγματοποιείται είτε με την επιβολή μιας σταθερής τιμής καθοδικού δυναμικού (ποτενσιοστατικές συνθήκες) είτε με την επιβολή σταθερής τιμής έντασης ρεύματος (γαλβανοστατικές συνθήκες) [5].

Το φαινόμενο της ηλεκτοοαπόθεσης σε ποτενσιοστατικές συνθήκες εφαομόστηκε ευοέως από πολλούς εοευνητές. Κύοιος παράγοντας για τον καθοοισμό των ιδιοτήτων των αποθεμάτων αποτελεί το εφαομοσμένο δυναμικό. Ο έλεγχος, όμως, και ο ποοσδιοοισμός του δυναμικού αποδεικνύεται αρκετά δύσκολος λόγω της ωμικής πτώσης του δυναμικού, που οφείλεται στην αντίσταση που εμφανίζει το ηλεκτοολυτικό λουτοό. Για χαμηλές τιμές της πυκνότητας του φεύματος η ωμική αντίσταση θεωφείται αμελητέα, ενώ για υψηλές τιμές της πυκνότητας του φεύματος η ωμική αντίσταση πφοσεγγίζει την τιμή του μετφούμενου δυναμικού. Έτσι ο ακφιβής πφοσδιοφισμός της ωμικής αντίστασης παφουσιάζεται εξαιφετικά δύσκολος.

Κατά συνέπεια, οι πεφισσότεφοι εφευνητές στφάφηκαν στην μελέτη του φαινομένου της ηλεκτφοαπόθεσης σε γαλβανοστατικές συνθήκες. Σε αυτήν την πεφίπτωση κύφια παφάμετφος αποτελεί η πυκνότητα η πυκνότητα του ρεύματος απόθεσης (J) (current density – σε A/dm² ή A/cm²), η οποία εκφφάζει τον φυθμό κφυσταλλικής ανάπτυξης του μεταλλικού αποθέματος.

Η συνεχής προσπάθεια των εφευνητών για τον έλεγχο και τη βελτίωση των ιδιοτήτων των αποθεμάτων οδήγησε στην εφαφμογή διάφοφων τύπων φευμάτων, πεφιοδικά μεταβαλλόμενα με τον χφόνο. Το 1837 ο A de la Rive, παφατήφησε ότι το μεταβαλλόμενο φεύμα παφεμβαίνει στα ηλεκτφοχημικά φαινόμενα, δηλαδή παφατηφείσαι αύξηση στη διάβφωση των μετάλλων, ακόμα και των ευγενών, σε συνθήκες εναλλασσόμενου φεύματος. Επιπφόσθετα, ο ίδιος εφευνητής διαπίστωσε ότι η συχνότητα του φεύματος επιδφά στα φαινόμενα αυτά και παφατηφείσαι μείωση της πόλωσης των ηλεκτφοδίων.

Σε αυτό το σημείο, σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η επιβολή παλμικών ρευμάτων εισάγει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι της εφαρμογής συνεχούς ρεύματος:

 Υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης πολύ υψηλών στιγμιαίων πυκνοτήτων ρεύματος, άρα και πολύ αρνητικών δυναμικών γεγονός που οδηγεί στην εφαρμογή υψηλότερων μέσων πυκνοτήτων ρεύματος από τις συνήθεις τιμές για συνεχές ρεύμα.
 Έτσι, παρέχονται υψηλότερα ποσά ενέργειας για τον σχηματισμό

νέων πυρήνων, συνεπώς αυξάνεται ο ρυθμός απόθεσης του μετάλλου. [6, 7]

2. Το παλμικό φεύμα επηφεάζει το φαινόμενο φόφησης-εκφόφησης στην πεφιοχή του καθολύτη αλλά και ανακφυστάλλωσης του αποθέματος. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα παφασκευής αποθεμάτων με βελτιωμένες ιδιότητες μεταβάλλοντας τις συνθήκες ηλεκτφόλυσης και η δυνατότητα παφασκευής διάφοφων άλλων υλικών που δεν θα μποφούσαν να παφασκευασθούν με απλές συνθήκες ηλεκτφόλυσης [8].

Οι διάφοροι τύποι ρευμάτων περιοδικά μεταβαλλόμενων με το χρόνο (τετραγωνικού, τριγωνικού ή ημιτονοειδούς παλμού) που εφαρμόζονται στις ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις παρουσιάζεται στο σχήμα 1.2 και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: (α) τα μονοπολικά παλμικά **ρεύματα,** όπου οι επιβαλλόμενοι παλμοί είναι μιας και μόνο κατεύθυνσης (καθοδικοί) και (β) τα διπολικά παλμικά **ρεύματα,** όπου οι επιβαλλόμενοι παλμοί αλλάζουν περιοδικά κατεύθυνση (καθοδικοί και ανοδικοί).



Σχήμα 1.2. Διάφοροι τύποι ρευμάτων περιοδικά μεταβαλλόμενων με το χρόνο

Με την επιβολή τέτοιων φευμάτων παφατηφείται ουσιαστική ουσιαστική αλλαγή στη σύσταση του λουτφού, στη διεπιφάνεια καθόδουηλεκτφολύτη -γνωστό και ως καθολύτης- καθώς και φιζική μεταβολή στη δομή και στις ιδιότητες των αποθεμάτων, εν συγκφίσει με αυτές που επικφατούν σε συνθήκες συνεχούς φεύματος. Συνεπώς, η επιμετάλλωση με χφήση παλμικού φεύματος αποτελεί πφόσφοφο πεδίο έφευνας για την παφασκευή νέων υλικών σύνθετων και μη, τα οποία είναι δύσκολο να παφασκευασθούν με τη χφήση απλού συνεχούς φεύματος.

• Παλμικό <u>φεύμα</u> σταθε<u>φής</u> φάσης (Pulse Current- P.C)

Η δεύτεφη κατηγορία, όπου κυρίως έχουν επικεντρωθεί οι ερευνητές, αναφέρεται στο παλμικό ρεύμα σταθερής φοράς (Pulse Current), όπου οι παλμοί είναι απλοί, τετράγωνοι και καθοδικοί (βλ. Σχήμα 1.4).



Σχήμα 1.4. Μεταβολή της έντασης του φεύματος με το χφόνο κατά την επιβολή τετφαγωνικών παλμών σταθεφής φοφάς.

Η εφαφμογή του φεύματος σταθεφής φοφάς εισάγει τφεις επιπλέον παφαμέτφους, οι οποίες αντικαθιστούν τη βασική παφάμετφο της πυκνότητας του συνεχούς φεύματος. Οι παφάμετφοι αυτές μεταβάλλονται κατά ανεξάφτητο τφόπο μεταξύ τους και μποφούν να επηφεάσουν τον μηχανισμό της ηλεκτφολυτικής επιμετάλλωσης. Οι νέες παφάμετφοι είναι εξής:

- + Η πυκνότητα του φεύματος (Jp) κατά την εφαφμογή του παλμού
- Ο χρόνος επιβολής του παλμού (Ton) κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται η απόθεση και
- Ο χρόνος (T_{off}) κατά τη διάρκεια του οποίου μηδενίζεται το ρεύμα απόθεσης

Από τις παραπάνω παραμέτρους προκύπτουν ακόμα τρία μεγέθη πρακτικού ενδιαφέροντος:

- + Η περίοδος του παλμού Θ = Ton + Toff και κατ'επέκταση η συχνότητα εφαρμογής του παλμού v = 1/θ.
- + Η μέση πυκνότητα του $Qεύματος: J_m = J_p \cdot T_{on} / (T_{on} + T_{off}) και$
- Το επί τις εκατό ποσοστό του χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου η ηλεκτρολυτική κυψελίδα διαρρέεται από ρεύμα, γνωστό ως duty cycle (d.c) ή κύκλος φόρτισης – εκφόρτισης:

 $d.c = T_{on} / (T_{on} + T_{off}) \cdot 100$ [9]

Εφευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι υψηλές συχνότητες παλμών ευνοούν την παφασκευή αποθεμάτων με βελτιωμένες ιδιότητες [34]. Η επιλογή της συχνότητας, όμως, απαιτεί ιδιαίτεφη πφοσοχή, ώστε μεγάλη αύξησή της να μην οδηγήσει σε πφοσομοίωση των συνθηκών επιβολής συνεχών φευμάτων.

Συνοψίζοντας, γενικά, η χρήση παλμικού ρεύματος στην ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αποθέματα με καλά οργανωμένη δομή, περισσότερο συμπαγή και λιγότερο πορώδη σε σχέση με αυτά που παράγονται σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος. Ακόμα, τα αποθέματα εμφανίζονται λεία και εύκαμπτα, γεγονός που αποδίδεται στον περιορισμό αταξιών της δομής κατά την κρυσταλλικής τους ανάπτυξη [10].

1.7 Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις κράματος Ni-P

1.7.1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια το κράμα νικελίου-φωσφόρου (Ni-P) βρίσκεται στο κέντρο των επιστημονικών και τεχνολογικών μελετών. Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει σημαντικές μηχανικές, ηλεκτρονικές, μαγνητικές και άλλες ιδιότητες. Τα κράματα Ni-P επιδεικνύουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές σκληρότητας, μεγάλη αντοχή σε διάβρωση καθώς και υψηλή αντοχή στην τριβή. Επιπλέον, τα κράματα Ni-P βρίσκουν εφαρμογή ως ηλεκτρόδια παραγωγής υδρογόνου ενώ λόγω των φερρομαγνητικών ιδιοτήτων τους χρησιμοποιούνται με τη μορφή λεπτών επιστρώσεων σε ηλεκτρονικές διατάξεις [6-13].

Η δομή του κράματος Ni-P παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ανάλογα με το ποσοστό φωσφόρου (P) μπορεί να χαρακτηριστεί κρυσταλλικό, νανοκρυσταλλικό ή άμορφο. Η παρασκευή του κράματος Ni-P γίνεται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες θα αναπτυχθούν αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους με ιδιαίτερη έμφαση στη μέθοδο της ηλεκτρολυτικής απόθεση. Επιπλέον, θα αναλυθούν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόθεση, τη δομή και τις ιδιότητες του κράματος.

1.7.2. Μέθοδοι παρασκευής

α) Χημική α πόθεση (electroless deposition)

Ο όφος μη ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση (electroless deposition, EN) αποδίδεται κατά κύριο λόγο στους A. Brenner και G. Riddell, οι οποίοι τον χρησιμοποίησαν προκειμένου να περιγράψουν μια μέθοδο επικάλυψης σε μέταλλα, με κράματα νικελίου, χωρίς τη χρήση ρεύματος προερχόμενο από εξωτερική πηγή. Κατά τη μη ηλεκτρολυτική απόθεση μεταλλικά ανάγονται συνεχώς στην επιφάνεια ενός ιόντα καταλυτικού υποστρώματος, το οποίο έχει εμβαπτιστεί σε κατάλληλο διάλυμα. Το παραγόμενο απόθεμα καταλύει την αντίδραση αναγωγής και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται και ο όρος αυτοκαταλυώμενη αντίδραση (autocatalytic reaction). Τέλος, αναφέρεται και ο όρος «χημικό νικέλιο» κυρίως στη βιομηχανία επιμεταλλώσεων. Το κύριο πλεονέκτημα της αυτοκαταλυώμενης απόθεσης είναι η διατήρηση της ομοιομορφίας του αποθέματος σε σύσταση, ομοιομορφία η οποία δεν επηρεάζεται από τις ανομοιογένειες του υποστρώματος. Στα μειονεκτήματα της μη ηλεκτρολυτικής απόθεσης συγκαταλέγονται το υψηλό κόστος των αναγωγικών παραγόντων, η υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας των λουτρών, ο δύσκολος έλεγχος των παραμέτρων και ο μικρός χρόνος ζωής του λουτρού [14-18].

β) Απόθεση ατμών

Η απόθεση ατμών χρησιμοποιείται κυρίως για την δημιουργία άμορφων κραμάτων Ni-P. Η μέθοδος όμως αυτή εμφανίζει κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή της, οι οποίες οφείλονται στην υψηλότερη τάση ατμών του φωσφόρου σε σχέση με το νικέλιο καθώς και στη μεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν τα σημεία τήξης του φωσφόρου και του νικελίου [19].

γ) Ηλεκτοολυτική απόθεση

Ο όφος ηλεκτρολυτική απόθεση αναφέφεται στην τεχνική σύμφωνα με την οποία ένα στφώμα κφάματος νικελίου-φωσφόφου αποτίθεται πάνω σε μία επιφάνεια με τη βοήθεια του φαινόμενου της ηλεκτφόλυσης. Η ηλεκτφολυτική απόθεση (αλλιώς ηλεκτφοαπόθεση) υπεφτεφεί έναντι των άλλων μεθόδων λόγω της απλότητας στην εφαφμογή της και στη δυνατότητά της να παφέχει συμπαγείς επικαλύψεις σε αντίθεση με τις άλλες πφοαναφεφθείσες μεθόδους. Επιπλέον, η μέθοδος της ηλεκτφοαπόθεσης μποφεί να παφάγει αποθέματα ανεξαφτήτου σχήματος και μποφεί να αποθέσει πάνω σε πλήθος υποστφωμάτων [20, 21].

1.7.3 Ηλεκτοοαπόθεση Ni-P

1.7.3.1. Πλεονεκτήματα ηλεκτροαπόθεσης Ni-P

Η παφασκευή κφαμάτων Ni-P με τη μέθοδο της ηλεκτφοαπόθεσης, όπως αναφέφαμε και πφοηγουμένως, υπεφτεφεί έναντι των άλλων μεθόδων και συνοπτικά τα σημαντικότεφα πλεονεκτήματα της ηλεκτφοαπόθεσης είναι τα εξής :

- Η απλή πειραματική διάταξη
- Είναι πιο οικονομική μέθοδος
- Είναι κατάλληλη για παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα
- Είναι δυνατή η απόθεση πάνω σε ευού φάσμα επιφανειών
- Χρησιμοποιείται για διάφορα συστήματα κραμάτων και με αρκετά χαμηλό κόστος
- Είναι εύκολο να αποκτηθεί ένα μη κουσταλλικό απόθεμα
- ✓ Η δυνατότητα ελέγχου της σύνθεσης του κράματος όπως και ότι επιτυγχάνονται αποθέματα με ποικίλες συστάσεις που άλλες μέθοδοι δεν παρέχουν
- Η δυνατότητα να σχηματίζει επικαλύψεις με φάσεις που δεν
 βρίσκονται σε ισορροπία
- Το ηλεκτφολυτικό λουτφό είναι σταθεφό, έχει μεγάλη διάφκεια ζωής
 και συνεπώς δε χρειάζεται συνεχώς ανανέωση
- ✓ Παρέχει παχύ στρώμα αποθέματος σε μικρό χρονικό διάστημα
 [20,21].

1.7.3.2. Μηχανισμοί ηλεκτροαπόθεσης κράματος Ni-P

Οι μηχανισμοί που έχουν προταθεί για την ηλεκτροαπόθεση του κράματος νικελίου-φωσφόρου είναι οι εξής:

- ο άμεσος μηχανισμός (direct)
- ο έμμεσος μηχανισμός (indirect)

Οι ανοδικές και καθοδικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται βάση των δύο μηχανισμών παρατίθενται στον πίνακα 1.1. [34]

<u>Άμεσος μηχανισμός</u>

Ποώτος ο Brenner ποότεινε τον άμεσο μηχανισμό, στον οποίο το οξύ που υπάοχει στο λουτοό, όπως το φωσφορώδες οξύ (H₃PO₃), καταναλώνεται πλήρως σε ένα μόνο στάδιο (αντίδραση 1) σε στοιχειακό φώσφορο P⁰. Η ηλεκτροαπόθεση των μετάλλων, που ανήκουν στην ομάδα του σιδήρου, με το φώσφορο έχει χαρακτηριστεί ως παρακινούμενη συναπόθεση, αφού ο φώσφορος από μόνος του δεν μπορεί να αποτεθεί από υδατικά διαλύματα αλάτων του, αλλά σαν κράμα μέσω διαλυμάτων που περιέχουν ταυτόχρονα και ιόντα της ομάδας του σιδήρου. Επιπλέον, στην απόθεση του φωσφόρου βοηθά και η πόλωση που εμφανίζεται κατά απόθεση του νικελίου.

Επιπρόσθετα στον άμεσο μηχανισμό το φωσφορώδες οξύ (H₃PO₃) είναι δυνατόν να μετατραπεί μερικώς σε υποφωσφορωδες οξύ (H₃PO₂), (εξίσωση 16), και στη συνέχεια μετατρέπεται σε φώσφορο P⁰. Εναλλακτικά, το υποφωσφορώδες οξύ μπορεί να οξειδωθεί στην άνοδο με
μία ομοιογενή αντίδραση (αντίδραση 17), μειώνοντας έτσι την απόδοση της διαδικασίας.

Έμμεσος μηχανισμός

Τον έμμεσο μηχανισμό για την ηλεκτφοαπόθεση του κφάματος νικελίου-φωσφόφου πφότειναν αφχικά οι Vyacheslavov και Fedotev και στη συνέχεια ο Ratzer.

Στον έμμεσο μηχανισμό η πηγή φωσφόρου ανάγεται αρχικά σε φωσφίνη (PH₃) (αντίδραση 6) και στη συνέχεια ακολουθεί μια οξειδοαναγωγική χημική αντίδραση με τα ιόντα Ni²⁺ για να παραχθούν νικέλιο (Ni) και φώσφορος (P) στη στοιχειακή τους μορφή (αντίδραση 7). Ο σχηματισμός της φωσφίνης πριν την απόθεση οδηγεί σε πτώση της απόδοσης του ρεύματος.

Η απόδοση του φεύματος παίζει σημαντικό φόλο στη δομή του κφάματος. Έτσι, με αύξηση της απόδοσης του φεύματος είναι δυνατή η μετάβαση από μια άμοφφη δομή υψηλής πεφιεκτικότητας σε φώσφοφο, σε μια κφυσταλλική δομή χαμηλότεφης πεφιεκτικότητας σε φώσφοφο και μποφεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή στον μηχανισμό ηλεκτφοαπόθεσης του κφάματος Ni-P. Τελικά, πφέπει να σημειωθεί ότι ο άμεσος μηχανισμός (υψηλής απόδοσης φεύματος) οδηγεί σε κφυσταλλικές αποθέσεις, ενώ ο έμμεσος μηχανισμός (χαμηλής απόδοσης φεύματος) οδηγεί σε κφυσταλλικών [19,22].

Πίνακας 1.1. Αντιδράσεις σχετικές με την απορρόφηση του P στο κράμα Ni-P [23].

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ρ ΣΤΟ ΚΡΑΜΑ Νι-Ρ		
<u>Ευθύς μηχανισμός</u>		
$H_{3}PO_{3} + 3H^{+} + 3e^{-} \rightarrow P(s) + 3H_{2}O$	(1)	
Ανοδικός αντιδράσεις (και για τους 2 μηχανισμούς)		
$2Cl- \rightarrow Cl_2 + 2e-$	(2)	
$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	(3)	
$H_{3}PO_{3} + H_{2}O \rightarrow H_{3}PO_{4} + 2H^{+} + 2e^{-}$	(4)	
Αντιδράσεις στην κάθοδο (μη-ευθύς μηχανισμός)		
$6H^+ + 6e^- \rightarrow 6H^0$	(5)	
$H_{3}PO_{3} + 6H^{0} \rightarrow PH_{3} + 3H_{2}O$	(6)	
$2PH_3 + 3Ni^{2+} \rightarrow 3Ni^0 + 2P^0 + 6H^+$	(7)	
$3Ni^{2+} + 2H_3PO_3 + 6H^+ + 12e^- \rightarrow 3Ni^0 + 2P^0 + 6H_2O$	(8)	
Αντιδράσεις στην κάθοδο (ευθύς μηχανισμός)		
$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni^0$	(9)	
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	(10)	
Ηλεκτφοχημικές αντιδφάσεις των συστατικών του λουτφού		
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	(11)	
$2SO^{2-4} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow S_2O^{2-6} + 2H_2O$	(12)	
Ni ²⁺ + 2e ⁻ →Ni	(13)	
$H_3PO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_3PO_3 + H_2O$	(14)	
$H_3PO_3 + 3H^+ + 3e^- \rightarrow P + 3H_2O$	(15)	
$H_{3}PO_{3} + 2H^{+} + 2e^{-} \rightarrow H_{3}PO_{2} + H_{2}O$	(16)	
$H_{3}PO_{2} + H^{+} + e^{-} \rightarrow P + 2H_{2}O$	(17)	
$P + 3H_2O + 2e^- \rightarrow PH_3 + 3OH^-$	(18)	
$SO^{2-4} + H_2O + 2e^{-} \rightarrow HSO^{2-3} + 2OH^{-}$	(19)	
$PO^{3}-4 + 2H_2O + 2e^- \rightarrow HPO^{2}-3 + 3OH^-$	(20)	
$HPO^{2} + 2H_2O + 3e^- \rightarrow P + 5OH^-$	(21)	
$SO^{2-4} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow H_2SO_3 + H_2O$	(22)	
$H_2SO_3 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow S + 3H_2O$	(23)	
$Cl^2 + 2e^- \rightarrow Cl^-$	(24)	

1.7.3.3 Παράγοντες ηλεκτροαπόθεσης Ni-P

Η διαδικασία ηλεκτφοαπόθεσης του κφάματος Ni-P επηφεάζεται σημαντικά από τις πειφαματικές συνθήκες που επικφατούν. Οι σημαντικότεφες από αυτές αναλύονται παφακάτω και είναι: η θεφμοκφασία, το pH, η πεφιεκτικότητα φωσφόφου στο λουτφό και το δυναμικό απόθεσης.

Θεομοκοασία

Η θεφμοκφασία είναι από τους παφάγοντες που παίζουν το σπουδαιότεφο στην απόθεση του νικελίου-φωσφόφου. Έχει βφεθεί ότι η απόδοση του φεύματος εξαφτάται από τη θεφμοκφασία. Συνεπώς, με αύξηση της θεφμοκφασίας επιτυγχάνονται μεγαλύτεφες απόδοσης φεύματος. Επιπλέον, σε υψηλότεφες θεφμοκφασίες η άμοφφη δομή του αποθέματος κφυσταλλοποίειται. Τέλος, παφατηφείται ότι όσο αυξάνεται η θεφμοκφασία στο λουτφό τόσο λιγότεφος φώσφοφος αποτίθεται.[19]

• <u>pH</u>

Το pH επηφεάζει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτφοαπόθεση του κφάματος Ni-P, καθώς μποφεί να επηφεάσει τη σύστασή του. Έτσι σε χαμηλές τιμές pH, όπου υπάφχει έντονη παφαγωγή υδφογόνου με συνολική απόδοση φεύματος, παφάγονται επικαλύψεις με μεγάλο ποσοστό φωσφόφου. Η παφαγωγή του υδφογόνου, όπως πφοαναφέφθηκε, οδηγεί σε τοπική μείωση της συγκέντφωσης των Ni²⁺ στην πεφιοχή του καταλύτη με αποτέλεσμα να ευνοείται η απόθεση του φωσφόφου. Αντίθετα, όταν το pH παίφνει μεγαλύτεφες τιμές, η παφαγωγή παύει να είναι τόσο έντονη, οδηγώντας σε επικαλύψεις με μειωμένο ποσοστό φωσφόφου [22,24]. Ως

σταθεφοποιητής του pH χφησιμοποιείται είτε το βοφικό οξύ είτε το φωσφοφικό οξύ, καθώς με σταθεφό pH επιτυγχάνεται πιο σταθεφή ποιότητα κφάματος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφεφθεί ότι στην πεφιοχή του καταλύτη η τιμή του pH μποφεί να απέχει πολύ από αυτή του κύφιου διαλύματος, εξαιτίας κακής ανάδευσης ή από αναγωγή του υδφογόνου, οδηγώντας έτσι σε σχηματισμό στφωματικών αποθέσεων [19].

• Περιεκτικότητα φωσφόρου στο λουτρό

Η κουσταλλογοαφική δομή του κοάματος Ni-P επηρεάζεται από την ποσότητα του φωσφόρου στο κοάμα ανεξάρτητα από τις χοησιμοποιούμενες παραμέτρους απόθεσης. Η παρουσία του φωσφόρου μέσα στο μέταλλο του νικελίου επηρεάζει την διαδικασία της ηλεκτροκουστάλλωσης. Καθώς η ποσότητα του φωσφόρου μέσα στο απόθεμα αυξάνεται το μέσο μέγεθος του κουστάλλου μειώνεται. Η αλλαγή από μία κουσταλλική σε πλήρη άμορφη δομή λαμβάνει χώρα μεταξύ 11,6 – 13,1 P %.

Το ποσοστό φωσφόρου μέσα στο λουτρό αυξάνεται, όπως είναι λογικό, όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα της πηγής του φωσφόρου. Επιπλέον, ανάλογα με τη πηγή νικελίου μπορεί να παρατηρηθεί διαφορετική αύξηση του φωσφόρου στο απόθεμα για την ίδια αύξηση της συγκέντρωσης πηγής φωσφόρου. Έτσι, έχε βρεθεί ότι σε λουτρά με θειϊκό νικέλιο λαμβάνει χώρα μεγαλύτερη αύξηση από ότι σε λουτρά με διαφορετική πηγή νικελίου [24-27].

Δυναμικό απόθεσης

Σε χαμηλά δυναμικά είναι δυνατόν να παφαχθούν επικαλύψεις με υψηλότεφα ποσοστά φωσφόφου. Όπως αναφέφθηκε και σε πφοηγούμενη παφάγφαφο, η ηλεκτφοαπόθεση του κφάματος Ni-P εξαφτάται από την παφαγωγή υδφογόνου, που και είναι ο κύφιος λόγος μείωσης της απόδοσης φεύματος της απόθεσης. Σε υψηλά καθοδικά φεύματα η απόθεση του νικελίου ευνοείται σε σχέση με του φωσφόφου. Συνεπώς είναι φανεφό ότι η συναπόθεση Ni-P γίνεται με χαμηλότεφους φυθμούς απόθεσης για τον φώσφοφο. Γενικά, η συναπόθεση του φωσφόφου με το νικέλιο επιτυγχάνεται σε όλες τις τιμές δυναμικού, στις οποίες αποτίθεται το νικέλιο.

Όμως, σε χαμηλά δυναμικά ο ουθμός συναπόθεσης του φωσφόοου είναι μεγαλύτεοος από αυτόν του νικελίου, ενώ το αντίθετο σε συμβαίνει σε υψηλά δυναμικά. Συνεπώς, για να ληφθεί ένα ομοιογενές υλικό θα ποέπει η κατανομή της πυκνότητας του οεύματος να είναι ομοιόμοοφη [19, 21, 32, 23, 26].

1.7.3.4 Δομή κράματος Ni-P

Στα κφάματα Ni-P, όπως φαίνεται και από το διάγφαμμα φάσεων (βλ. Σχήμα 1.6), το νικέλιο και ο φώσφοφος είναι πλήφως αναμίξιμα. Το κφάμα Ni-P, ανάλογα με την πεφιεκτικότητα του σε φώσφοφο, μποφεί να βφίσκεται σε κφυσταλλική, νανοκφυσταλλική ή άμοφφη κατάσταση. Στην βιβλιογφαφία τα όφια πεφιεκτικοτήτων για αυτές τις τφείς δομές υπολογίζονται ότι είναι: κφυσταλλική φάση 0-4 wt. %, νανοκφυσταλλική φάση 4-8 wt. % και άμοφφη δομή > 8 wt. % [19].



Σχήμα 1.6: Διάγραμμα φάσεων του κράματος Ni-P [33]

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα, όμως, υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα διακριτά όρια περιεκτικοτήτων φωσφόρου ώστε να ταξινομηθούν τα κράματα σε κάποια από τις τρεις φάσεις. Συγκεκριμένα, νέες μελέτες συνδυάζουν τη δομή του κράματος με τον τρόπο παρασκευή τους. Έτσι ,μελέτες, που έχουν γίνει με την επιβολή παλμικού ρεύματος αναφέρουν την ύπαρξη κρυσταλλικών της τάξης των μερικών νανομέτρων μέσα σε άμορφη δομή για μεγάλες σχετικά περιεκτικότητες φωσφόρου (14 wt. %) καθώς και κρυσταλλικά υλικά σε περιεκτικότητες φωσφόρου όπου το κράμα θεωρείται άμορφο [30, 31].

1.7.3.5 Λουτρά απόθεσης

Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί εκτενώς η ηλεκτροαπόθεση του κράματος νικελίου-φωσφόρου και έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τύποι λουτρών. Ως πηγή νικελίου χρησιμοποιείται κυρίως θειϊκό και σουλφαμικό νικέλιο. Ως πηγή φωσφόρου χρησιμοποιείται κυρίως το φωσφορώδες οξύ και το υποφωσφορώδες νάτριο. Το υποφωσφορώδες νάτριο υπερτερεί του φωσφορώδους οξέως καθώς μπορεί να ανεβάσει την απόδοση του ρεύματος κατά τη διαδικασία της ηλεκτροαπόθεσης. Ως σταθεροποιητές του pH χρησιμοποιούνται το βορικό ή φωσφορικό οξύ. Τέλος, ως πρόσθετα (λειαντικά και στιλβωτικά) έχουν χρησιμοποιηθεί τα λαυρεντικό οξύ και η σακχαρίνη αλλά γενικά η χρήση των λειαντικών δεν είναι συχνή [7, 12, 29,32].

1.8 Θεομική κατεογασία κοαμάτων Ni-P

Το κουσταλλικό νικέλιο μποοεί να διαλύσει πολύ μικοή ποσότητα φωσφόρου βάση του διαγράμματος φάσεων Ni-P (σχήμα 1.6). Όμως, κατά την ηλεκτροαπόθεση το κράμα παρασκευάζεται ως υπέρκορο στερεό διάλυμα (supersaturated solid solution). Έτσι, από πολύ νωρίς μελετήθηκε η θερμική κατεργασία (heat treatment) του κράματος σχετικά με τις δομικές και μορφολογικές μετατροπές που προκαλεί στα αποθέματα, καθώς και με την επίδρασή της στις διάφορες ιδιότητες των αποθεμάτων.

Οι περισσότερες μελέτες αναφέρονται σε κράματα χαμηλής ή υψηλής περιεκτικότητας φωσφόρου, ενώ σε ορισμένες μελέτες συναντάται και η κατηγορία της μέσης περιεκτικότητας φωσφόρου, χωρίς όμως να γίνεται ακριβής διαχωρισμός των ορίων της κάθε κατηγορίας. Παρακάτω γίνεται αναφορά στη θερμική κατεργασία ηλεκτρολυτικών αποθεμάτων.

Για τη μελέτη της θερμικής κατεργασίας των κραμάτων Ni-P έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές, όπως η Διαφορική θερμική ανάλυση (Differential Thermal Analysis-DTA), η Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης (Differential Scanning Calorimetry-DSC), η περίθλαση ακτίνων X (XRD).

<u>Από τις θερμιδομετρικές μελέτες DSC και DTA έχει διαπιστωθεί:</u>

Α) Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας φωσφόρου

Η ύπαςξη μιας εξώθεςμης κοςυφής που αποδίδεται στην κατακςήμνιση της φάσης Ni₃P. Γενικά, το θεςμοκςασιακό εύςος στο οποίο σχηματίζεται το Ni3P είναι μεταξύ 390 – 450 oC. Σε οςισμένες μελέτες πςιν το σχηματισμό του φωσφιδίου αναφέςεται η ύπαςξη μια μικςότεςης κοςυφής, η οποία αποδίδεται στην κατακςήμνιση μικςών κουστάλλων νικελίου στο στεςεό διάλυμα. [34]

B) Κράματα υψηλής περιεκτικότητας φωσφόρου (>12 wt.%)

Η ύπαςξη δύο ή τςιών εξώθεςμων κοςυφών οι οποίες παςουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στις θεςμοκςασίες όπου εμφανίζονται σύμφωνα με τα βιβλιογςαφικά δεδομένα. Η πςώτη ισχυςά εξώθεςμη κοςυφή υποδηλώνει την αςχή του μετασχηματισμού των φάσεων νικελίου – φωσφόςου στους ~370°C.

<u>Από την περίθλαση των ακτίνων Χ (XRD) έχει διαπιστωθεί:</u>

Α) Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας φωσφόρου

Μετά τους ~400 °C οι μόνες φάσεις που ανιχνεύονται είναι αυτές του Ni και του Ni₃P, χωρίς να γίνεται δυνατός ο εντοπισμός οποιασδήποτε άλλης φάσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

B) Κράματα υψηλής περιεκτικότητας φωσφόρου (>12 wt.%)

Οι μελέτες πεφίθλασης ακτίνων Χ, οι οποίες πφαγματοποιήθηκαν σε δείγματα θεφμικά κατεφγασμένα μετά τους 370°C έδειξαν κοφυφές NisP, αλλά και κοφυφές που δεν είναι δυνατόν να αναγνωφιστούν και γενικά έχουν χαφακτηφιστεί ως υπεύθυνες φάσεων τύπου NixPy. Παφόλα αυτά, οφισμένοι εφευνητές υποστηφίζουν ότι τα φωσφίδια αυτά είναι πιθανόν να είναι φάσεις Ni-P πλούσιες σε φώσφοφο, όπως είναι οι NisP2 και Ni2P. Η δεύτεφη μεγάλη εξώθεφμη κοφυφή που ακολουθεί σε μεγαλύτεφη θεφμοκφασία (400 έως 500°C) αποδίδεται στον τελικό σχηματισμό των σταθεφών φάσεων Ni και Ni3P. Οφισμένοι εφευνητές υποστηφίζουν ότι όσο μεγαλύτεφο ποσοστό φωσφόφου πεφιέχουν τα αποθέματα Ni-P, τόσο χαμηλότεφη είναι η θεφμοκφασία που ξεκινάει η κφυστάλλωση. Έτσι, τα κφάματα με υψηλό ποσοστό φωσφόφου χαφακτηφίζονται ως ιδιαίτεφα θεφμικά ασταθή [34].

Η βασικότερη διαφορά από την προηγούμενη κατηγορία κραμάτων είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει η κρυστάλλωσή τους. Επομένως, ενώ στα χαμηλού φωσφόρου αποθέματα η ανάπτυξη των κρυστάλλων γίνεται με **αύξηση του μεγέθους τους** (κρύσταλλοι Νi υπάρχουν ήδη από τη δημιουργία του αποθέματος), στην περίπτωση των κραμάτων υψηλού φωσφόρου λαμβάνει χώρα **πρώτα η πυρηνογέννεση και ακολουθεί η ανάπτυξη των κρυστάλλωη [34]**.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1

- [1] Ν. Σπυρέλης, Τεχνολογία Επιμεταλλώσεων, Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα 1997
- [2] Ν. Κουλουμπή, Γ. Χρυσουλάκης, Θεωρητική Ηλεκτροχημεία, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 1992
- [3] V.A. Zabludovsky, N.V. Fedotova, E.F. Shtapenko, Trans. Ist. Met. Finish, 74(3) (1996), 106

[4] J. Amblard, T.A. Costavaras, A. Hugot-Le goff, N. Spyrellis, Oberflache Surface, 18 (19770, 1

- [5] J.C. Puippe, N.lbl, Plat.Surf.Fin, 66 (1980), 68
- [6] J.L. Carbajal, R.E. White, J. Electrochem. Soc., 135(1988), p.2952
- [7] R. Rofagha, U. Erb, D. Ostrander, G. Palumbo, K.T. Aust, NanoStruct. Mater., 2 (1993), p. 1
- [8] T. Burchart, Hydrog. Energ., 26 (2001), p. 1193
- [9] C. Colia, N. Spyrellis, J. Amblard, M. Froment, G. Maurin, J. Appl. Electrochem., 20 1025 (1990)
- [10] B. Sutter, Oberflache, 25 (1984), 16
- [11] P. Peeters, G.V.D. Hoorn, T. Daenen, A. kurowski, G. Staikon, Electochim, Acta, 47 (2001), p. 161
- [12] C.C. Hu, A. Bai, Mater. Chem. Phys., 77 (2002), p. 215
- [13] D. H J eong, U. Erb, K.T. Aust, G. Palumbo, Script. Mater., 48 (2003) p. 1067
- [14] Li, Platin. Surfac. Finish., 84 (1997), p. 77
- [15] J.N Balaraju, S. Narayan, S.K Seshadi, J. Appl. Electrochem., 33 (2003) p. 807
- [16] Y. Wu, L. Liu, B. Shen, W. Hu, J. Mater. Sce., 40 (2005), p. 5057
- [17] Z. Guo, K.G. Keong, W. Sha, J.Alloys Comp. 358, (2003), p.112
- [18] K. Hari Krishman, S. John, K.N Srinivasa, J. Praveen, M. Ganesan, P.M. Kavimani, Metallurg. Mater. Trans. A, 37A (2006), 1997
- [19] B.P Daly, G.J Barry, Inter. Mater. Rev., 48 (2003), p.326
- [20] N.g, D. Snyder, J.LaSala, J. Electrochem, Soc., 135 (1988), 1376
- [21] R, Narayan, M.N Mugnole, Surf. Technol. 24 (1985), p.233
- [22] T.M Harris Q.D Dang, J. Electrochem. Soc., 140, (1993), 81
- [23] Tomaszewski, L.C Tomaszewski, H. Brown, Plat. 56 (1969) 1234

- [24] T. Morikawa, T. Nakade, M. Yokoi, Y. Fukumoto, C.Iwajura, Electrochem. Act., 42, (1997), 115
- [25] G. McMahon, U. Erb, J. Mater. Scienc. Letter. 8, (1989) 865
- [26] J.P Bonimo, S. Bruet-Hotellaz, C. Bories, P. Pouderoux, A. Rousset, 27 (1997), 1193
- [27] M.H Seo, J.S. Kim, W.S Hwang, D.J.Kim, S.S. Hwang, B.S. Chum, Surf. Coat. Technol. 176 (2004) 135
- [28] E. Bradael, J.P. Celis, J.R Roos, Surf. Coat. Technol. 58, (1993) 63
- [29] M. Saitou, Y. Okudaira, W. Oshikawa, J. Electrochem. Soc, 150, (2003) 140
- [30] S. Lin, C.Y. Lee, F.J. Chen, C.T. Chien, P.L. Lin, W.C. Chung, J. Electr. Soc 153 (2003) C387
- [31] P. Pouderoux, I. Chassaing, J.P. Bonino, A. Rousset, Surf. Coat. Technol. 45 (1991) 161
- [32] D.B. Lewis, G.W. Marshall, Surf. Coat. Techn. 78 91996) 150
- [33] Κωνσταντινοπουλος Κωνσταντίνος, Διπλωματική εργασία με θέμα: «Τριβολογική μελέτη ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων μήτρας Ni-P με ενίσχυση μικροσωματιδίων SiC»
- [34] Α. Ζωίκης Καραθανάσης, Διδακτορική διατριβή «Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-P με ηλεκτρολυτική συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC σε συνθήκες παλμικού ρεύματος: σύνθεση, δομή και μηχανικές ιδιότητες», Αθήνα 2010

Κεφάλαιο 2° Σύνθετες επικαλύψεις Ni-P

2.1 Σύνθετα Υλικά

Με την πάφοδο των χφόνων, η ανάγκη για νέα υλικά με βελτιωμένες και πφοηγμένες ιδιότητες οδήγησαν στην παφαγωγή μιας καινούφγιας κατηγοφίας υλικών, **τα σύνθετα υλικά** (composite materials).

Με τον όρο σύνθετα υλικά αναφέρονται τα υλικά, τα οποία προκύπτουν από τον συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων υλικών που ανήκουν στην κατηγορία των μετάλλων, των πολυμερών και των κεραμικών. Τα υλικά αυτά είναι μη αναμίξιμα, διαφέρουν στη χημική σύσταση και επιπλέον μπορεί να είναι μερικώς χημικά αδρανή. Επιπρόσθετα, τα σύνθετα υλικά συνδυάζουν τις βέλτιστες ιδιότητες των υλικών από τα οποία προέρχονται. Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι ο συνδυασμός διαφόρων υλικών δεν είναι απαραίτητο ότι θα καταλήξει στην επιτυχή παρασκευή σύνθετων υλικών, αφού προαπαιτείται προσεχτικός σχεδιασμός των λειτουογικών χαρακτηριστικών τους. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές αποτελούν την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λύση έναντι των συμβατικών υλικών [1].

Τα σύνθετα υλικά απαρτίζονται από δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις, αλλά συνήθως αποτελούνται από τις δύο εξής φάσεις:

Τη μήτρα (matrix), η οποία μπορεί να είναι είτε μέταλλο, είτε κεραμικό, είτε πολυμερές υλικό και

Το μέσο ενίσχυσης ή ενισχυτικό μέσο (reinforcing material), το οποίο μπορεί να είναι είτε μέταλλο, είτε κεραμικό, είτε πολυμερές υλικό. Το μέσο ενίσχυσης έχει την μορφή κόκκων (particles), ινών (fibers) ή φύλλων

(laminates). Το ενισχυτικό μέσο περικλείεται από τη συνεχή φάση της μήτρας, σχηματίζοντας το συνθετικό υλικό.

Συγκεκοιμένα, ιδιαίτεοη αναφορά γίνεται για τα σύνθετα υλικά με μεταλλική μήτρα. Τα σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας μπορεί να έχουν ως μήτρα ένα απλό μέταλλο ή ένα κράμα μετάλλων και ταξινομούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας, όπου το ενισχυτικό μέσο είναι
υπό τη μορφή σωματιδίων (particles reinforced MMCs). Το μέγεθος των
σωματιδίων είναι μεγαλύτερο από 1μm και μικρότερο από 40 μm, ενώ το
κατ'όγκον ποσοστό τους στην μεταλλική μήτρα κυμαίνεται μεταξύ 5-40
%.

Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας όπου το ενισχυτικό μέσο είναι υπό τη μορφή *ινών* (fiber/whisker reinforced MMCs). Το μήκος των ινών συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,1-250 μm, ενώ το κατ' όγκον ποσοστό τους στη μεταλλική μήτρα μπορεί να φτάσει έως και 70 %.

Σύνθετα υλικά, όπου το ενισχυτικό μέσο είναι υπό τη μορφή μικροσωματιδίων (dispersed hardened MMCs) ομοιόμορφα κατανεμημένων στην μεταλλική μήτρα. Το μέγεθός των μικροσωματιδίων είναι μικρότερο του 1μm ενώ το κατ'όγκον ποσοστό τους στην μεταλλική μήτρα κυμαίνεται μεταξύ 1-15 %.

Τα συνηθέστερα μέσα ενίσχυσης υπό τη μορφή σωματιδίων είναι κυρίως τα οξείδια, καρβίδια, βορίδια και νιτρίδια διαφόρων μετάλλων (π.χ Sio₂, Al₂O₃, Cr₂O₃, Sic, WC, TiC, Cr₃C₂ AIN) τα σωματίδια γραφίτη, διαμαντιού όπως και τα οργανικά πολυμερικά σωματίδια.[2]

2.2 Σύνθετες ηλεκτοολυτικές επικαλύψεις μεταλλικής

μήτρας

Στην ευφεία κατηγοφία των σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτφας υπάγονται και οι σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις, οι οποίες χφησιμοποιούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό στις βιομηχανικές εφαφμογές. Η ευφεία χφήση τους οφείλετε στα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Μικρό κατασκευαστικό κόστος λόγω της δυνατότητας χρήσης
υλικών χαμηλού κόστους ως πρώτες ύλες.

 Μικρότερο βάρος και μικρότερη πυκνότητα έναντι των κλασσικών μεταλλικών υλικών, που χρησιμοποιούνταν για την ίδια χρήση.

 Παράταση του χρόνου ζωής των υλικών, με δυνατότητα αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης μόνο της επιφάνειάς τους, όπου υπάρχει σύνθετη επικάλυψη.

Δυνατότητα χρήσης του υπό πολύ αντίξοες συνθήκες λειτουργίας,
διότι διαθέτουν βελτιωμένες μηχανικές, θερμομηχανικές και
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

Οι συνηθέστερες μέθοδοι παρασκευής σύνθετων επικαλύψεων μεταλλικής μήτρας με ενίσχυση σωματιδίων είναι οι εξής παρακάτω:

1) Ηλεκτοολυτική $\alpha \pi \delta \theta \epsilon \sigma \eta$ (electrodeposition)

2) Χημική απόθεση σε αέρια φάση (chemical vapor deposition)

3) Χημική απόθεση σε φάση πλάσματος (plasma vapor deposition)

4) Απόθεση μετάλλου με ψεκασμό (metal spray deposition)

5) Κονιομεταλλουγία (powder metallurgy)

6) Συγκαταβύθιση (coprecipation)

- 7) Δ ιέλαση (extrusion)
- 8) Μηχανική ανάμιξη (mechanical mixing)
- 9) Εσωτερική οξείδωση (internal oxidation)
- 10) Επιφανειακή κατεργασία με ακτίνες λέιζερ (laser surface treatment)
- 11) Η μη ηλεκτοολυτική ή αυτοκαταλυώμενη απόθεση (electroless)

[3]

Στην συγκεκοιμένη εργασία μελετώνται οι σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις, οι οποίες παρασκευάζονται με τη μέθοδο της ηλεκτρολυτικής συναπόθεσης νανοσωματιδίων (electrolytic- codeposition).

2.3 Ηλεκτοολυτική Συναπόθεση (electrolytic- codeposition)

2.3.1. Ορισμός

Με τον όρο ηλεκτρολυτική συναπόθεση ονομάζεται η διαδικασία ενσωμάτωσης αδρανών σωματιδίων στη μεταλλική μήτρα κατά την απόθεση του μετάλλου. Τα σωματίδια είναι δυνατόν να συναποτεθούν με δύο τρόπους στο μεταλλικό απόθεμα:

(i) Είτε διατηφούνται ομοιογενώς διεσπαφμένα στο ηλεκτφολυτικό λουτοό μέσω ανάδευσης και ενσωματώνονται στο απόθεμα συμπαρασυρόμενα από τα μεταλλικά ιόντα που ανάγονται στην κάθοδο διατηρούνται ομοιογενώς (ii) Είτε. ενώ διεσπαρμένα στο ηλεκτρολυτικό λουτρό, αφήνονται να καθιζάνουν στην καθοδική επιφάνεια και εγκλείονται στο απόθεμα κατά την ηλεκτοοαπόθεση του

μετάλλου. Τα ποσοστά συναπόθεσης με αυτόν τον τρόπο είναι αρκετά αυξημένα.

Τα συνηθέστερα ενισχυτικά μέσα που έχουν μελετηθεί και αφορούν σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις είναι: SiO₂, Al₂O₃, ZrO₂, TiO₂, μικροσωματίδια SiC και πολυμερικές κάψουλες.

Κάποια από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μέθοδος της ηλεκτρολυτικής συναπόθεσης είναι ότι:

 Απαιτεί χαμηλές θεομοκοασίες και έχει σχετικό χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουογίας.

Διαθέτει τη δυνατότητα μεγάλου εύφους μεταβολής των συνθηκών
λειτουφγίας, με αποτέλεσμα την δυνατότητα παφαγωγής αποθεμάτων με
πφοκαθοφισμένες ιδιότητες χωφίς να χφειάζεται πεφεταίφω κατεφγασία.

 Επιτρέπει την παραγωγή σύνθετων επικαλύψεων ελεγχόμενου πάχους σε επιφάνειας με πολύπλοκο σχήμα αλλά και σύνθετων πολυστρωματικών επικαλύψεων ή σύνθετων επικαλύψεων κραματικής μήτρας, που με άλλες τεχνικές είναι δύσκολο ή αδύνατο να παραχθούν [4,5].

2.3.2. Παράμετροι που επηρεάζουν την ηλεκτρολυτική συναπόθεση

Όπως στην ηλεκτφολυτική απόθεση των απλών μετάλλων, έτσι και στην ηλεκτφολυτική συναπόθεση σωματιδίων, υπάφχουν πολλές πειφαματικές παφάμετφοι που επηφεάζουν την διαδικασία της συναπόθεσης και επιδφούν στα χαφακτηφιστικά των σύνθετων αποθεμάτων. Οι πιο βασικές παφάμετφοι οι οποίες επιδφούν στην κουσταλλική οογάνωση, τη δομή, την επιφανειακή μοοφολογία, τις ιδιότητες των σύνθετων αποθεμάτων, στο ποσοστό συναπόθεσης και την ομοιόμοοφη κατανομή των σωματιδίων του ενισχυτικού μέσου στη μεταλλική μήτοα είναι: <u>η σύσταση του ηλεκτοολυτικού λουτοού</u>, <u>η</u> <u>θεομοκοασία, το pH</u>, <u>η πυκνότητα του οεύματος</u>, <u>σχήμα και μέγεθος</u> <u>σωματιδίων</u> και <u>η επιφανειακή φόρτιση.</u>

Σύσταση του ηλεκτρολυτικού λουτρού

Η σύσταση του ηλεκτφολυτικού λουτφού συναπόθεσης αποτελεί μία από τις σημαντικότεφες πειφαματικές παφαμέτφους. Πολλοί εφευνητές, κατά καιφούς, έχουν διαπιστώσει ότι για ίδια σύνθετα συστήματα, διαφοφετικά είδη λουτφών δίνουν διαφοφετικούς φυθμούς συναπόθεσης, ενώ για οφισμένους τύπους λουτφών η συναπόθεση μποφεί να μην είναι καθόλου εφικτή.

Συγκεκοιμένα, το 1967 οι Brandes&Goldthorpe [6] διαπίστωσαν ότι τα σωματίδια Al2O₃ αποτίθενται μεν σε λουτοά Cu και Ni, αλλά όχι σε χοωμικά λουτοά. Επιπλέον, για το σύστημα Cu/Al2O₃ τα λουτοά κυανιούχου χαλκού δίνουν καλύτεοα αποθέματα από τα λουτοά θειϊκού χαλκού. Αν και υπάοχουν πολλές μαοτυρίες για τις επιδοάσεις των αλλαγών των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λουτοών, δεν υπάοχουν πολλές μαοτυρίες για τις επιδοάσεις των ποσοτικών αλλαγών. Οι Williams&Martins [6] βρήκαν ότι για το σύστημα Cu/ ίνες SiO₂, η αύξηση της συγκέντρωσης του CuCN στο λουτοό κυανιούχου χαλκού συνεπάγεται αύξηση της πυκνότητας των συναποτιθέμενων ινών SiO₂, ενώ πειράματα για το σύστημα Cr/γραφίτη δίνουν ανάλογα αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια σημαντική παράμετρος που αφορά την σύσταση του ηλεκτρολυτικού λουτρού είναι η γήρανσή του. Για

παφάδειγμα, στο σύστημα Cu/Al2O3 παφατηφήθηκε μείωση του ποσού Al2O3 με την γήφανση του λουτφού, η οποία πιθανόν να οφείλεται σε ακαθαφσίες του λουτφού. Αντίθετα, το αντίστοιχο φαινόμενο δεν παφατηφήθηκε για το σύστημα Cr/ Al2O3 [7].

Θεομοκοασία

Η επίδραση της θερμοκρασίας του λουτρού ποικίλει για διαφορετικά συστήματα συναπόθεσης. Έτσι, για το σύστημα Ni/ Al2O3 να υπάρχει κάποια επίδραση της θερμοκρασίας στο ποσοστό των αποτιθέμενων σωματιδίων. Αντίθετα, στο σύστημα Ni/ V2O3 παρατηρήθηκε ότι η μέγιστη περιεκτικότητα σε σωματίδια επιτυγχάνεται για θερμοκρασία λουτρού ίση με 50 °C. Συνεχίζοντας, η ενσωματωμένη ποσότητα γραφίτη σε μήτρα Cu αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 50 °C, ενώ για το σύστημα Cr/ Al2O3 έχει παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των σωματιδίων που αποτίθενται για θερμοκρασία πάνω από τους 50 °C [8].

• <u>pH</u>

Η τιμή pH του ηλεκτφολυτικού λουτφού είναι ένας ιδιαίτεφα σημαντικός παφάγοντας, κυφίως για την μεταβολή του ποσοστού συναπόθεσης. Έτσι, για το σύστημα Ni/Al2O3 ο Sauter διαπίστωσε ότι για pH>2 ότι δεν παφατηφούνται σημαντικές μεταβολές του ποσοστού ενσωμάτωσης, ενώ κάτω από αυτή την τιμή το ποσοστό των συναποτιθέμενων σωματιδίων μειώνεται απότομα [8]. Επιπλέον, σύμφωνα με πφόσφατες έφευνες των Yeh & Wan, για τιμές του pH μικφότεφες του 2, η απόδοση του φεύματος κατά την αναγωγή του Ni παφουσία σωματιδίων SiC μειώνεται σημαντικά [9]. Σε διαφοφετική έφευνα για το ίδιο παφατηφήθηκε ότι αύξηση της τιμής του pH

συνεπάγεται αύξηση της συναπόθεσης των σωματιδίων, για σχετικές χαμηλές τιμές συγκέντοωσής τους στο λουτοό (20 g/L). Αντίθετα, κάποιοι εφευνητές διαπίστωσαν ότι η ενσωμάτωση των σωματιδίων στο απόθεμα είναι η μέγιστη για pH=4, ενώ η τιμή αυτή φαίνεται να είναι ανεξάφτητη του μεγέθους των σωματιδίων[9].

<u>Πυκνότητα του οεύματος</u>

Η πυκνότητα του φεύματος εκφφάζει τον φυθμό αναγωγής ιόντων στην κάθοδο, δηλαδή το φυθμό κφυσταλλικής ανάπτυξης του μεταλλικού αποθέματος και είναι μία από τις σημαντικότεφες παφαμέτφους για τον καθοφισμό του ποσοστού ενσωμάτωσης του ενισχυτικού μέσου. Η αύξηση της πυκνότητας του φεύματος, συνήθως, οδηγεί στη μείωση του αφιθμού των συναποτιθέμενων σωματιδίων, αν και παφατηφήθηκε ότι συνήθως στην καμπύλη πυκνότητας φεύματος συναφτήσει του ποσού σωματιδίων υπάφχουν ένα ή πεφισσότεφα μέγιστα. Σε κάθε πεφίπτωση, πάντως, η μεταβολή του ποσοστού συναπόθεσης συναφτήσει της πυκνότητας φεύματος εξαφτάται σημαντικά από το είδος των σωματιδίων.

Εκτός από το γεγονός ότι η πυκνότητα του φεύματος επηφεάζει τη συναπόθεση των σωματιδίων σημαντικό να αναφεφθεί είναι το γεγονός ότι και η πυκνότητα του φεύματος επηφεάζεται από την παφουσία των σωματιδίων. Πολλοί είναι οι εφευνητές που βφήκαν ότι η πφοσθήκη των σωματιδίων στο ηλεκτφολυτικό λουτφό συνεπάγεται την εμφάνιση υψηλότεφης τιμής πυκνότητας φεύματος, για το ίδιο δυναμικό, υποδεικνύοντας μια αποπόλωση της καθόδου παφουσία σωματιδίων.

<u>Σχήμα και μέγεθος σωματιδίων</u>

Σχετικά με την επίδοαση του σχήματος των σωματιδίων στην ηλεκτοολυτική συναπόθεση δεν έχει γίνει εκτεταμένη έφευνα. Έχει βρεθεί, όμως, ότι το σχήμα επιδρά στην προσρόφηση των σωματιδίων στην κάθοδο, στην προσρόφηση των ιόντων στην επιφάνεια των σωματιδίων και στην ευστάθεια της αιώρησης.

Μελετώντας, τώρα, την επίδραση του μεγέθους των σωματιδίων στην συναπόθεση έχουν αναφερθεί διαφορετικά αποτελέσματα. Για επικαλύψεις, Ni/Al2O3 και Ni/Cr αύξηση του μεγέθους των σωματιδίων προκαλεί αύξηση του ποσοστού των αποτιθέμενων σωματιδίων [10,11]. Επιπρόσθετα, έχει φανεί ότι το ποσό του συναποτιθέμενου φωσφόρου (P) στον χαλκό (Cu) αυξάνει γραμμικά με το μέγεθος των σωματιδίων [12]. Αντίθετα, ανεπαίσθητη είναι η επίδραση του μεγέθους των σωματιδίων για επικαλύψεις Ni/ Al2O3 και Ag/Al2O3 ενώ και ο ουθμός απόθεσης είναι μικρότερος για μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων [13,14]. Τελευταία έχουν μελετηθεί διεξοδικά οι σύνθετες επικαλύψεις Ni/SiC και παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό ενσωμάτωσης μειώνεται με ελάττωση του μεγέθους των σωματιδίων [15].

<u>Επιφανειακή φόρτιση</u>

Μεγάλη αναφορά έχει γίνει στην επίδραση της επιφανειακής φόρτισης των σωματιδίων. Οι Fink & Prince, αφού εκτίμησαν τη σπουδαιότητα της επιφανειακής φόρτισης, ανέφεραν ότι η θετική επιφανειακή φόρτιση αυξάνει τη συναπόθεση γεγονός που οφείλεται στο ότι τα σωματίδια έλκονται από την κάθοδο [16].

Οι Tomaszewski et al. επικύφωσαν τα όσα είπα οι Fink & Prince και ισχυρίστηκαν ότι τα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια SiO₂ μεταφέρονται

δυσκολότεφα στην κάθοδο από τα θετικά φοφτισμένα σωματίδια Al₂O₃. Επίσης, το 1693 οι αδεφφοί Tomaszewski παφατήφησαν ότι τα σωματίδια αποκτούν θετική επιφανειακή φόφτιση όταν πφοσφοφώνται μεταλλικά ιόντα ή ιόντα υδφογόνου. Συνεχίζοντας, το 1982 οι Naraya & Chattpadhy κατάφεφαν να επιλύσουν το πφόβλημα της συναπόθεσης σωματιδίων Al₂O₃ σε χφώμιο, με ξηφή λειοτφίβηση πφιν από κάθε πείφαμα, με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να αλλάζει τις επιφανειακές τους ιδιότητες και τελικά να δημιουφγεί μια θετική επιφανειακή φόφτιση [17].

Το 1987 οι Meguno et al. επιβεβαίωσαν τις προτάσεις των αδερφών Tomaszewski et al, μετρώντας την επιφανειακή φόρτιση των σωματιδίων ποσοτικά μέσω του δυναμικού ζ (ζ-potential) [18]. Το 1993 ο Helle διαπίστωσε ότι όταν:

- ζ < 0 τότε η συναπόθεση των σωματιδίων είναι μικρή
- ζ = 0 τότε η συναπόθεση των σωματιδίων εμποδίζεται και
- $\zeta > 0$ τότε η συναπόθεση των σωματιδίων είναι μεγάλη.

Πιο αναλυτικά, με μετφήσεις του δυναμικού ζ εφμηνεύτηκε η ευκολία συναπόθεσης σωματιδίων α- Al2O3 έναντι σωματιδίων γ- Al2O3, αφού το δυναμικό των α- Al2O3 σωματιδίων βφέθηκε ότι είναι μεγαλύτεφο και θετικό σε θειϊκά λουτφά χαλκού, ενώ το δυναμικό των σωματιδίων γ-Al2O3 είναι μικφότεφο και αφνητικό. Τέλος, βφέθηκε ότι για τα σωματίδια α-SiC και γ-SiC το δυναμικό ζ είναι αφνητικό σε υψηλές τιμές του pH, αυξάνεται με μείωσή του και γίνεται θετικό στις χαμηλές τιμές του pH, αυξάνεται με μείωσή του και γίνεται θετικό στις χαμηλές τιμές του [19]. Όσον αφοφά την επίδφαση της αύξησης του ποσοστού συναπόθεσης των σωματιδίων, την ταυτόχφονη ομοιόμοφφη κατανομής τους και τις ιδιότητες των παφαγόμενων σύνθετων αποθεμάτων, έχουν γίνει πολλές μελέτες σε διάφοφα σύνθετα συστήματα και έχουν διαπιστωθεί κυφίως τα ακόλουθα συμπεφάσματα[19]: Η Με την αύξηση του ποσοστού συναπόθεσης αυξάνονται οι εσωτερικές τάσεις των αποθεμάτων κατά απόλυτη τιμή, γεγονός που, πιθανόν, αποδίδεται στην αύξηση της πυκνότητας των αταξιών της δομής, που επιφέρει η συναπόθεση.

Η Με την αύξηση του ποσοστού συναπόθεσης, τα σύνθετα αποθέματα εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σκληρότητας, βελτιωμένη ελατότητα και μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και τις θερμομηχανικές καταπονήσεις.

2.4 Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-P

Ενδιαφέρον, παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις νικελίου-φωσφόρου. Όπως φαίνεται και από τα προαναφερθέντα, η μήτρα αυτών των επικαλύψεων αποτελείται από κράμα Ni-P. Η συναπόθεση του φωσφόρου στο νικέλιο επηρεάζει σημαντικά τη δομή και τις ιδιότητες της μήτρας.

Οι βασικές μέθοδοι παρασκευής των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P είναι:

- (i) Η ηλεκτφολυτική συναπόθεση(electrolytic- codeposition), η οποία αναπτύχθηκε προηγουμένως και
- (ii) Η μη ηλεκτοολυτική ή αυτοκαταλυώμενη απόθεση (electroless).

2.4.1. Σύνθετες ηλεκτοολυτικές επικαλύψεις μήτοας Ni-P

Επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μεταλλικές ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μήτρας Ni-P, έχουν δείξει αυξημένη αντοχή σε διάβρωση και αυξημένη αντοχή στη φθορά λόγω τριβής. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, μελέτες έχουν δείξει ότι η ενσωμάτωση σκληρών σωματιδίων στη μήτρα (γνωστά ως ενισχυτικά μέσα) έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση αντοχής στη φθορά, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται και οι καλές ιδιότητες των αποθεμάτων Ni-P [20,21].

2.4.1.1 Ενισχυτικά μέσα

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις μήτρας Ni-P, που ως ενισχυτικό μέσο έχει χρησιμοποιηθεί το διοξείδιο του τιτανίου (TiO₂), Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα σωματίδια σε ποικιλία μεγεθών ως ενισχυτικά μέσα.

Το ποσοστό ενσωμάτωσης των σωματιδίων στη μήτρα Ni-P εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων με κυριότερες το μέγεθος των σωματιδίων, την πυκνότητα του ρεύματος και συγκέντρωση των σωματιδίων στο λουτρό. Γενικά, τα σωματίδια μεγαλύτερου μεγέθους ευνοούνται στη συναπόθεση. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η συγκέντρωση των σωματιδίων στο λουτρό και όσο υψηλότερες πυκνότητες ρεύματος επικρατούν στο λουτρό τόσο μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά ενσωμάτωσης. Ακόμα, μελέτες έχουν δείξει ότι όταν αυξάνεται η συγκέντρωση των σωματιδίων στο λουτρό ευνοείται η συναπόθεση των μικρότερων σε μέγεθος σωματιδίων. Τέλος, η αύξηση του φορτίου των σωματιδίων στο λουτρό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα συσσωματωμάτων, κυρίως όταν το ονομαστικό μέγεθος των σωματιδίων είναι πολύ μικρό [22].

Επιπρόσθετα, το οξείδιο του αλουμινίου (Al2O3) έχει χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες μελέτες [23,24] ενώ σε μεμονωμένες μελέτες έχουν εμφανιστεί ως μέσα ενίσχυσης τα σωματίδια: Si3N4 [25], Ti [26], νάνοδιαμαντιών (UFD) [27]. Τέλος, πολύ πρόσφατα μελετήθηκε η ηλεκτρολυτική συναπόθεση νανοσωλήνων άνθρακα (MWCN) σε μήτρα Ni-P [28].

2.4.1.2 Ιδιότητες

Κατά κύφιο λόγο η δημιουογία σύνθετων επικαλύψεων μήτοας Ni-P αποσκοπεί στην παφασκευή ανθεκτικών επικαλύψεων σε συνθήκες όπου απαιτείται υψηλή αντοχή στην τφιβή ή και στη διάβφωση. Έτσι, οι πεφισσότεφες μελέτες επικεντφώνονται στη διεφεύνηση ιδιοτήτων των σύνθετων αποθεμάτων όπως είναι η σκληφότητα, η τφιβολογική συμπεφιφοφά και η αντοχή τους σε διαβφωτικά πεφιβάλλοντα. Επίσης, οφισμένες εφγασίες αναφέφονται στην καταλυτική δφάση των επικαλύψεων αυτών ως ηλεκτφόδια αναγωγής του υδφογόνου.

Όσον αφορά στη σκληρότητα έχει διαπιστωθεί ότι η εισαγωγή των σωματιδίων ενίσχυσης στην μήτρα Ni-P ενισχύει τη σκληρότητα των αποθεμάτων σε σχέση με τις απλές επικαλύψεις.

Διάφοφες μελέτες που αφοφούσαν σε σύνθετα υλικά μήτφας Ni-P, έδειξαν ότι η σκληφότητα αυξάνει όταν το ποσοστό συναπόθεσης των σωματιδίων αυξάνει [29,30]. Από την άλλη μεφιά, οι Chou et al. μελετώντας σύνθετα αποθέματα χαμηλής πεφιεκτικότητας φωσφόφου, δηλαδή με κφυσταλλική δομή μήτφας Ni-P, υποστηφίζουν ότι η κύφια

παφάμετφος που επιδφά στη μικφοσκληφότητα είναι η πεφιεκτικότητα του φωσφόφου στο απόθεμα και όχι το ποσοστό συναπόθεσης των σωματιδίων, καθώς δεν φαίνεται να επιδεικνύουν σκλήφυνση λόγω διασποφάς (dispersion hardening) [31]. Η θεφμική κατεφγασία των αποθεμάτων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μικφοσκληφότητας τους λόγω της κφυστάλλωσης της άμοφφης μήτφας και της κατακφήμνισης του Ni₃P [32,33,34].

Από τριβολογικές μελέτες που έγιναν και αφορούσαν σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μήτρας Ni-P έδειξαν ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό ενσωμάτωσης TiO₂ μειώνεται ο όγκος φθοράς. Οι Aslanyan et al. συμπέραναν ότι τόσο η αντοχή σε φθορά όσο και ο μηχανισμός τριβής εξαρτώνται από τον τύπο της ολίσθησης. Η μέση τιμή του συντελεστή τριβής δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία των σωματιδίων ή από τη θερμική κατεργασία των αποθεμάτων. Παρόλα αυτά, οι διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη του συντελεστή τριβής φανερώνουν διαφορετικούς μηχανισμούς τριβής. Έτσι, στην περίπτωση της συναπόθεσης TiO2 η αλλαγή στον μηχανισμό τριβής πιθανόν να οφείλεται στα σωματίδια ΤiO2 που αποκολλούνται από τη μήτρα και είτε εγκλωβίζονται στην περιοχή επαφής είτε μεταφέρονται στο αντίπαλο σώμα. Ο μηχανισμός αυτός εμποδίζει τη δημιουργία προστατευτικού φιλμ στην πίστα τριβής (όπως γίνεται στην περίπτωση των Ni-P αποθεμάτων), και έτσι συμπέραναν ότι τα σύνθετα αποθέματα έχουν χειρότερη αντοχή στην φθορά σε σύγκριση με τα θερμικά κατεργασμένα απλά αποθέματα Ni-P.

Όσον αφορά στις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες των σύνθετων αποθεμάτων μήτρας Ni-P, οι Malfatti et al. διαπίστωσαν ότι η αύξηση του ποσοστού συναπόθεσης σωματιδίων (μεγέθους 600 nm) επιδρά ευνοϊκά στην αντοχή σε διάβρωση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τις επιφάνειας καλύπτεται από τα σωματίδια. Παρόλα αυτά, μετά τη θερμική τους κατεργασία φαίνεται ότι η αντοχή σε διάβρωση μειώνεται καθώς η συρρίκνωση της μήτρας Ni-P γύρω από τα σωματίδια δημιουργεί ασυνέχειες [35].

Πέφα από τις μηχανικές ιδιότητες των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P, σε παλαιότεφες μελέτες έχουν διεφευνηθεί και οι καταλυτικές τους ιδιότητες ως ηλεκτφόδια αναγωγής υδφογόνου. Οι Gierlotka et al. διαπίστωσαν ότι η συναπόθεση TiO₂ σε Ni-P μήτφα αυξάνει το φυθμό αναγωγής του υδφογόνου τόσο σε όξινο, όσο και σε αλκαλικό πεφιβάλλον [36]. Επίσης, οι Shi et al. χφησιμοποιώντας νανο-διαμάντια και νανοσωλήνες άνθφακα κατάφεφαν να αυξήσουν το φυθμό αναγωγής υδφογόνου, και απέδωσαν αυτή την αύξηση στη μεγάλη ειδική επιφάνεια της νανοδομής που σχηματίζεται, ευνοώντας έτσι την πφοσφόφηση των υδφογονοκατιόντων [37].

2.5 Χαρακτηριστικά Διοξειδίου του Τιτανίου (TiO₂)

Όπως αναφέφαμε και στην παφαπάνω παφάγφαφο στην παφούσα μεταπτυχιακή εφγασία, ως ενισχυτικό μέσο έχει χφησιμοποιηθεί το διοξείδιο του τιτανίου (TiO₂). Είναι ημιαγώγιμο υλικό και εμφανίζεται με τη μοφφή λευκής σκόνη, η οποία εμφανίζεται χημικώς μη αδφανής, μη τοξική, με ιδιαίτεφα χαμηλό κόστος.

Από χημική σκοπιά το διοξείδιο του τιτανίου δεν αντιδρά με τα ορυκτά οξέα (ισχυρά ανόργανα οξέα), παρά μόνο με πυκνό θειικό οξύ, από το οποίο και διαλύεται προς κίτρινο θειικό τιτανύλιο [38]:

 $TiO_{2(s)} + H_2SO_{4(aq)} - TiOSO_{4(aq)} + H_2O_{(l)}$ (E§ 1.10)

Το συγκεκοιμένο οξείδιο δεν επιδεικνύει καμία διαλυτότητα σε κοινούς διαλύτες. Σχηματίζει κολλοειδή διαλύματα στο νεοό και τους πολικούς διαλύτες.



Σχήμα 2.1. Γενικές βιομηχανικές μέθοδοι παφασκευής τιτανίας [39].

Βιομηχανικά, διοξείδιο του τιτανίου παρασκευάζεται με δύο βασικές διεργασίες: τη διαδικασία χλωριούχων και θειικών (Σχήμα 2.1). Άλλες εφαρμοσμένες μέθοδοι παρασκευής τιτανίας εμπορικής καθαρότητας είναι:

Κατεργασία ορυκτού ιλμενίτη (ilmenite) με πυκνό θειικό οξύ και υδρόλυση με ανθρακικό αμμώνιο [40].

- Κατεργασία μεταλλικού τιτανίου με αμμωνιακό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 90% [41].
- Οξείδωση τιτανίου σε περίσσεια οξυγόνου [41].
- Θεομική επεξεογασία με ψεκασμό, αλάτων ή οργανικών ενώσεων τιτανίου σε ανοικτή φλόγα [41].

Η χαμηλή έως ανύπαφκτη τοξικότητα του οξειδίου το καθιστά ένα από τα πιο αδφανή συστατικά για τον ανθφώπινο οφγανισμό. Η συμπεφιφοφά αυτή αιτιολογείται από την υψηλή και σταθεφή οξειδωτική βαθμίδα του τιτανίου [42]. Ο κύφιος τφόπος εισόδου στο σώμα είναι η αναπνευστική οδός. Ωστόσο, ακόμα και συγκεντφώσεις 250 mg.m⁻³ στον ατμοσφαιφικό αέφα, δεν πφοκαλούν παφά δύσπνοια και έντονο βήχα, χωφίς άλλες παφενέφγειες [43-44]. Η ποσότητα που αποφφοφάται στους πνεύμονες κατόπιν έντονης εισπνοής σκόνης μποφεί να παφακολουθηθεί με ακτινολογική εξέταση. Υπολογίζεται ότι ο χφόνος ημιζωής στο ανθφώπινο σώμα είναι 320 ημέφες [54]. Το διοξείδιο του τιτανίου δεν αποτελεί υλικό που σχετίζεται με την ανάπτυξη νεοπλασιών [45].

Η δομή του διοξειδίου του τιτανίου προκύπτει από την ανάμιξη των 2p οξυγόνου 3d τροχιακών του με τα τροχιακά του τιτανίου. Κουσταλλογραφικά απαντάται σε τρεις κύριες μορφές (σε σειρά εμφάνισης στο φλοιό της γης): ανατάσης, ρουτίλιο και μπρουκίτης (anatase, rutile και brookite) [46]. Τα παραπάνω υλικά αφορούν δομές πολυμορφισμού του ημιαγωγού, με διαφορετική διευθέτηση των ατόμων στο χώρο. Οι συνηθέστερες δομές είναι του ανατάση και του ρουτιλίου. Τόσο ο μπρουκίτης όσο και ο ανατάσης μεταπίπτουν μη αντιστρεπτά στην κουσταλλική φάση του οουτιλίου μετά από ολιγόλεπτη θέρμανση στους 870Κ [47]. Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η χωροπληρωτική (space filled) δομή ανατάση – οουτιλίου:

	Ρουτίλιο	Ανατάσης
Ενεργ. Χάσμα (E _s):	3.02 eV	3.23 eV
Ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού ΔG ^e f:	-212.6 kcal·mol ⁻¹	-211.4 kcal·mol ⁻¹
Ευκινησία ηλεκτρονίων κατά Hall:	0.1 cm ² ·V ⁻¹ ·s ⁻¹	4-20 cm ² ·V ⁻¹ ·s ⁻¹
Πυκνότητα ρ (25ºC):	4.250 g⋅cm ⁻³	3.894 g·cm⁻³
Δείκτης διάθλασης: (633nm)	2.8	2.5
Απόσταση δεσμού Ti-O:	1.959Å	1.917Å
Συμβολισμός συμμετρίας Θεωρίας Ομάδων:	P42/mnm	I4/amd
Δομή πλήρωσης χώρου		
(filled space):		
(Τα οκτάεδρα		
συμβολίζουν στο χώρο		
τη δομή ΤiO₅)		
Σχετική Ατομική Θέση:		

Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικές φυσικοχημικές ιδιότητες ρουτιλίου και ανατάση [48]

Το TiO₂ έχει επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα, δρα δηλαδή τόσο ως οξύ όσο και ως βάση κατά Brönstead-Lowry (Δότης ή δέκτης υδρογονοκατιόντων H⁺). Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι να ενυδατώνεται πολύ εύκολα. Το προσροφώμενο νερό διασπάται με το υδροξύλιο να σχηματίζει βασικές ομάδες Ti-OH και το πρωτόνιο όξινες Ti-OH⁺-Ti [48]. Οι ομάδες υδροξυλίου δρουν και ως Lewis όξινες θέσεις όταν βρεθούν σε επαφή με ενώσεις που διαθέτουν κενό ζεύγους ηλεκτρονίων (π.χ. μέταλλα μετάπτωσης). Ο βασικός κατά Lewis χαρακτήρας εκδηλώνεται σε επαφή με οργανικά οξέα.

> Ti-OH + H⁺ TiOH₂⁺ pK_α = 4.95 (Eξ 1.11) Ti-OH TiO⁻ + H⁺ pK_α = 7.80 (Eξ 1.12)

Το ισοηλεκτοικό σημείο του TiO₂ βρίσκεται σε pH=½(4.95+7.8) = 6.4 [49]. Κατά συνέπεια, η επιφάνεια του TiO₂ σε pH μικρότερο του 6.4 είναι θετικά φορτισμένη λόγω της πρωτονίωσης των επιφανειακών υδροξυλίων.

2.6 Στόχος της εργασίας

Από τα παφαπάνω είναι φανεφό ότι οι σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις μήτφας Ni-P με ενίσχυση νανο-σωματιδίων TiO² αναμένεται να συνδυάζουν τις εξαιφετικές μηχανικές ιδιότητες της κφαματικής μήτφας, καθώς και να ενισχύονται από την παφουσία των νανο-οξειδίων, τα οποία παφουσιάζουν πολύ ενδιαφέφουσες φωτοκαταλυτικές δφάσεις.Επίσης, η εφαφμογή παλμικού φεύματος αναμένεται να βελτιώσει πεφαιτέφω την ποιότητα και τις φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες των επικαλύψεων αυτών, ανοίγοντας πφοοπτικές ανάπτυξης υλικών με πολλαπλές εφαφμογές, όπως ανάπτυξη αυτοκαθαφιζόμενων και αντιμικφοβιακών μεταλλικών επιφανειών.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 2

[1] M. Grayson (editor), Encyclopedia of Composite Materials and Components, John Wiley & Sons, New York, 1983

[2] M. Taya, R.J. Arsenault, Metal Matrix Composites – Thermomechanical Bahaviour, Pergamon Press, G.B. (1989)

[3] T.W. Clyne, P.J. Whithers, An introduction to composite materials, 2nd Ed. (1996)

[4] M. Ohring, Engineering Materials Science, Academic Press, USA, 1995

[5J. Walz, Adv. Colloid Interface Sci., 74 (1998) p.119

[6] R.V. Williams, P.W. Martin, Trans. Inst. Met. Finish. 42 (1964) p.182

[7] J.Jahavi, J. Hazan, Plat. Surf. Finish. 70 (1983) p.56 [8] C.T.J. Low, R.G.A Wills, F.C Walsh, Surf. Coat. Technol., 201 (2006) p.371

[8] F.K Sauter, J. Electrochem. Soc 110 (6) (1963) p. 557

[9] S.H.Yeh, C.C.Wan, J.Appl.Electrochem, 24 (1994), p.993

[10] J.Apachitei, J.Duszczyk, L.Katgerman, P.J.B.Overkamp, Scripta Materialia, 38 (9) (1998)

[11] G.Murin, ALavanant, J.Appl.Electochem. n25, 1995

[12] E.A.Lukashev, Rus.J.Electrochem, 1994

[13] J.L. Carbajal, R.E. White, J. Electrochem. Soc., 135 (1988), p. 2952

[14] R. Rofagha, U. Erb, D. Ostrander, G. Palumbo, K.T. Aust, NanoStruct. Mater., 2 (1993), p. 1

[15] T. Burchardt, Hydrog. Energ., 26, (2001), p. 1193

[16] P.H.Cheng, W.Y.Xu, L.Q.Hua, Z.Y.Zhang, X.J.Wan, Plat.Surf.Finish, 85 (2), (1998)

[17] D.H. Jeong, U. Erb, K.T. Aust, G. Palumbo, Script. Mater., 48 (2003), p. 1067

[18] T.M. Harris, Q. Dany, J.Electrochem.Soc.140 (1993) p.81

[19] T.Morikawa, T.Nakade, M.Yokoi, Y.Fukumoto, C.Iwakura , Electrochim. Acta., 42, (1997), p.115

[20] Garcia, J. Fransaer, J.-P. Celis, Surf. Coat. Technol., 148 (2001) p.171

[21] B. Gillot, K. El Amri, P. Pouderoux, A. Rousset, J. Alloys Compd., 189 (1992) p.151

[22] D. Gierlotka, E. Rowinski, A. Budniok, E. Lagiewka, J. Appl. Electrochem., 27 (1997) p.1349

[23] G.R. Lakshminarayanan, E.S. Chen, F.K. Sautter, Plat. Surf. Fin, 63 (1976) p.38

[24] . G.W. Marshall, D.B. Lewis, D. Clayton, K. Blake, B. Dodds, Surf. Coat. Technol., 96 (1997) p.353

[25] Huichen Zhang, Mengxiong Zhang, Mater. Mech. Eng., 29 (1996) p.20

[26] A. Serek, A. Budniok, Curr. Appl. Phys., 2 (2002) p.193

[27] Y.L. Shi, Z. Yang, M.K. Li, H. Xu, H.L. Li, Mater. Chem. Phy., 87 (2004) p.154

[28] Y. Suzuki, S. Arai, M. Endo, J. Electrochem. Soc., 157 (2010) p.50

[29] D.B. Lewis, B.E. Dodds, G.W. Marshall, Special Publication-Royal Society of Chemistry (1997), 207 (Advances in Surface Engineering, Vol.) p 280

[30]] C.F. Malfati, H.M. Veit, T.L. Menezes, J. Zoppas Ferreira, J.S. Rodrigues, J.P. Bonino, Surf. Coat. Technol., 201 (2006) p.6318

[31] M.C. Chou, M.D. Ger, S.T. Ke, Y.R. Huang, S.T. Wu, Mater. Chem. Phys., 92 (2005) p.146

[32] S. Shawki, Z.A. Hamid, Anti-Corros. Meth. Mater., 44 (1997) p.178

[33] X. Changgeng, D. Zonggeng, Z. Lijun, Plat. Surf. Finish., 75 (1998) p.54

[34] D. Gierlotka, E. Rowinski, A. Budniok, E. Lagiewka, J. Appl. Electrochem., 27 (1997) p.1349

[35] C.F. Malfati, H.M. Veit, T.L. Menezes, J. Zoppas Ferreira, J.S. Rodrigues, J.P. Bonino, Surf. Coat. Technol., 201 (2006) p.6318

[36] D. Gierlotka, E. Rowinski, A. Budniok, E. Lagiewka, J. Appl. Electrochem., 27 (1997) p.1349

[37] Y.L. Shi, Z. Yang, M.K. Li, H. Xu, H.L. Li, Mater. Chem. Phy., 87 (2004) p.154

[38] Τεχνικό δελτίο Millenium Chemicals, Inc..

[39] The Merck Index, 12th Edition.

[40] International Labour Office. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Volumes I and II. New York: McGraw-Hill Book Co., 1971.

[51] S. Budavari, (ed.). The Merck Index - Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals. Rahway, NJ: Merck and Co., Inc., 1989.

[42] T.D. Luckey, B. Venugopal. Metal Toxicity in Mammals, 1. New York: Plenum Press, 1977.

[43] H.J. Trochimowicz, J. Appl. Toxicol. 8(6) (1988) 383.

[44] G.D. Clayton, F.E. Clayton (eds.). Patty's Industrial Hygiene and Toxicology: Vol. 2A,2B, 2C: Toxicology. 3rd ed. New York: John Wiley Sons, 1981-1982.

[45] L. Friberg, G.F. Nordberg, E. Kessler, V.B. Vouk, (eds). Handbook of the Toxicology of Metals. 2nd ed. Vols I, II.: Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1986.

[46] IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer,1972-PRESENT. (Multivolume work)., 322 (1989) p. 47.

[47] J. Muscat, V. Swamy, N.M. Harrison, *Phys. Rev. B* 65 (2002) 224112.

[48] T. Mitsuhashi, O.J. Kleppa, J. Am. Chem. Soc. 62 (1979) 356.

[49] R. Rodriguez, M.A. Blessa, A.E. Regazzoni, J. Col. Interf. Sci., 177 (1996) 2185.

Κεφάλαιο 3ο Φωτοκατάλυση με ΤίΟ2

3.1 Γενική Περιγραφή Φωτοκαταλυτικής Δράσης.

Η διεργασία της φωτοκατάλυσης έχει ως βάση το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και έλαβε σημαντική ώθηση με τη δημιουργία φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας (Σχήμα 3.1) από τους Fujishima και Honda το 1972 [1]. Η προσπάθεια της φωτοκαταλυτικής διάσπασης του νερού στα στοιχεία του, ξεκίνησε με έναυσμα τις ανάλογες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη φύση. Τα ίδια τα φυτά οξειδώνουν το νερό και ανάγουν το διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διεργασία της φωτοσύνθεσης.



Σχήμα 3.1. Σχηματικό διάγραμμα της φωτοηλεκτροχημικής κυψελίδας για τη «λύση» του νερού [2]: (1) φωτοηλεκτρόδιο TiO₂, (2) αντίθετο ηλεκτρόδιο πλατίνας, (3) πορώδης μεμβράνη, (4) ογκομετρικός κύλινδρος, (5) αντίσταση και (6) βολτόμετρο.

Σύμφωνα με τους πρωτοπόρους Fujishima και Honda, όταν το ηλεκτρόδιο της τιτανίας φωτιζόταν από φωτόνια με μήκη κύματος κάτω των 415 nm, παρατηρήθηκε η διέλευση ρεύματος από το αντίθετο

ηλεκτφόδιο πφος το ηλεκτφόδιο του ημιαγωγού. Μάλιστα η φοφά του φεύματος υποδεικνύει ότι μοφιακό οξυγόνο παφάγεται στην τιτανία (TiO₂), ενώ υδφογόνο εκλύεται στο ηλεκτφόδιο της πλατίνας. Έτσι, αποδείχθηκε ότι η αποτελεσματική μετατφοπή ενέφγειας από φωτεινή σε χημική είναι εφικτή και μάλιστα χωφίς την εφαφμογή εξωτεφικού δυναμικού.

Η πεφαιτέφω ανάπτυξη της χημείας ημιαγωγών που έλαβε χώφα τα τελευταία χρόνια ώθησε όσο τίποτα άλλο την ανάπτυξη των φωτοκαταλυτικών εφαρμογών [3]. Παράλληλα, τα προβλήματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, που ανέκυψαν [4], απαιτούν την άμεση και αποτελεσματική επίλυση τους, και μάλιστα με σχετικά χαμηλό κόστος. Για τους παραπάνω λόγους, η φωτοκαταλυτική τεχνολογία αναπτύχθηκε και μάλιστα αποδείχθηκε ότι το διοξείδιο του τιτανίου αποτελεί έναν εξαιρετικό ημιαγωγό για την αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων σε υδατική ή αέρια φάση [5-14], για την καταστροφή βακτηρίων [15] και ιών [16], για την αδρανοποίηση καρκινικών κυττάρων [17-18] και για την αντιμετώπιση πετρελαϊκών κηλίδων [19-20].

Το πλεονέκτημα του TiO² ως φωτοκαταλύτη βασίζεται στη μεγάλη διαθεσιμότητα του υλικού, τη μεγάλη του σταθερότητα και το μικρό του κόστος. Ωστόσο, η μεγάλη του απόδοση και ικανότητα να αποικοδομεί τις οργανικές ενώσεις το καθιέρωσε ως την πιο σύγχρονη «Προχωρημένη Οξειδωτική Μέθοδο Αντιρρύπανσης (Advanced Oxidation Process, AOP)». Μία πρώτη προσέγγιση της φωτοκαταλυτικής διεργασίας υποδεικνύει ότι σημασία έχει το μήκος κύματος των φωτονίων που προσπίπτουν στον ημιαγωγό, και όχι τόσο η συνολική ένταση του φωτός [10]. Έτσι, σε ένα συνηθισμένο δωμάτιο με φωτισμό συνολικής έντασης 10 μW.cm⁻², η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας, που θα μπορούσε να προκαλέσει την διέγερση φωτοηλεκτρονίων, βρίσκεται στα επίπεδα του 1 μW.cm⁻². Υποθέτοντας ότι μόνο το 25% των «ικανών» φωτονίων ποδεικνύεται ότι ένα
στρώμα υδρογονανθράκων περίπου 1 μm πάχους μπορεί αποτελεσματικά να μετατραπεί σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό μέσα σε χρονικό διάστημα μίας ώρας [10]. Αν κανείς αναλογιστεί ότι οι ρύποι εναποτίθενται σταδιακά στις επιφάνειες και ότι ένα υμένιο μπορεί αποτελεσματικά να καταστρέφει ρύπους «εν τω γεννάσθαι», τότε είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες της φωτοκαταλυτικής τεχνολογίας.

3.2 Μηχανισμός Φωτοκατάλυσης Διοξειδίου του Τιτανίου.

Το γενικό περίγραμμα του μηχανισμού της φωτοκατάλυσης φαίνεται στο σχήμα 3.2:



Το βασικό στάδιο του μηχανισμού της φωτοκαταλυτικής διεργασίας σε νανοσωματίδια διοξειδίου του τιτανίου περιλαμβάνει την απορρόφηση φωτονίου με την απαραίτητη ενέργεια ($E_{hv} \ge E_g = 3.2 \text{ eV} \Rightarrow \lambda \le 387.5 \text{ nm}$). Αμέσως, ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους του ημιαγωγού διεγείρονται στη ζώνη αγωγιμότητας, δημιουογώντας ζεύγος αντίθετα φοοτισμένων φωτοεπαγόμενων φοοτίων (φωτοηλεκτοόνια ecb και θετικές οπές hvb⁺, στη ζώνη αγωγιμότητας CB και τη ζώνη σθένους VB αντίστοιχα). Τα φοοτία αυτά μπορούν να «ταξιδέψουν» στην επιφάνεια του ημιαγωγού, λόγω του εκτεταμένου δικτύου δεσμικών και αντιδεσμικών τροχιακών του νανοσωματιδίου. Η κινητικότητά τους, ωστόσο, διαφέρει αισθητά και θα αναλυθεί διεξοδικά στη συνέχεια. Τα φωτοεπαγόμενα φορτία μπορούν στη συνέχεια να αντιδράσουν επιφανειακά με μοριακό οξυγόνο (διοξυγόνο) και νερό, σχηματίζοντας δραστικές οξειδωτικές ρίζες σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

$$e_{CB^-} + O_2 \rightarrow O_2$$
. (Eξίσωση 3-1)

$$h_{VB^+} + H_2O \rightarrow H^+ + OH \cdot$$
 (Eξίσωση 3-2)

Οι ελεύθερες ρίζες, που δημιουργούνται, έχουν το απαραίτητο δυναμικό οξείδωσης για την αποικοδόμηση σχεδόν όλων των οργανικών μορίων προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η αποικοδόμηση δεν γίνεται παρά σε αρκετά ενδιάμεσα στάδια, τελικά προϊόντα ωστόσο παραμένουν ανόργανα μόρια και ιόντα. Η οξειδωτική ισχύς μερικών οξειδωτικών μέσων (πίνακας 3.1) αποκαλύπτει την ισχύ της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης.

Οξειδωτικό	Δυναμικό (V)	Οξειδωτικό	Δυναμικό (V)	
	(vs NHE)		(vs NHE)	
F2	3.03	MnO4 ⁻	1.68	
ОН∙	2.80	ClO2 ⁻	1.57	
O ⁻	2.42	HClO	1.49	
O ₃	2.07	Cl2	1.36	
H2O2	1.78	Br ₂	1.09	
Δυναμικό αναγωγής Ο₂/Ο₂⊷ -0.28V				

Πίνακας 3.1. Δυναμικό οξείδωσης διαφόρων οξειδωτικών ουσιών [21]

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να προκαλέσουν φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπων ακόμα και σε απόσταση 500 μm από την επιφάνεια του διοξειδίου του τιτανίου [22]. Όπως ήταν ωστόσο αναμενόμενο, η ταχύτητα της αντίδρασης είναι σαφώς μειωμένη σε αυτές τις αποστάσεις. Μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι ανάλογο παρουσία ή απουσία νερού, υποδεικνύοντας ότι η ελεύθερη ρίζα που ενδεχομένως εμπλέκεται σε αυτές τις αποστάσεις, είναι η ανιονική ρίζα του οξυγόνου O_2^{-} . Ανάλογα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί κατά την καταστροφή βακτηριακών πληθυσμών σε αποστάσεις 50 μm [23] από την επιφάνεια του ημιαγωγού. Στην τελευταία περίπτωση δραστικό οξειδωτικό θεωρείται το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H₂O₂), το οποίο μπορεί να σχηματιστεί τόσο από φωτοηλεκτρόνια ece⁻ όσο και οπές hyp⁺σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

$$2e_{CB^-} + O_2 + 2H^+ → H_2O_2$$
 (Εξίσωση 3-3)
 $2h_{VB^+} + 2H_2O → 2H^+ + H_2O_2$ (Εξίσωση 3-4)

Σημαντική παφάμετφος της φωτοκαταλυτικής διεφγασίας αποτελεί ο χφόνος ζωής των διάφοφων ειδών που εμπλέκονται. Με τον τφόπο αυτό αξιολογείται η σταθεφότητά τους άφα και ο βαθμός εμπλοκής τους στα διάφοφα στάδια του μηχανισμού. Πειφάματα με βφαχύβιους παλμούς laser, αποκαλύπτουν στον πίνακα 3.2 τα παφακάτω δεδομένα [24-25].

Πίνακας 3.2. Χαρακτηριστικοί χρόνοι ζωής των διαφόρων χημικών μορφών που εμπλέκονται στο φωτοκαταλυτικό μηχανισμό.

Διεργασία	Χαρακτηριστικοί χρόνοι
Διαχωρισμός φορτίων	
$TiO_2 + hv \rightarrow TiO_2 (e_{CB^-} + h_{VB^+})$	fs
Παγίδευση φορτίων (charge - carrier trapping)	
h_{VB^+} +Ti-O-Ti ^{IV} -OH \rightarrow Ti-O-Ti ^{IV} -OH·+	10 ns
e_{CB^-} +Ti-O-Ti ^{IV} -OH \rightarrow Ti-O-Ti ^{III} -OH	100 ps
Επανασύνδεση φορτίων (charge - carrier recombination)	
h_{VB^+} +Ti-O-Ti ^{III} -OH \rightarrow Ti-O-Ti ^{IV} -OH	10 ns
e_{CB^-} +Ti-O-Ti ^{IV} -OH·+ \rightarrow Ti-O-Ti ^{IV} -OH	100 ns
Διεπιφανειακή μεταφορά φορτίου	
Τi-O-Ti ^{IV} -OH·⁺ + Αναγωγικό → Ti-O-Ti ^{IV} -OH + Αναγωγικό·⁺	100 ns
ecb⁻ + οξειδωτικό → οξειδωτικό⁻	ms

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα διεγερμένα φωτοηλεκτρόνια μπορούν, κατά το ταξίδι τους προς τη διεπιφάνεια νανοσωματιδίου – υγρής (ή αέριας) φάσης, να παγιδευτούν από κατιόντα Ti^{iv} του κρυσταλλικού πλέγματος σύμφωνα με την αντίδραση:

$$e_{CB^-} + \dots - O - Ti^{IV} - O - \dots \rightarrow - O - Ti^{III} - O - (E\xi i \sigma \omega \sigma \eta 3 - 5)$$

Τα φωτοηλεκτοόνια που παγιδεύονται με αυτόν τον τοόπο βοίσκονται ενεογειακά σε επίπεδο πεοίπου 25 - 50 meV χαμηλότεοα της ζώνης αγωγιμότητας [24]. Με δεδομένο ότι η συχνότητα των φωτονίων μποοεί να ποοκαλέσει διέγεοση στην ανώτεοη ζώνη αλλά και ότι το θεομικό πεοιεχόμενο του ηλεκτοονίου σε θεομοκοασία 25℃ είναι 26 meV μποοούμε να θεωοήσουμε ότι ποακτικά δεν λαμβάνει χώοα αντίδοαση παγίδευσης με αυτόν τον τοόπο [25].

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποδεικνύεται ότι η απόδοση του φωτοκαταλυτικού μηχανισμού εξαρτάται από δύο κυρίως διεργασίες: την επανασύνδεση ή την παγίδευση των αντίθετων φωτοεπαγόμενων φορτίων και την διεπιφανειακή μεταφορά φορτίου προς δημιουργία των ιδιαίτερα οξειδωτικών ελευθέρων ριζών. Η ρύθμιση σε κάποιον από αυτούς τους παράγοντες προκαλεί κατακόρυφη αύξηση της κβαντικής απόδοσης, δηλαδή του ποσοστού μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε χημική. Η υψηλή απόδοση της εμπορικής σκόνης TiO2 Degussa P25 σε σχέση με άλλα εμπορικά σκευάσματα, αποδίδεται στη χαμηλή ταχύτητα ανασυνδυασμού των φορέων φορτίου. Μάλιστα, προτείνεται ότι ο χαμηλός ουθμός ανασυνδυασμού οφείλεται στη συνύπαοξη δύο κουσταλλικών φάσεων (ανατάσης και οουτίλιο) σε ποσοστό (κ.β.) 75% -25% [26]. Ως γενική θεώρηση, σημειώνεται ότι ο τρόπος παρασκευής και ακινητοποίησης του ημιαγωγού καθορίζει δραστικά τη φωτοκαταλυτική συμπεριφορά του. Οι χρόνοι επανασύνδεσης, διάχυσης και διαχωρισμού των φορτίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις κρυσταλλικές ατέλειες

του πλέγματος, την κουσταλλική φάση, ακόμα και από την ύπαοξη οωγμών ή άλλων επιφανειακών ατελειών.

Στην περιγραφή του μηχανισμού της φωτοκατάλυσης θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη δράση των θετικά φορτισμένων οπών, αφού πολλά από τα οργανικά μόρια, τα οποία έχουν εξεταστεί, εμφανίζουν εκτεταμένο βαθμό υδροξυλίωσης στην πορεία τους προς ανόργανες μορφές [27-28]. Αυτή η υδροξυλίωση είναι ενδεικτική της προσβολής από ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου ΟΗ·, οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται από την αλληλεπίδραση νερού με τις φωτοεπαγόμενες θετικές οπές hv^{β+}. Μάλιστα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι αντιδράσεις αποικοδόμησης προχωρούν ταχύτερα στην περίπτωση της άμεσης αλληλεπίδρασης των οπών με το ρύπο, παρά στην περίπτωση της ενδιάμεσης δημιουργίας ελευθέρων ριζών υδροξυλίου [29].

Κατά τη διάφκεια της φωτοκαταλυτικής διεφγασίας έχουν αναφεφθεί και άλλες δφαστικές ελεύθεφες φίζες, που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση των μοφίων – στόχων. Αυτές οφείλονται κυφίως στην αλληλεπίδφαση της φίζας O_2 ·· με τα πεφιβάλλοντα μόφια και την μετατφοπή της σε φίζες O·, O· και O_3 ·· [30-33]. Η παφουσία των φιζών αυτών έχει μελετηθεί τόσο με μεθόδους φασματοσκοπίας ηλεκτφονιακού παφαμαγνητικού συντονισμού (*Electron Paramagnetic Resonance, EPR*) [34-35] όσο και με μεθόδους φθοφισμού – φωταύγειας [36-37]. Κατά τη μελέτη των αλληλεπιδφάσεων της ανιονικής φίζας οξυγόνου O_2 ·· με άλλα μόφια επισημαίνεται ότι η φίζα αυτή έχει μεγάλο χφόνο ζωής στην επιφάνεια του ημιαγωγού (έως και 1 min! [37]) αφού μποφεί εύκολα να πφωτονιώνεται σύμφωνα με την αντίδφαση (2-6):

 $H^+ + O_2 - \leftrightarrows HO_2 - pK_a(HO_2) = 4.88$ (ESigway 3-6)

Στον πίνακα 3.1, η τιμή του δυναμικού αναγωγής O₂- φανερώνει ότι η ρίζα αυτή δεν έχει την απαραίτητη «δύναμη» ώστε να οξειδώσει το

πλήθος των οργανικών ενώσεων. Μία τέτοια διαπίστωση ανάγει τις θετικές οπές σε κύριο εκφραστή της οξειδωτικής ισχύος στις φωτοκαταλυτικές διεργασίες. Ωστόσο το συμπέρασμα είναι μάλλον βεβιασμένο, αφού είναι πειραματικά αποδεδειγμένο ότι στην περίπτωση που η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση οργανικού ρύπου γίνεται απουσία μοριακού οξυγόνου, τότε προχωρά με σαφώς βραδύτερο ρυθμό. Η παρουσία του Ο2 είναι σημαντική διότι δεσμεύοντας τα φωτοεπαγόμενα e⁻ , διευκολύνει το διαχωρισμό των φορέων φορτίου (ecb⁻ και hvb⁺). Οι ρίζες Ο2⁻⁻ βασίζουν την οξειδωτική τους ισχύ και στο μετασχηματισμό τους σε υπεροξείδιο του υδρογόνου, σύμφωνα με τις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα [38-39]:

$$HO_{2} + O_{2} + H^{+} \rightarrow H_{2}O_{2} + O_{2}$$
(Eξίσωση 3-7)

$$HO_{2} + HO_{2} \rightarrow H_{2}O_{2} + O_{2}$$
(ESíowong 3-8)

$$O_{2^{\star^{-}}} + O_{2^{\star^{-}}} + 2H^{\star} \rightarrow H_2O_2 + O_2 \qquad (E\xi i\sigma\omega\sigma\eta 3-9)$$

Η κατεργασία ενός διαλύματος με υπεροξείδιο του υδρογόνου προκαλεί μη αντιστρεπτή οξείδωση του οργανικού φορτίου, για αυτό και η μέθοδος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις «Προχωρημένες Οξειδωτικές Μεθόδους Αντιρρύπανσης (Advanced Oxidation Process, AOP)». Έτσι, η δράση της ρίζας Ο2⁻⁻ δεν υποτιμάται στη φωτοκαταλυτική διεργασία, αντίθετα συνεκτιμάται στη συνολική αποικοδόμηση των οργανικών ρύπων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ικανότητα του διοξειδίου του τιτανίου να αποικοδομεί οργανικούς ρύπους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεργασία δημιουργίας φωτοεπαγόμενων ζευγών φορτίων, ούτε από την αποτελεσματική μετατροπή τους σε οξειδωτικές ρίζες. Η φωτοκατάλυση διέπεται, επίσης, από τις αρχές της ετερογενούς κατάλυσης. Επομένως, τα επιφανειακά χαρακτηριστικά υμενίων

διοξειδίου του τιτανίου διαδοαματίζουν καθοριστικό ρόλο στην συνολική απόδοση της φωτοκαταλυτικής διεργασίας και θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων εφαρμογών. Βιβλιογραφικά, δεν γίνεται αναφορά, ταυτόχρονα, στις ημιαγωγικές ιδιότητες των νανοκουσταλλικών σωματιδίων και στο συνολικό ανάπτυγμα της επιφάνειας της τιτανίας. Στα πλαίσια της διδακτορικής αυτής διατριβής γίνεται εκτεταμένη αναφορά τόσο στα φασματοσκοπικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την δομή και τις οπτικές – ηλεκτοικές ιδιότητες του ημιαγωγού, όσο και στα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, τα οποία σχετίζονται με την διαθέσιμη επιφάνεια για ετερογενείς διεργασίες. Μάλιστα, όπως θα περιγραφεί εκτεταμένα στις επόμενες ενότητες, η επιλογή της μεθόδου παρασκευής νανοδομημένης τιτανίας ακολουθεί δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (sol gel παρασκευή και πάστες εμπορικής σκόνης). Επιπλέον, συντέθηκε τιτανία σε αφρώδη διαμόρφωση ώστε να γίνει εκμετάλλευση του πορώδους και της μεγάλης ειδικής επιφάνειας ιδιαίτερου της συγκεκριμένης αυτής δομής. Η προσπάθεια αυτή έχει ως σκοπό να συνδυάσει τόσο τη δημιουργία υλικών με νανοδομημένα χαρακτηριστικά χωρίς ατέλειες, όσο και την αύξηση της τραχύτητας - πολυπλοκότητας της ημιαγωγικής επιφάνειας. Η τελευταία προσέγγιση εμφανίζεται ως η πλέον ενδεδειγμένη για την παρασκευή νανοδομημένης τιτανίας για περιβαλλοντικές εφαρμογές.

3.3 Χημική Τροποποίηση Διοξειδίου του Τιτανίου - Φωτοκατάλυση.

Η ανάγκη για αυξημένη απόδοση υμενίων ή εναιωφημάτων διοξειδίου του τιτανίου για πεφιβαλλοντικές εφαφμογές, ώθησε τη χημεία ημιαγωγών να αναζητήσει λύσεις τφοποποίησης του συγκεκφιμένου ημιαγωγού. Σκοπός της τφοποποίησης σε μοφιακό επίπεδο είναι είτε η μετατόπιση του ενεφγειακού χάσματος της τιτανίας στην πεφιοχή του οφατού, είτε η αύξηση του φυθμού της φωτοκαταλυτικής διάσπασης των οφγανικών φύπων. Η επιτυχία της αύξησης της φωτοκαταλυτικής απόδοσης βασίζεται σε έναν ή πεφισσότεφους από τους παφακάτω λόγους:

- Αποτελεσματική απορρόφηση φωτονίων.
- Αύξηση της επιφανειακής συγκέντοωσης φωτοεπαγόμενων φορτίων (hvb⁺ ή/και ecv⁻).
- Ελάττωση της τάσης επανασύνδεσης των φωτοεπαγόμενων
 ζευγών φορτίων.
- Ελάττωση των τιμών υπέφτασης (φφάγμα δυναμικού) κατά τη διεφγασία μεταφοφάς των οξειδωτικών μέσων στα πφοσφοφημένα, οφγανικά μόφια - στόχους.

Ο συνηθέστεφος τφόπος αύξησης της φωτοκαταλυτικής απόδοσης είναι η χημική τφοποποίηση της κφυσταλλικής μήτφας του διοξειδίου του τιτανίου με πφοσμίξεις μετάλλων μετάπτωσης [9, 40-44]. Ο τφόπος εισαγωγής των μεταλλοκατιόντων βασίζεται στη διεφγασία της παφασκευής των νανοσωματιδίων ή των υμενίων με τη μέθοδο λύματος – πηκτής (sol – gel). Έτσι, αν κατά την παφασκευαστική ποφεία διαλυθούν άλατα ή αλκοξείδια των επιθυμητών μετάλλων, ο ημιαγωγός που πφοκύπτει πεφιέχει στην κατάλληλη αναλογία μεταλλοκατιόντα στο κουσταλλικό του πλέγμα. Να σημειωθεί ότι η τοοποποίηση που λαμβάνει χώρα δεν είναι επιφανειακή αλλά αφορά όλη τη μάζα της τιτανίας.

Η απλή σχετικά εισαγωγή του μετάλλου στον ημιαγωγό ήταν το έναυσμα για την παρουσίαση αρκετών εργασιών στο χώρο αυτό. Έτσι αποδείχθηκε ότι ο Fe³⁺ παρεμποδίζει την επανασύνδεση του ζεύγους των αντίθετων φωτοεπαγόμενων φορτίων [45], ενώ προτάθηκε η συνεργιστική δράση μεταλλικών κατιόντων με αριθμό οξείδωσης μεγαλύτερο αυτού του τιτανίου (IV) [46].

Τα μεταλλικά ιόντα μπορούν να δράσουν σαν παγίδες φωτοηλεκτρονίων ή οπών σύμφωνα με τις παρακάτω αντιδράσεις [47-48]

:

$$M^{n+} + e_{CV^-} \rightarrow M^{(n-1)+}$$
 (E§. 3.10)

$$M^{n+} + h_{VB^+} \rightarrow M^{(n+1)+}$$
 (E§. 3.11)

Η παφαπάνω δφάση πφοϋποθέτει ότι το ενεφγειακό επίπεδο των μετάλλων μέσα στον κφύσταλλο βφίσκεται ανάμεσα στη ζώνη σθένους και στη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού.



Σχήμα 3.3. Διάγραμμα των ενεργειακών επιπέδων προσμίξεων μετάλλων μετάπτωσης σε κρύσταλλο ρουτιλίου [49].

Στο σχήμα 3.3 απεικονίζεται το ενεργειακό διάγραμμα για τις ενεργειακές στάθμες διαφόρων μεταλλοκατιόντων σε κρύσταλλο ουτιλίου. Αποτέλεσμα της ύπαρξης ενεργειακών επιπέδων ανάμεσα στη ζώνη αγωγιμότητας και τη ζώνη σθένους είναι ο ενεργειακά ευκολότερος διαχωρισμός φορτίων. Με τον τρόπο αυτό, παρατηρείται μία μετατόπιση του ενεργειακού χάσματος κατά μερικές δεκάδες νανόμετρα προς την ορατή περιοχή. Επομένως, η εισαγωγή επιλεγμένων μεταλλοκατιόντων μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα τον ευκολότερο διαχωρισμό φωτοεπαγόμενων φορτίων αλλά και τη μετατόπιση του ενεργειακού χάσματος (E_g) προς το εουθοό. Συνοπτικά, η δράση των μεταλλοκατιόντων μπορεί να παρασταθεί με την παρακάτω αλληλουχία αντιδράσεων:

Παγίδευση φορτίων (charge trapping)

$$M^{n+} + e_{CV} \rightarrow M^{(n-1)+}$$
 (E§. 3.12)

$$M^{n+} + h_{VB^+} \rightarrow M^{(n+1)+}$$
 (E§. 3.13)

Απελευθέρωση και διάχυση φορτίου

$$M^{(n-1)+} + Ti^{4+} \rightarrow M^{n+} + Ti^{3+}$$
 (E§. 3.14)

$$M^{(n+1)+} + H_2O \rightarrow M^{n+} + OH + H^+$$
 (E§. 3.15)

Επανασύνδεση φωτοεπαγόμενου φορτίου

$$M^{(n+1)+} + e_{CV} \rightarrow M^{n+}$$
 (E§. 3.16)

$$M^{(n-1)+} + h_{VB^+} \rightarrow M^{n+}$$
 (E§. 3.17)

Διεπιφανειακή μεταφορά φορτίου

$$e_{CV^-}$$
ή M⁽ⁿ⁻¹⁾⁺ + Οξειδωτικό → Οξειδωτικό⁻ + Mⁿ⁺ (Εξ. 3.18)

$$h_{VB^{+}} \dot{\eta} M^{(n+1)+} + A v \alpha \gamma \omega \gamma ι \kappa \acute{o} \rightarrow A v \alpha \gamma \omega \gamma ι \kappa \acute{o}^{+} + M^{n+}$$
(Εξ. 3.19)

Είναι προφανές από τις παραπάνω αντιδράσεις ότι το μεταλλοκατιόν μπορεί να δράσει ως «διαμεσολαβητής» (mediator), έτσι ώστε να διαχωριστούν αποτελεσματικότερα (και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) τα φωτοεπαγόμενα φορτία. Επιπλέον, οι θετικές οπές και τα φωτοηλεκτρόνια (hvb⁺ και ecv⁻) πλησιάζουν ταχύτερα στη διεπιφάνεια νανοσωματιδίου–ρευστού διαλύματος και αντιδρούν αποτελεσματικότερα προς σχηματισμό δραστικών μορφών.

Ενώ η αλληλεπίδοαση μετάλλων με το κουσταλλικό πλέγμα του TiO² εοευνήθηκε εκτεταμένα την τελευταία δεκαετία, η αντικατάσταση ατόμων οξυγόνου με ετεοοάτομα – αμέταλλα είναι ένα εοευνητικό πεδίο

που εμφανίστηκε την τελευταία χρονιά [50-55]. Η δραστηριότητα στον τομέα αυτό έχει ως αρχή μεθόδου την αντικατάσταση ενός μικρού ποσοστού ατόμων οξυγόνου με άζωτο (κυρίως) ή φώσφορο. Οι τροποποιημένος ημιαγωγός έχει μοριακό τύπο TiO2-xNx ή TiO2-xPx, όπου χ≤0.02. Το οξυγόνο, δηλαδή, εμφανίζεται σε υποστοιχειομετοία σε σχέση με τον αρχικό ημιαγωγό. Θεωρητικοί υπολογισμοί [56] και πειραματική επιβεβαίωση [53] υποδεικνύουν ότι στην περίπτωση του αζώτου τα 2p τροχιακά αναμιγνύονται με τα 2p τροχιακά των ατόμων του οξυγόνου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια προέκταση της ζώνης σθένους προς τη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού, ελαττώνοντας την ενέργεια που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί διαχωρισμός φορτίων. Η ελάττωση του ενεργειακού χάσματος υπολογίζεται σε 0.1 - 0.2 eV, ωστόσο είναι αρκετή για να μετατοπιστεί η περιοχή απόκρισης του ημιαγωγού κατά 50 nm μέσα στην ορατή περιοχή. Η θέση της ζώνης αγωγιμότητας της τιτανίας παραμένει ανεπηρέαστη. Τα ετεροάτομα του κρυσταλλικού πλέγματος δρουν ως σημεία επανασύνδεσης του φωτοεπαγόμενου ζεύγους φορτίων αλλά η ελάττωση του ενεργειακού χάσματος συντελεί ώστε να υπάρχει πολλαπλάσιος και αποτελεσματικότερος διαχωρισμός φορτίων. Αν και η παραπάνω δράση φαίνεται αντιφατική, το τελικό αποτέλεσμα είναι η ενεργοποίηση των φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων στην ορατή περιοχή.

Η αύξηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει ως βάση την τροποποίηση όλης της μάζας του ημιαγωγού και την εισαγωγή προσμίξεων στο κρυσταλλικό πλέγμα του διοξειδίου του τιτανίου. Η αλλαγή, επομένως, που επιφέρεται, είναι κατά το πλείστον, στις δομικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες του ημιαγωγού. Η επιφάνεια του υλικού παραμένει πρακτικά ανεπηρέαστη, αφού τα μεταλλικά ιόντα (ή αμέταλλα) που χρησιμοποιούνται στις συνθετικές πορείες βρίσκονται σε υποστοιχειομετρία σε σχέση με το αρχικό υλικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φωτοκατάλυση είναι και επιφανειακή διεργασία, η πειραματική προσέγγιση και συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής βασίζεται στην επιφανειακή τροποποίηση υμενίων με ευγενή μέταλλα. Με τον τρόπο αυτό, επηρεάζονται τόσο ο μηχανισμός της φωτοκαταλυτικής δράσης (φωτοεπαγόμενος διαχωρισμός φορτίων, σχηματισμός ελευθέρων ριζών), όσο και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των λεπτών υμενίων που παρασκευάζονται.

3.4 Γενική προσέγγιση περιβαλλοντικών εφαρμογών μεταλλικών επικαλύψεων Ni-P/TiO2

Η μελέτη της συμπεριφοράς των μεταλλικών επικαλύψεων Νi-P/TiO2 στην αποικοδόμηση οργανικών ρύπων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης των υλικών αυτών σε πρακτικές εφαρμογές. Η κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα βοηθήσει στην επιλογή των πλέον κατάλληλων μεθόδων, συνθηκών παρασκευής και ανάπτυξης υλικών για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Παράλληλα θα βοηθήσει σημαντικά στην διευκρίνιση, επιβεβαίωση και εμβάθυνση των μηχανισμών που διέπουν τις φωτοκαταλυτικές εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η βελτιστοποίηση της λειτουργίας και απόδοσης των αντίστοιχων διατάξεων και εφαρμογών. Επομένως, κρίνεται επιβεβλημένη η παράθεση και ανάλυση περιβαλλοντικών εφαρμογών παράλληλα με τους χαρακτηρισμούς που έγιναν σε επίπεδο υλικού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας της έρευνας που διεξάγεται στον τομέα των εφαρμογών περιβαλλοντικής σημασίας δεν έχει αναλυτικό χαρακτήρα (προσδιορισμός ενδιάμεσων προϊόντων φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης ούπων) αλλά επικεντοώνεται κυοίως στον φωτοκαταλύτη. Επίσης, επιχειρείται σε βάθος η συσχέτιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών των λεπτών υμενίων του ημιαγωγού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ακινητοποίηση του ημιαγωγικού υλικού σε αδρανές υπόστρωμα (αγώγιμο ή απλό γυαλί) με σκοπό να αναδειχτεί η σημασία αξία της φωτοκαταλυτικής επιφάνειας, και η η πολυδυναμικότητα και η πληθώρα των εφαρμογών. Στην προσπάθεια αξιολόγησης της φωτοκαταλυτικής ικανότητας των νέων υλικών οργανικός ρύπος χρησιμοποιήθηκε πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου (Methyl Orange, MO). Η αξιολόγηση με τη βοήθεια της χρωστικής πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου εξασφαλίζει φωτομετρικό προσδιορισμό υδατικών διαλυμάτων σε πολύ μικρές ποσότητες, ακόμα και σε επίπεδα ελάχιστων ppb.

Η ανάπτυξη του παφόντος κεφαλαίου δεν αποτελεί συμπλήφωμα του χαφακτηφισμού των νέων υλικών αλλά απόδειξη ότι η επέμβαση της χημείας ημιαγωγών σε επίπεδο νανοκλίμακας μποφεί να έχει άμεσα και εφαφμόσιμα αποτελέσματα. Η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση φύπων αποτελεί μία ευφεία κατηγοφία εφαφμογών, που τονίζουν την ικανότητα του διοξειδίου του τιτανίου να παφέχει δφαστικές λύσεις (πεφιβαλλοντική αποκατάσταση) σε συγκεκφιμένα πφοβλήματα.

3.5 Κινητική ανάλυση φωτοκαταλυτικής διεργασίας

Στη γενική θεώφηση μίας χημικής ισοφφοπίας (Εξ. 3-1) μποφεί να υπάφχει η καταλυτική επίδφαση ενός υλικού, οπότε μετασχηματίζεται στην εξίσωση (3-2):

 $A \leftrightarrows B \tag{E\xi. 3.1}$

$$A + Cat \leftrightarrows B + Cat$$
 (E§. 3.2)

Η απλούστερη περιγραφή μίας καταλυτικής διεργασίας είναι η αναφορά του φαινομένου κατά το οποίο ο καταλύτης (Cat) προστίθεται σε ένα χημικό σύστημα μεταβάλλοντας την ταχύτητα με την οποία το αποκαθιστά δυναμική, χημική ισορροπία. Μετά την σύστημα αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας ο καταλύτης μπορεί να διαχωριστεί με φυσικά ή χημικά μέσα, παραμένοντας αμετάβλητος τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Μία πιο προχωρημένη προσέγγιση του φαινομένου υιοθετεί το γεγονός ότι η καταλυτική δράση είναι σαφώς συνδεδεμένη με τα ενδιάμεσα στάδια που μεσολαβούν για να ολοκληρωθεί μία χημική αντίδραση. Η ολική ταχύτητα της αντίδρασης μεταβάλλεται προς μεγαλύτερες τιμές εάν το ενεργειακό περιεχόμενο όλων των ενδιάμεσων σταδίων παρουσία καταλύτη είναι μικρότερο σε σχέση με την αντίδραση απουσία καταλύτη. Η εισαγωγή του φωτός στις παραπάνω εξισώσεις δίνει τον ορισμό μιας φωτοκαταλυόμενης χημικής αντίδρασης:

$$A + Cat + hv \leftrightarrows B + Cat \qquad (E\xi. 3.3)$$

Η περιγραφή της φωτοκαταλυόμενης χημικής αντίδρασης με την παραπάνω χημική εξίσωση δεν προαπαιτεί την βαθιά γνώση του μηχανισμού με την οποία λαμβάνει χώρα η παραπάνω διεργασία. Μάλιστα δεν λαμβάνονται σε καμία περίπτωση ενδιάμεσα στάδια προσρόφησης ή εκρρόφησης στα ενεργά κέντρα του καταλύτη. Συνεπώς, για την περίπτωση των ετερογενών φωτοκαταλυτικών αντιδράσεων του διοξειδίου του τιτανίου πρέπει να περιγραφούν όλα τα ενδιάμεσα στάδια με κατάλληλα μοντέλα από τη χημεία των ετερογενώς καταλυόμενων αντιδράσεων. Τα μοντέλα, τα οποία έχουν επικρατήσει είναι η

φωτοκαταλυτική διεργασία των Eley – Rideal και η αντίστοιχη των Langmuir – Hinshelwood [57-58] :

Το μοντέλο των Eley - Rideal.

Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδοαση του φωτοκαταλύτη με το φως αλλά δεν ποοϋποθέτει τη φυσική ποοσοόφηση του ούπου στην επιφάνεια του καταλύτη.

{1}	$TiO2 + hv \rightarrow TiO2(e_{CV^-} + h_{VB^+})$	(Εξ. 3.4)
{2}	$S + {}_{\rm hVB^+} \longrightarrow S^+$	(Εξ. 3.5)
{3}	$S + + e_{CV} \rightarrow S$	(Εξ. 3.6)
{3 <i>α</i> }	$S \!$	(Εξ. 3.7)
{3β}	$S\text{+}+hv \rightarrow S\text{+}h_{VB^{+}}$	(Εξ. 3.8)
{4}	$S++M \rightarrow (S-M)^+$	(Εξ. 3.9)
<i>{5α}</i>	(S-M)+ → S ⁺ + προϊόντα	(Εξ. 3.10)
{5β}	(S-M)+ → S + προϊόντα	(Eξ. 3.11)

Το στάδιο {1} αναπαφιστά την αποφφόφηση φωτός από τον φωτοκαταλύτη με αποτέλεσμα την δημιουφγία φωτοεπαγόμενων αντίθετων φοφτίων ecv- και hvb⁺. Το στάδιο {2} πεφιγφάφει την δέσμευση των φοφέων φοφτίων (θετικών οπών hvb⁺) από δυνητικά επιφανειακά κέντφα S ώστε να δημιουφγηθούν τα ενεφγά κέντφα του φωτοκαταλύτη S⁺. Το στάδιο {3} αναφέφεται στον επανασύνδεση των φοφέων φοφτίου. Η αποδιέγεφση αυτή μποφεί να λάβει χώφα είτε θεφμικά (στάδιο {3α}) είτε μέσω φωτεινής αλληλεπίδφασης (στάδιο {3β}). Τα τελευταία στάδια του μηχανισμού αναπαφιστούν την αλληλεπίδφαση των ενεφγών κέντφων με μόφια – στόχους (M) δημιουφγώντας ένα ενδιάμεσο (S-M)⁺ (στάδιο {4}), το οποίο στη συνέχεια αποικοδομείται ελευθερώνοντας το ενεργό S+ (στάδιο {5α}) ή δυνητικά ενεργό (στάδιο {5β}) κέντρο S του φωτοκαταλύτη.

• Το μοντέλο των Langmuir – Hinshelwood

Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδοαση του φωτοκαταλύτη με το φως αλλά ποοϋποθέτει τη φυσική ποοσοόφηση του ούπου στην επιφάνεια του καταλύτη.

$$\{6\} \qquad M + S \rightarrow M_{ads} \qquad (E\xi. 3.11)$$

$$\{7\} \qquad M_{ads} \rightarrow M + S \qquad (E\xi, 3.12)$$

$$\{8\} \qquad TiO_2 + hv \rightarrow TiO_2(e_{CV} + (E\xi, 3.13) h_{VB})$$

$$\{9\} \qquad \qquad M_{ads} + h_{VB^+} \rightarrow M_{ads^+} \qquad (E\xi, 3.14)$$

$$\{10\} \qquad M_{ads}^{+} + e_{CV} \rightarrow M_{ads} \qquad (E\xi, 3.15)$$

$$\{11\} \qquad M_{ads}^+ \to \pi \varrho \ddot{o} \dot{o} v \tau \alpha + S \qquad (E\xi. 3.16)$$

Τα στάδια {6} και {7} περιγράφουν την προσρόφηση / εκρρόφηση ενός ρύπου M στο ενεργό επιφανειακό κέντρο S του φωτοκαταλύτη, προς σχηματισμού της προσροφημένης μορφής Mads. Η διεργασίες αυτές ακολουθούν ισορροπία Langmuir με σταθερά $K_L = k_6/k_7$, όπου k_6 και k_7 οι σταθερές ταχύτητας χημικών αντιδράσεων (Εξ. 3.11) και (Εξ. 3.12), αντίστοιχα. Το στάδιο {8} αναπαριστά τη διέγερση του φωτοκαταλύτη προς δημιουργία των φωτοεπαγόμενων αντίθετων φορτίων ecv⁻ και hv^{*}. Τα στάδια {9} και {10} περιγράφουν την παγίδευση (trapping) ενός φορέα φορτίου (θετικά φορτισμένα οπή) προς δημιουργία μίας δραστικής ελεύθερης ρίζας, η απόσβεση της οποίας γίνεται μέσω της αντίδρασης με τον αντίθετο φοφέα φοφτίου (επανασύνδεση φωτοηλεκτφονίου – οπής). Το τελευταίο στάδιο {11} αντιπφοσωπεύει τη χημική αντίδφαση, που αποδίδει τα πφοϊόντα οξείδωσης και επαναδημιουφγεί τα επιφανειακά ενεφγά κέντφα του φωτοκαταλύτη.

Και στα δύο μοντέλα, η κινητική περιγραφή της επιφανειακής συγκέντρωσης των φωτοεπαγόμενων αντίθετων φορτίων ecv⁻ και hvb⁺ δίνεται από τις σχέσεις (3.17) και (3.18) [3]:

$$[h_{VB^+}] = a_h \cdot \varrho \cdot \tau_h \tag{3.17}$$

$$[e_{CV}] = a_e \cdot \varrho \cdot \tau_e \tag{3.18}$$

όπου a_h και a_e είναι οι συντελεστές απορρόφησης φωτονίων του ημιαγωγού προς δημιουργία των φωτοεπαγόμενων h_{VB^+} και e_{CV^-} , αντίστοιχα, ρ είναι η φωτεινή ροή και $\tau_h - \tau_e$ είναι οι μέσοι χρόνοι ζωής των h_{VB^+} και e_{CV^-} .

Η κύρια διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα της φωτοκαταλυτικής ετερογενούς διεργασίας έγκειται στο γεγονός ότι το μοντέλο Langmuir -Hinshelwood θεωρεί τον ημιαγωγό ως μέσο απορρόφησης φωτός αλλά ακόμα σημαντικότερα ως μέσο προσρόφησης των μορίων - στόχων. Η φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση λαμβάνει, δηλαδή, χώρα αφού το μόριο ούπος προσκολληθεί στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Αντίθετα στο μοντέλο των Eley – Rideal, το μόριο-στόχος αλληλεπιδρά, χωρίς ενδιάμεσο βήμα προσρόφησης, κατ' ευθείαν με το διεγερμένο ενεργό κέντρο S⁺ προς τις αντίστοιχες οξειδωμένες μορφές. Αν και φαινομενικά η κινητική την παραμένει αδιάφορη για της ανάλυση ολική απόδοση φωτοκαταλυτικής διεργασίας όπως αυτή παρουσιάζεται στην αντίδραση (10-2), άμεσα εμφανίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση: Το μοντέλο των Langmuir – Hinshelwood (L-H) προβλέπει ότι η ταχύτητα της φωτοκαταλυτικής διεργασίας φτάνει ένα μέγιστο, όταν η συγκέντρωση του ρύπου λάβει μεγάλες τιμές. Στην περίπτωση αυτή τα ενεργά κέντρα είναι κατειλημμένα από τα μόρια του ρύπου και η όλη διεργασία καθορίζεται κινητικά από το βραδύ στάδιο της προσρόφησης – εκρρόφησης του ρύπου στην επιφάνεια του ημιαγωγού.

Αντίθετα, στο μοντέλο των Eley – Rideal (E-R) δεν τίθεται αυτός ο περιορισμός αφού η αντίδραση του ρύπου με την διεγερμένη κατάσταση του ημιαγωγού και η επακόλουθη εκρρόφησή του στο διάλυμα είναι πολλές τάξεις μεγέθους ταχύτερη της διεργασίας προσρόφησης – εκρρόφησης του ρύπου, όπως υποδηλώνει το μοντέλο L-H [4]. Στην πράξη, ο διαχωρισμός των δύο μηχανισμών είναι αρκετά δύσκολος με δεδομένο ότι σε κάποια χημικά συστήματα [5-6] οι σταθερές της κινητικής ανάλυσης δίνουν παρόμοια αποτελέσματα. Παρά την τελευταία παρατήρηση θεωρείται δεδομένο στην ανάλυση των φωτοκαταλυτικών κινητικών δεδομένων, ότι το μοντέλο L-H περιορίζεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις ρύπου, ενώ από την άλλη το μοντέλο E-R από τις αντίστοιχες υψηλές τιμές φωτεινής ροής.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 3

[1] A. Fujishima, K. Honda, *Nature*, 238 (1972) 37.

[2] A. Fujishima, D.A. Tryk, Functionality of Molecular Systems, K. Honda (Ed.), Vol. 2, Springer, Tokyo, 1999.

[3] A. Heller, Acc. Chem. Res., 14 (1981) 154.

[4] R. Rife, T.W. Thomas, D.W. Norberg, R.L. Fournier, F.G. Rinker, M.S. Bonomo, *Environ. Prog.*, 8 (1989) 167.

[5] D.F. Ollis, H. Al-Ekabi (Eds.): Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air, Elsevier, Amsterdam, 1993.

[6] D.M. Blake, Bibliography of Work on the Photocatalytic Removal of Hazardous Compounds from Water and Air, NREL, 1994.

[7] A. Mills, R.H. Davies, D. Worseley, Chem. Soc. Rev., 22 (1993) 417.

[8] P.V. Kamat, Chem. Rev., 93 (1993) 267.

[9] M.A. Fox, M.T. Dulay, Chem. Rev., 93 (1993) 341.

[10] A. Fujishima, T.N. Rao, D.A. Tryk, J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev., 1 (2000) 1.

[11] P. Pichat, *Catal. Today*, 19 (1994) 313.

[12] M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi, D.W. Bahnemann, *Chem. Rev.*, 95 (1995) 69.

[13] L.N. Lewis, Chem. Rev., 93 (1993) 2693.

[14] N. Serpone, M. Schiavello (Eds.), Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991.

[15] J.C. Ireland, P. Klostermann, E.W. Rice, R.M. Clark, *Appl. Environ. Microbiol.*, 59 (1993) 1668.

[16] J.C. Sjorgen, R.A. Sierka, Appl. Environ. Microbiol., 60 (1994) 344.

[17] H. Sakai, R. Baba, K. Hashimoto, Y. Kubota, A. Fujishima, *Chem. Lett.*, (1995) 185.

[18] R. Cai, Y. Kubota, T. Shuin, H. Sakai, K. Hashimoto, A. Fujishima, *Cancer Res.*, 52 (1992) 2346.

[19] M. Nair, Z.H. Luo, A. Heller, Ind. Eng. Chem. Res., 32 (1993) 2318.

[20] H. Gerischer, A. Heller, J. Electrochem. Soc., 139 (1992) 113.

[21] Α. Αρδίτσογλου, Ι. Πούλιος, Χημικά Χρονικά, 65(10) (2003) 40.

[22] T. Tatsuma, S. Tachibana, T. Miwa, D.A. Tryk, A. Fujishima, *J. Phys. Chem. B*, 103 (1999) 8033.

[23] T. Kikuchi, K. Sunada, T. Iyoda, K. Hashimoto, A. Fujishima, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.*, 106 (1997) 51.

[24] S.T. Martin, H. Herrmann, W. Choi, M.R. Hoffmann, *Trans. Faraday Soc.*, 90 (1994) 3315.

[25] S.T. Martin, H. Herrmann, M.R. Hoffmann, *Trans. Faraday Soc.*, 90 (1994) 3323.

[26] R.I. Bickley, T. Gonzalez-Carreno, J.S. Lees, L. Palmisano, R.J. Tilley, *J. Solid State Chem.*, 92 (1991) 178.

[27] V. Augugliaro, L. Palmisano, A. Sclafani, C. Minero, E. Pelizzetti, *Toxicol. Environ. Chem.*, 16 (1998) 89.

[28] V.A. Sakkas, I.M. Arabatzis, I.K. Konstantinou, A.D. Dimou, T.A. Albanis, P. Falaras, *Appl. Catal. B: Environ.*, 49 (2004) 195.

[29] K. Ishibashi, A. Fujishima, T. Watanabe, K. Hashimoto, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.*, 134 (2000) 139.

[30] J.R. Harbour, M.L. Hair, Adv. Colloid Interface Sci., 24 (1986) 103.

[31] R.F. Howe, M. Grätzel, J. Phys. Chem., 91 (1987) 3906.

[32] M. Anpo, K. Chiba, M. Tomonari, S. Coluccia, M. Che, M.A. Fox, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 64 (1991) 543.

[33] A. Sclafani, J.M. Herrmann, J. Phys. Chem., 100 (1996) 13655.

[34] Y. Nosaka, H. Fukuyama, Chem. Lett. (1997) 383.

[35] Y. Nosaka, Y. Yamashita, H. Fukuyama, J. Phys. Chem. B, 101 (1997) 5822.

[36] M. Nakano, M. Kikuyama, T. Hasegawa, T. Ito, K. Sakurai, K. Hiraishi, E. Hashimura, M. Adachi, *FEBS Lett.*, 372 (1995) 140.

[37] K. Ishibashi, Y. Nosaka, K. Hashimoto, A. Fujishima, *J. Phys. Chem. B*, 102(12) (1998) 2117.

[38] A. Linsebigler, G. Lu, J. T. Jr. Yates, J. Phys. Chem., 100 (1996) 6631.

[39] G. Lu, A. Linsebigler, J. T. Jr. Yates, J. Phys. Chem., 99 (1996) 7626.

[40] M.I. Litter, Appl. Catal. B : Environ., 23 (1999) 89.

[41] K. Rajeshwar, J. Appl. Electrochem., 25 (1995) 1067.

[42] N. Serpone, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 104 (1997) 1.

[43] Z. Luo, Q.-H. Gao, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 63 (1992) 367.

[44] W. Choi, A. Termin, M.R. Hoffmann, J. Phys. Chem., 98 (1994) 13669.

[45] J. Moser, M. Grätzel, R. Gallay, Helv. Chim. Acta, 70 (1987) 1596.

[46] K.E. Karakitsou, X.E. Verykios, J. Phys. Chem., 97 (1993) 1184.

[47] J. Soria, J.C. Conesa, V. Augugliaro, L. Palmisano, M. Schiavello, A.J. Sclafani, *Phys. Chem.*, 95 (1991) 274.

[48] Z. Luo, Q.-H. Gao, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 63 (1992) 367.

[49] P. Triggs, Helv. Phys. Acta, 58 (1985) 657.

[50] C. Burda, Y. Lou, X. Chen, A.C.S. Samia, J. Stout, J.L. Gole, *Nanoletters*, 3(8) (2003) 1049.

[51] H. Irie, Y. Watanabe, K. Hashimoto, J. Phys. Chem. B, ASAP article, in press.

[52] T. Ihara, M. Miyoshi, Y. Iriyama, O. Matsumoto, S. Sugihara, *Appl. Catal. B: Environ.*, 42 (2003) 403.

[53] T. Lindgren, J.M. Mwabora, E. Avendaño, J. Jonsson, A. Hoel, C.-G. Granqvist, S.-E. Lindquist, *J. Phys. Chem. B.*, 107 (2003) 5709.

[54] J.C. Yu, L. Zhang, Z. Zheng, J. Zhao, *Chem. Mater.*, 15 (2003) 2280.

[55] H. Irie, S. Washizuka, N. Yoshino, K. Hashimoto, *Chem. Comm.*, (2003) 1298.

[56] R. Asahi, T. Morikawa, T. Ohwaki, K. Aoki, Y. Taga, Science, 293 (2001) 269.

[57] C. Minero, Catal. Today 54(2-3) (1999) 205.

[58] D.F. Ollis, E. Pelizzetti, N. Serpone, Environ. Sci. Technol. 25(9) (1991) 1522.

Κεφάλαιο 4° Πειραματική Διαδικασία

4.1 Πειραματική διάταξη παρασκευής επικαλύψεων

Η πειραματική διάταξη στην οποία έλαβε χώρα η παρασκευή σύνθετων ηλεκτρολυτικών αποθεμάτων μήτρας Ni-P σε συνθήκες συνεχούς, αλλά και παλμικού ρεύματος παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1. Αναλυτικά η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει:

Ι. Μια γυάλινη ηλεκτρολυτική κυψελίδα (ηλεκτρολυτικό κελί) χωρητικότητας ενός λίτρου (1000ml). Η κυψελίδα είναι θερμοστατούμενη, με διπλό τοίχωμα που επιτρέπει την κυκλοφορία νερού η οποία διατηρείται με τη βοήθεια εξωτερικού κυκλώματος υδατόλουτρου στο οποίο ο θερμοστάτης ρυθμίστηκε στην τιμή των 65±1 °C.

ΙΙ. Κύκλωμα τριών ηλεκτροδίων:

- Ηλεκτρόδιο εργασίας (WE): στην προκειμένη περίπτωση είναι η κάθοδος η οποία είναι προσαρτημένη σε σύστημα μηχανικού αναδευτήρα που περιστρέφεται με ρυθμιζόμενη ταχύτητα.
- Ηλεκτρόδιο αναφοράς (RE): ως ηλεκτρόδιο αναφοράς χρησιμοποιείται πρότυπο ηλεκτρόδιο καλομέλανα (Standard Calomel Electrode, SCE) με σύσταση: KCl^{κορ}Hg₂Cl₂ |Hg₂Cl_{2σ}| Hg και δυναμικό ως προς το ηλεκτρόδιο υδρογόνου ίσο με +0.24 Volts.
- Ηλεκτρόδιο μέτρησης (CE): ως ηλεκτρόδιο μέτρησης (άνοδος) χρησιμοποιείται κυλινδρική πλάκα νικελίου καθαρότητας 99,9%, η οποία είναι τοποθετημένη πλευρικά στο εσωτερικό τοίχωμα της ηλεκτρολυτικής κυψελίδας και έχει ύψος περίπου ίσο με το μισό του ύψους της κυψελίδας. Η συνολική επιφάνεια της ανόδου είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή της καθόδου, προκειμένου να

διευκολύνεται η διάλυσή της και να αποφεύγονται τα φαινόμενα πόλωσης.



Σχήμα 4.1. Σχηματική αναπαφάσταση πειφαματικής διάταξης ηλεκτφολυτική απόθεσης [1]

III. Έναν Ποτενσιοστάτη, τύπου Wenking PGS, μοντέλο ST 88. Ο ποτενσιοστάτης διαθέτει ενσωματωμένο αμπερόμετρο αναλογικής ένδειξης, με κλίμακα 0,1mA – 3A. Το εφαρμοζόμενο δυναμικό, καθώς και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την ηλεκτρολυτική κυψελίδα ελέγχονται συγχρόνως από ένα βολτόμετρο, το οποίο συνδέεται παράλληλα στο κύκλωμα, και ένα αμπερόμετρο, που παρεμβάλλεται κατά σειρά στο κύκλωμα.

IV. Μια Γεννήτρια Παλμών, τύπου Wenking, μοντέλο DPC 72. Η γεννήτοια αυτή έχει τη δυνατότητα παραγωγής απλών αλλά και διπλών τετραγωνικών παλμών, οι οποίοι επιβάλλονται στα ηλεκτρόδια υπό ποτενσιοστατικές συνθήκες. Κατά την επιβολή παλμικού ρεύματος, η γεννήτρια παράγει τετραγωνικούς παλμούς, τα χαρακτηριστικά των

οποίων (ύψος, πλάτος, συχνότητα και πολικότητα) καθορίζονται μέσω ειδικών ουθμίσεων της γεννήτοιας. Ο κάθε παλμός υπεοτίθεται σε ένα αρχικά ρυθμιζόμενο συνεχές δυναμικό (offset) το οποίο μπορεί να είναι συγκεκοιμένου ύψους, πλάτους, και πολικότητας. Οι επιβαλλόμενες τιμές σταθερού δυναμικού για το offset δυναμικό, καθώς και για τους υπερτιθέμενους σε αυτό παλμούς, μπορούν να μεταβάλλονται μεταξύ ΟV έως ±10V. Το πλάτος των τετραγωνικών παλμών μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών 1msec και 100msec, επομένως το duty cycle του εφαρμοζόμενου παλμικού ρεύματος μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 0% - 99%, ενώ η χρονική διάρκεια του offset δυναμικού μπορεί να μεταβάλλεται ανάμεσα στα 10msec και στα 1000msec, επομένως η περίοδος του εφαρμοζόμενου παλμικού ρεύματος μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10⁻² – 10² Ηz.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες σειρές πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε ποτενσιοστάτης/γαλβανοστάτης/γεννήτρια παλμών της εταιρίας AUTOLAB μοντέλο PGSTAT302N προκειμένου να γίνει καταγραφή της καμπύλης ρεύματος/χρόνου μέσω Η/Υ.

V. Ορειχάλκινα δοκίμια (70% Cu, και 30% Zn), τα οποία αποτέλεσαν το αγώγιμο υπόστρωμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η απόθεση των επικαλύψεων Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυλινδρικά με διάμετρο 25mm και πάχος 15mm. Ποιν τη διαδικασία της ηλεκτοοαπόθεσης, υποβλήθηκαν σε μηχανικό καθαρισμό, στίλβωση και λείανση με κατάλληλες βούρτσες. Στη συνέχεια υπέστησαν καθαρισμό σε σύστημα υπερήχων αρχικά σε ακετόνη και ακολούθως σε απιονισμένο νέρό, με στόχο την απομάκουνση των ακαθαρσιών που έμειναν στη επιφάνεια των δοκιμίων από την προκατεργασία. Προκειμένου να είναι ελεγχόμενη η επιφάνεια απόθεσης του μετάλλου, ακολούθησε μόνωση πλευοικής κυλινδοικής επιφάνειας των δοκιμίων της με θερμοσκληραινόμενο πλαστικό. Έπειτα από τα στάδια αυτά της

ποοκατεργασίας, η προκύπτουσα ελεύθερη επιφάνεια απόθεσης της καθόδου είχε εμβαδό ίσο με 0,049 dm². Για να ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της δομής, της μορφολογίας και των ιδιοτήτων των παραγόμενων δοκιμίων, οι χρόνοι απόθεσης υπολογίστηκαν έτσι ώστε το πάχος των αποθεμάτων να είναι μεγαλύτερο από 50μm.

4.2 Συνθήκες παφασκευής σύνθετων επικαλύψεων μήτφας Ni-P

4.2.1 Ηλεκτοολυτικό λουτοό

Το είδος και η σύσταση του ηλεκτρολυτικού λουτρού έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν βασικές παραμέτρους της ηλεκτρόλυσης και οποιαδήποτε μεταβολή τους επηρεάζει τόσο τη δομή όσο και τις ιδιότητες των παραγόμενων αποθεμάτων. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία όλες οι αποθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε τροποποιημένο λουτρό τύπου Watts (βλ. Πίνακα 4.1).

Η επίδραση καθενός από τα συστατικά του λουτρού Watts μελετήθηκε συστηματικά από αρκετούς ερευνητές και διαπιστώθηκε ότι:

- Η προσθήκη μεγαλύτερης συγκέντρωσης θειικού νικελίου σε σχέση
 με τα άλλα συστατικά οφείλεται στη σημαντική διαλυτότητά του
 [1].
- Η παρουσία των ιόντων χλωρίου στο ηλεκτρολυτικό λουτρό είναι απαραίτητη για την αποπαθητικοποίηση της ανόδου [2].
- Ο ρόλος του βορικού οξέος στο ηλεκτρολυτικό λουτρό Watts δεν περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση του pH, αλλά λειτουργεί και ως

καταλύτης, αφού ελαττώνει την υπέφταση του υδφογόνου κατά την ηλεκτφοαπόθεση του νικελίου [3].

 Το υποφωσφορώδες νάτριο έχει το ρόλο της πηγής φωσφόρου για την ηλεκτροαπόθεση του κράματος Ni-P. Αν και στην περίπτωση της ηλεκτροαπόθεσης συνήθως χρησιμοποιείται ως πηγή φωσφόρου το H₃PO₃, το H₂PO₂⁻ έχει προταθεί ως ενδιάμεσο προϊόν κατά την αναγωγή του οξέος σε φώσφορο [4]. Καθώς λοιπόν η απ' ευθείας αναγωγή του υποφωσφορώδους σε φώσφορο απαιτεί ένα ηλεκτρόνιο, η διαδικασία της ηλεκτροαπόθεσης ελέγχεται πιο εύκολα [5].

Σύνθεση λουτρού NiSO4·6H2O 330 g L-1 35 g L⁻¹ NiCl₂·6H₂O H₃BO₃ 40 g L⁻¹ NaH₂PO₂·H₂O 10,8 g L⁻¹ 50 g L⁻¹ και 100 g L⁻¹ Σωματίδια TiO₂ (μέση διάμετοος 21nm) Συνθήκες ηλεκτρόλυσης 2,50 pН Θεομοκοασία 65 °C Υπόστρωμα Ορειχάλκινοι δίσκοι (διαμέτοου 25 mm) Περιστροφή καθόδου (ω) 700 rpm Άνοδος Πλάκα Ni (99,9%) 250 rpm Μαγνητική ανάδευση 6 A dm⁻² Πυκνότητα οεύματος Συνεχές (DC), Παλμικό (PC) Τύπος οεύματος Duty cycle (d.c.) 50% Συχνότητα (ν) 0,1, 1, 10, 100 Hz

Πίνακας 4.1. Σύσταση τροποποιημένου λουτρού Watts και συνθήκες ηλεκτρόλυσης.

4.2.2 Συνθήκες ηλεκτρόλυσης – πόλωσης ηλεκτρολυτικής κυψελίδας

Οι συνθήκες ηλεκτοόλυσης καθορίστηκαν με βάση ποοκαταρκτικά πειράματα καθώς και από τη μελέτη της βιβλιογραφίας [1]. Η θερμοκρασία του λουτρού διατηρήθηκε σταθερή στους 65 °C. Επίσης η τιμή του pH ήταν 2.5 ενώ οι μικρές μεταβολές που δημιουργούνταν μετά από κάθε απόθεση διορθωνόντουσαν με προσθήκη διαλυμάτων NH₃ και H₂SO₄. Η πυκνότητα ρεύματος ήταν 6 A/dm². Η τιμή γωνιακής ταχύτητας της περιστρεφόμενης καθόδου διατηρήθηκε σταθερή στις 700 rpm. Τέλος, στις σύνθετες επικαλύψεις, προκειμένου τα ενισχυτικά σωματίδια TiO₂ να διατηρούνται σε αιώρηση και σε ομοιογενή διασπορά μέσα στο ηλεκτρολυτικό λουτρό, εφαρμόστηκε μαγνητική ανάδευση στον πυθμένα της κυψελίδας, με ταχύτητα περιστροφής 250 rpm, κατά την διάρκεια της ηλεκτρολυτικής αντίδρασης και για τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πρώτη απόθεση. Οι συνθήκες ηλεκτρόλυσης των επικαλύψεων παρουσιάζονται παραπάνω, στον πίνακα 4.1.

4.2.3 Ενισχυτικό - Φωτοκαταλυτικό μέσο σύνθετων επικαλύψεων

4.2.3.1 Διοξείδιο του τιτανίου (TiO2)

Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 3 το διοξείδιο του τιτανίου είναι ένα εμπορικό προϊόν το οποίο προέρχεται από την υδρόλυση του τετραχλωριδίου του τιτανίου και χρησιμοποιείται συχνά σε μελέτες λόγω των φωτοκαταλυτικών του ιδιοτήτων. Από τους προμηθευτές της σκόνης είναι γνωστό ότι η τιτανία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία

εμφανίζει δύο τρόπους κρυσταλλικής ανάπτυξης τον ανατάση και το ρουτίλιο σε ποσοστό αναλογίας 70:30 (βλ. πίνακα 2.1)

4.2.4 Θεομική κατεργασία επικαλύψεων

Όλες οι επικαλύψεις που παφασκευάστηκαν υποβλήθηκαν σε θεφμική κατεφγασία στους 400 °C. Μετά από κάθε κύκλο θέφμανσης οι επικαλύψεις εξεταζόντουσαν στο XRD. Η θεφμική κατεφγασία έγινε σε φούφνο υψηλών θεφμοκφασιών σε ατμόσφαιφα αέφα. Η αύξηση της θεφμοκφασίας είχε φυθμό 5 °C/min, ενώ τα δοκίμια διατηφήθηκαν στην εκάστοτε επιθυμητή θεφμοκφασία για μία ώφα. Τέλος, η ψύξη των δειγμάτων έγινε με φυσικό φυθμό.

4.3 Μέθοδοι χαφακτηφισμού δομής και μοφφολογίας των επικαλύψεων

4.3.1 Περίθλαση ακτίνων X (XRD)

Η περίθλαση ακτίνων X (XRD) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική, για την ταυτοποίηση κρυσταλλικών φάσεων που βρίσκονται σε υλικά, καθώς και για το χαρακτηρισμό τον δομικών χαρακτηριστικών αυτών των φάσεων (μέγεθος κρυστάλλων, εσωτερικές τάσεις, κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός, ατέλειες δομές).

Η εφαφμογή της μεθόδου της πεφίθλασης των ακτίνων Χ στηφίζεται στην αφχή σύμφωνα με την οποία, το φαινόμενο της πεφίθλασης ενός κύματος πφος μια οφισμένη διεύθυνση, εκδηλώνεται μόνον όταν:

 τα άτομα του κουσταλλικού πλέγματος πεοιθλούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία "σε φάση" προς τη διεύθυνση αυτή και,

το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι της ίδιας τάξης μεγέθους
 με τις αποστάσεις μεταξύ των ατόμων του πλέγματος [6].
 Η αρχή της μεθόδου παρουσιάζεται παραστατικά στο σχήμα 4.2.



Σχήμα 4.2. Βασικά χαρακτηριστικά μέτρησης περίθλασης ακτίνων Χ [7].

Στην περίπτωση κατά την οποία μονοχρωματική δέσμη ακτίνων Χ προσπίπτει σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα, το φαινόμενο της περίθλασης από μια οικογένεια κρυσταλλικών επιπέδων {hkl} εκδηλώνεται μόνον όταν ικανοποιείται η συνθήκη του Bragg. Έτσι λοιπόν, εάν θ είναι η γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας Χ πάνω σε μια συστοιχία παράλληλων επιπέδων {hkl}, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση dha το ένα από το άλλο θα συμβεί περίθλαση όταν ικανοποιηθεί η σχέση:

 $2 d_{hkl} \times \eta \mu \theta = n \times \lambda$ (Συνθήκη του Bragg) (Εξ. 4.1)

Όπου:

λ: το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Χ n: η τάξη περίθλασης, n = 1,2,3, ... Συνεπώς, προκειμένου να εκδηλωθεί το φαινόμενο της περίθλασης των ακτίνων Χ, θα πρέπει να ισχύει: dhkl > λ / 2

Στην παοούσα μεταπτυχιακή η μέθοδος εφαομόστηκε με χοήση περιθλασίμετρου ακτίνων Χ τύπου Siemens, μοντέλο D-5000, το οποίο αποτελείται από ένα καθοδικό σωλήνα με μονοχρωμάτορα γραφίτη και αντικάθοδο χαλκού (Cu-Ka) (Σχήμα 4.3).



Σχήμα 4.3. Θάλαμος τοποθέτησης δείγματος συσκευής XRD

4.3.2 Ηλεκτφονική μικφοσκοπία σάφωσης (SEM) – Φασματοσκοπία διαχεόμενης ενέφγειας (EDS)

Για τη μελέτη της δομής και της μοφφολογίας της επιφάνειας των σύνθετων αποθεμάτων, χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy, SEM). Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι της εταιρίας FEI, μοντέλο FEI QUANTA 200, με δυνατότητα εστίασης 3.5nm και ενσωματωμένη συσκευή μικροανάλυσης EDS (σχήμα 4.4). Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνονται μεγεθύνσεις οι οποίες κυμαίνονται από 10 έως και 3 x 105 φορές, ανάλογα με τον τύπο του οργάνου [7-10].



Σχήμα 4.4. Μικροσκόπιο SEM (FEI QUANTA 200) με προσαρμοσμένο σύστημα EDS.

Η λειτουργία του SEM στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις του προς εξέταση δείγματος και της προσπίπτουσας σε αυτό δέσμης ηλεκτρονίων. Οι βασικές διατάξεις που υπάρχουν στο μικροσκόπιο είναι το σύστημα παφαγωγής δέσμης ηλεκτφονίων, το σύστημα κατεύθυνσης της δέσμης, το σύστημα πληφοφοφιών και, τέλος, το σύστημα κενού (σχήμα 4.5).



Σχήμα 4.5. Σχηματική απεικόνιση της οργανολογίας του SEM.

Τα βασικά στάδια λειτουργίας ενός μικροσκοπίου είναι :

 Σχηματισμός δέσμης ηλεκτρονίων από την πηγή η οποία επιταχύνεται προς το δείγμα μέσω ενός θετικού ηλεκτρικού δυναμικού

 Εστίαση μονοχοωματικής δέσμης με χρήση μαγνητικών φακών και πηνίων, η οποία σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος.

 Αλληλεπίδραση δέσμης - δείγματος και καταγραφή των σημάτων από ανιχνευτές.

Πιο συγκεκοιμένα, η προσπίπτουσα δέσμη (πρωτογενής) προκαλεί την δευτερογενών ηλεκτρονίων (secondary electrons) εκπομπή και οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων (back scattered electrons). Επίσης εκπέμπονται ηλεκτρόνια που έχουν υποστεί ελαστική σκέδαση ή χαμηλή απώλεια ενέργειας, καθώς και ακτίνες Χ αλλά και φωταύγεια. Τα σήματα των δευτερογενών και των οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων ενισχύονται και στη συνέχεια καταγράφονται, με αποτέλεσμα τη μεγεθυσμένη απεικόνιση της επιφάνειας του δείγματος. Ανάλογα με την επιλογή του σήματος που θα επιλεχθεί για την αναπαραγωγή της εικόνας, αναδεικνύονται διαφορετικά χαρακτηριστικά του δείγματος, δεδομένου ότι τόσο η παραγωγή δευτερογενών ηλεκτρονίων όσο και ο συντελεστής οπισθοσκέδασης εξαρτώνται από τις τοπικές τιμές της γωνίας πρόσπτωσης (τοπογραφικά χαρακτηριστικά), τον ατομικό αριθμό (στοιχειακή ανάλυση) και τον κουσταλλογραφικό προσανατολισμό (κουσταλλογραφικά χαρακτηριστικά).

Όσον αφορά στη στοιχειακή ανάλυση των επικαλύψεων έγινε χρήση της φασματοσκοπίας διαχεόμενης ενέργειας, η οποία αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδο ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των υλικών. Η βασική αρχή της στηρίζεται στη συλλογή και στην ανίχνευση της ακτινοβολίας Χ, η οποία εκπέμπεται από ένα δοκίμιο κατά τη μελέτη του με τεχνική SEM. Τα δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μέτρηση συγκρίνονται με αντίστοιχα δεδομένα προτύπων δειγμάτων που βρίσκονται στην τράπεζα δεδομένων του λειτουργικού προγράμματος και ποοκύπτει η χημική ανάλυση του δείγματος. Στα επόμενα κεφάλαια τα δεδομένα είτε θα παρουσιάζονται με τη μορφή ενός ιστογράμματος της ενέργειας της ακτινοβολίας Χ που ανιχνεύτηκε (διάγραμμα EDS), είτε ως εικόνα χαρτογράφησης της υπό εξέταση επιφάνειας του δοκιμίου, στην οποία η επιφάνεια αναπαρίσταται ως μαύρη, ενώ το ζητούμενο στοιχείο αναπαρίσταται ως κουκίδα διαφορετικού χρώματος (τεχνική

χαφτογφάφησης-mapping). Το σημαντικότεφο μειονέκτημα της μεθόδου EDS είναι η αδυναμία της να ανιχνεύσει στοιχεία με μικφό ατομικό αφιθμό (Ζ≤8), ωστόσο η ακφίβεια της μεθόδου είναι αφκετά υψηλή με σφάλμα της τάξης ±1-3% [10-13].

4.4 Μέθοδοι προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων

4.4.1 Μικοοσκληρότητα μεταλλικής επιφάνειας

Με τον όρο σκληρότητα μιας μεταλλικής επιφάνειας εκφράζεται η ολική αντίσταση που προβάλλει η ύλη σε κάθε προσπάθεια μόνιμης παραμόρφωσης της επιφάνειάς της. Η σκληρότητα αποτελεί μια μηχανική ιδιότητα των μετάλλων και των σύνθετων υλικών και η μέτρησή της πραγματοποιείται κατά προσέγγιση στην επιφάνειά τους.

Η παφαμόφφωση της επιφάνειας των υλικών μποφεί να επιτευχθεί με διάφοφους τφόπους, όπως με μηχανική τφιβή, διείσδυση, κοπή και δημιουφγία φάβδωσης ή αποτυπώματος με τη βοήθεια ειδικών «εισαγωγέων» (intenders), οι οποίοι αποτελούνται συνήθως από ιδιαίτεφα σκληφά υλικά. Στη συνέχεια μετφάται το μήκος, το πλάτος ή το βάθος του ίχνους της παφαμόφφωσης που πφοκαλείται.

Συγκεκοιμένα με την τεχνική δημιουργίας αποτυπώματος επιτυγχάνεται η μόνιμη παραμόρφωση της μεταλλικής επιφάνειας με τη διείσδυση ενός «εισαγωγέα» καθορισμένου γεωμετρικού σχήματος: σφαιρικού (μέθοδος Brinell), κωνικού (μέθοδος Rockwell), πυραμιδικού με τετραγωνική βάση (μέθοδος Vickers) ή πυραμιδικού με ρομβική βάση (μέθοδος Knoop).

Ο προσδιορισμός του βάθους διείσδυσης του «εισαγωγέα» πραγματοποιείται με τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου, το οποίο φέρει
ειδικές διατάξεις για τον ποοσδιοοισμό της απαιτούμενης δύναμης που ποέπει να εφαομοσθεί ποοκειμένου να παοαχθεί αποτύπωμα με σαφές περίγραμμα. Στην περίπτωση αυτή η σκληρότητα (Η) ορίζεται από το λόγο της δύναμης- πίεσης (*P*) που ασκεί ο εισαγωγέας προς το εμβαδόν της επιφάνειας του αποτυπώματος (*M*). Αν η P μετοείται σε kp και η M σε mm², η σκληρότητα υπολογίζεται από τον τύπο:

$$H = \frac{P}{M} (kp / mm^2 \eta GPa)$$
(E\xi. 4.2)

Ο προσδιορισμός της σκληρότητας των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂ πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Vickers, η οποία στηρίζεται στη δημιουργία τετραγωνικού αποτυπώματος πάνω στην επιφάνεια του μετάλλου, με τη βοήθεια ενός «εισαγωγέα» από διαμάντι, σχήματος πυραμίδας με γωνία κορυφής α=136^ο.

Στην παφούσα μεταπτυχιακή εφγασία, η μικφοσκληφότητα θα πφοσδιοφισθεί με χφήση αυτομάτου ηλεκτφονικού μικφοσκληφόμετφου Knoop/Vickers Tester της εταιφείας Wilson Instruments, μοντέλο 402 MVD που παφουσιάζεται στο σχήμα 4.6 [14].

Η βαθμονόμηση του μικοοσκληρόμετοου γίνεται με τη βοήθεια πρότυπων δειγμάτων, που έχουν συγκεκριμένη τιμή σκληρότητας στην οποία πρέπει να συμφωνεί και η τιμή της μέτρησης. Έπειτα, επιλέγεται η πίεση F του διαμαντιού που θα εξασκηθεί στην προς μέτρηση επιφάνεια, ενώ το εμβαδόν της επιφάνειας M (mm²) του αποτυπώματος υπολογίζεται γεωμετρικά και δίνεται από τον τύπο:

$$M = \frac{d^2}{2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}(mm^2)$$
(E\xi. 4.3)



Σχήμα 4.6. Μικοοσκληρόμετοο Knoop/Vickers Tester, 402 MVD

όπου d: η διαγώνιος του τετραγωνικού αποτυπώματος (σε mm).

Επομένως, ο γενικός τύπος της σκληφότητας κατά Vickers HV εκφφάζεται ως εξής:

σε MPa ή N/mm²
$$HV = 0.102 \cdot \left(\frac{F}{M}\right) = 0.1891(\frac{F}{d^2})$$
 (Εξ. 4.4)
σε kgf ή kp/mm² $HV = \frac{P}{M} = 1.8544 \cdot (\frac{F}{d^2})$ (Εξ. 4.5)

Στο μικοοσκληρόμετο αυτό μπορούν να προσδιοριστούν οι εξής μικοοσκληρότητες με αντίστοιχη επιλογή πίεσης gf: 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 και 2000 (μακοοσκληρότητα) δίνοντας τιμές αντίστοιχα HV0.01, HV 1 και HV2. Ο χρόνος διείσδυσης του εισαγωγέα μπορεί να επιλεχθεί στην περιοχή 5-99 sec. Το οπτικό μικροσκόπιο διαθέτει δύο φακούς με δυνατότητα μεγέθυνσης 100Χ στο φακό παρατήρησης και 400Χ στο φακό μέτρησης. Τέλος, προκειμένου να προσδιοριστεί η μικροσκληρότητα των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία:

- το πάχος των επικαλύψεων είναι μεγαλύτερο από 50 μm, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση από τις ιδιότητες του υποστρώματος,
- η σκληρότητα κάθε αποθέματος προκύπτει από τον μέσο όρο 10 μετρήσεων, οι οποίες λαμβάνονται σε διάφορες περιοχές της επιφάνειας του αποθέματος.

4.4.2 Τριβολογική συμπεριφορά επικαλύψεων

4.4.2.1 Μέτρηση συντελεστή τριβής ολίσθησης

Για τη μελέτη της συμπεφιφοφάς των επικαλύψεων σε τφιβή λόγω ολίσθησης -απουσία λιπαντικού- έγινε χφήση τφιβόμετφου τύπου ball-ondisc της εταιφείας CSM (σχήμα 4.7) . Η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα επιβολής φοφτίου έως 20 N και πεφιστφοφής του δίσκου έως 500 rpm. Η αφχή της μεθόδου παφουσιάζεται στο σχήμα 4.8 και είναι συμβατή με ASTM G99 & DIN 50324. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το αντίπαλο σώμα (σφαίφα ή ακίδα) ασκεί γνωστή δύναμη στο δείγμα το οποίο πεφιστφέφεται. Το τφιβόμετφο μετφάει αυτόματα την απόκλιση του ελαστικού βφαχίωνα, στον οποίο στηφίζεται το αντίπαλο σώμα, με ειδικό αισθητήφα και έτσι καταγφάφεται συνεχώς ο συντελεστής τφιβής.



Σχήμα 4.7. Τριβόμετρο CSM.



Σχήμα 4.8. Αρχή μεθόδου προσδιορισμού συντελεστή τριβής.

Οι επικαλύψεις που μελετήθηκαν ήταν σύνθετες Ni-P/TiO₂ (50gr/L και 100gr/L TiO₂ στο λουτοό) που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος καθώς και σε συγκεκριμένες συνθήκες παλμικού ρεύματος (d.c.=50%, v=0, 1 – 100Hz). Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι συνθήκες εκτέλεσης των τριβολογικών δοκιμών.

Συνθήκες τοιβολογικών δοκιμών ολίσθησης		
Αντίπαλο σώμα	Σφαίρα ρουμπινιού (d=6mm, HV = 2300 HV)	
Φορτίο	10 N	
Γοαμμική ταχύτητα ολίσθησης	10 cm/s	
Ακτίνα δοκιμής	8 mm	
Κύκλοι ολίσθησης	50000	
Θερμοκρασία	25 ± 2 °C	
Υγρασία	42-50%	

Πίνακας 4.2. Πειραματικές συνθήκες τριβολογικών δοκιμών.

4.4.2.2 Υπολογισμός συντελεστή όγκου φθοράς

Μετά από τις τοιβολογικές δοκιμές ακολούθησε ποοφιλομέτοηση της επιφάνειας των αποθεμάτων στην πεοιοχή του ίχνους φθοοάς, με χοήση ψηφιακού ποοφιλομέτου τύπου ακίδας Hommel Werke T1000 (σχήμα 4.9). Από τις μετοήσεις αυτές υπολογίστηκε **ο συντελεστής όγκου φθοράς c**w ως εξής:

Α
ρχικά από τη μέτ
ρηση του προφιλομέτρου υπολογίζεται ο όγκος φθορά
ςV

$$V = E \cdot d \cdot \pi(\text{mm}^3) \tag{E\xi. 4.6}$$

όπου:

Ε: το εμβαδόν της επιφάνειας του ίχνους φθοράς, που υπολογίζεται από την προφιλομέτρηση

d: η διάμετοος της σφαίρας αλούμινας (d=6mm).



Σχήμα 4.9. Προφιλόμετρο τύπου ακίδας Hommel Werke T
1000

Γνωρίζοντας τον όγκο φθοράς, υπολογίζεται ο συντελεστής όγκου φθοράς από την ακόλουθη σχέση [15]:

$$C_{W} = \frac{V}{F \cdot S}$$
(E\xi. 4.7)

όπου

F: το φορτίο (10N)

S: η συνολικά διανυθείσα απόσταση που δίνεται από τον τύπο

$$S = (αριθμοςκυκλων) \cdot \pi \cdot d$$
(Εξ. 4.8)

Έτσι, ο συντελεστής όγκου φθοράς, *cw*, υπολογίζεται τελικά από τη σχέση:

$$c_{w} = \frac{V}{F \cdot (\alpha \rho \iota \theta \mu \delta \varsigma \kappa \delta \kappa \lambda \omega v) \cdot \pi \cdot d}$$
(Eξ. 4.9)

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 4

- [1] Α. Ζωίκης Καραθανάσης, Διδακτορική διατριβή «Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-P με ηλεκτρολυτική συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC σε συνθήκες παλμικού ρεύματος: σύνθεση, δομή και μηχανικές ιδιότητες», Αθήνα 2010
- [2] M. Zamin, M.B. Ives, Corrosion, 29 (1973) p.319
- [3] J.P. Hoare, J. Electrochem. Soc, 134 (1987) p.3102
- [4] P.K. Ng, D.D. Snyder, J. LaSala, B. Clemens, C. Fuerst, J. Electrochem. Soc. 135 (1988) p.1376
- [5] C.C. Hu, A. Bai, Surf. Coat. Technol. 137 (2001) p.181
- [6] C.R. Brundle, C.A.Evans Jr, S. Wilson, Encyclopedia of materials characterization, Butterworth – Heinemann, 1992
- B.D. Cullity, S.R. Stock, Elements of X-Ray Diffraction, (3rd Edition) Prentice Hall, 2001
- [8] G. Gao, Nanostructures & Nanomaterials, Synthesis Properties and Applications, 1st ed. ICP, 2004
- [9] N. Yao, Z. L. Wang, Handbook of microscopy for Nanotechnology, 1st ed. Kluwer, 2005
- P.J. Goodhew, F.J. Humphreys, Electron Microscopy and Analysis, 2nd ed, Taylor & Francis Inc., 1988
- [11] N. Kanani, Electroplating, Basic Principles, Processes, and Practice, 1st ed. Elsevier, 2004, p.294
- [12] J.F. Shackelford, Introduction to Materials Science for Engineers, 4th ed., Prentice Hall, 1996
- [13] M.G. Barker, I.E. Schreinlechner, Surf. Interface Anal., 9 (1986) p.371
- [14] Ε.Α. Παυλάτου, Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Τεχνική Ανόργανων και Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών, Άσκηση 8», Αθήνας 2012
- [15] I. M. Hutchings, Tribology, Friction and Wear of Engineering Materials, 1st ed. Butterworth-Heinemann, 1992, 83-86

Κεφάλαιο 5° Μελέτη σύστασης δομής – μορφολογίας των επικαλύψεων NiP/TiO₂

5.1 Διεφεύνηση πειφαματικών συνθηκών

Οι σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-P που παρασκευάστηκαν στην εργασία αυτή εμπεριείχαν ως ενισχυτικό μέσο νανοσωματίδια TiO₂ μέσης διαμέτρου d_m = 21 nm. Η ποσότητα της σκόνης TiO₂ που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα ήταν 50 και 100 g/L. Οι βέλτιστες πειραματικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των σύνθετων επικαλύψεων NiP/TiO₂ ήταν οι ίδιες με αυτές των απλών επικαλύψεων μήτρας Ni-P [1]. Οι συνθήκες επιλέχθηκαν βάση αποτελεσμάτων διδακτορικών διατριβών, οι οποίες εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο Γενικής Χημείας [1-2]. Η σύνοψη των συνθηκών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Σύσταση λουτοού	
NiSO4· 6H2O	330 g/L (1,18M)
NiCl ₂ ·6H ₂ O	35 g/L (0,15M)
H ₃ BO ₃	40 g/L (0,65M)
NaH2PO2	10.6 g/L (0,1M)
Σκόνη TiO ₂ (μέσης διαμέτοου 21 nm)	50 g/L και 100 g/L
Συνθήκες ηλεκτοόλυσης	
рН	2.5
Πυκνότητα <i>φεύματος</i> (A/dm²)	6
Θερμοκρασία (°C)	65 °C ± 2

Πίνακας 5.1. Σύνοψη πειραματικών συνθηκών παρασκευής σύνθετων αποθεμάτων μήτρας νικελίου-φωσφόρου με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2

Ταχύτητα περιστροφής καθόδου (rpm)	700
Υπόστοωμα (κάθοδος)	Οφειχάλκινοι δίσκοι (d = 25mm)
Ανοδος	Πλάκα Ni (99,9%)
Ανάδευση λουτοού	Μαγνητική ανάδευση (250 rpm)
Τύπος ορύματος	Συνεχές (DC)
Τυπος θευματος	Παλμικό (PC):
Συνθήκες παλμικού	
duty cycle	d.c. = 50 %
συχνότητα	v = 0.1, 1, 10, 100 Hz

Σε όλα τα σύνθετα αποθέματα πραγματοποιήθηκε στοιχειακή ανάλυση της επιφάνειας, προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσοστό ενσωμάτωσης των ενισχυτικών σωματιδίων, καθώς και η σύσταση της μήτρας Ni-P. Οι επικαλύψεις υπέστησαν θερμική κατεργασία στους 400 °C Η δομή των επικαλύψεων διερευνήθηκε με χρήση XRD, ενώ η μορφολογία τους μελετήθηκε με χρήση μικροσκοπίας SEM.

5.2 Επίδραση πειραματικών παραμέτρων στο % w/w TiO2

Η δομή και οι μηχανικές ιδιότητες των σύνθετων αποθεμάτων εξαρτώνται άμεσα από το ποσοστό, το μέγεθος και τη διασπορά του μέσου ενίσχυσης που ενσωματώνεται στη μεταλλική μήτρα [2]. Από αποτελέσματα προηγούμενων πρωταρχικών πειραμάτων σχετικά με ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ προέκυψε ότι, η επιβολή παλμικού ρεύματος κατά τη συναπόθεση νανοσωματιδίων TiO₂ μέσης διαμέτρου 21nm από λουτρό που περιείχε 20g/L TiO₂ αυξάνει σημαντικά το ποσοστό ενσωμάτωσης στη μεταλλική μήτρα [3-4]. Επιπλέον , η αύξηση της ποσότητας της τιτανίας στο λουτρό 50 και 100 g/L αναμένεται να έχει ως

αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού ενσωμάτωσης αυτής στη μεταλλική μήτρα.

5.2.1 Επίδραση παραμέτρων παλμικού ρεύματος στο ποσοστό συναπόθεσης TiO2

Έχει αποδειχθεί ότι η εισαγωγή της τεχνικής του παλμικού φεύματος στην παφασκευή σύνθετων ηλεκτφολυτικών επικαλύψεων μποφεί να ενισχύσει το ποσοστό ενσωμάτωσης σε σύγκφιση με τα αποθέματα που παφασκευάζονται σε συνθήκες συνεχούς φεύματος [1-3].

Προκειμένου να διεφευνηθεί η αμιγής επίδραση των επιμέφους παραμέτρων του παλμικού ρεύματος, παρασκευάστηκαν σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ για διάφορες τιμές συχνοτήτων των παλμών και για σταθερό d.c = 50%, τόσο στα 50 όσο και στα 100 g/L TiO₂ στο λουτρό (σχήμα 5.1).



Σχήμα 5.1. Εξάφτηση του ποσοστού συναπόθεσης TiO₂ από τη συχνότητα των παλμών με d.c = 50 % . Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες τιμές για τις επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος.

Γενικά διαπιστώνεται ότι η επιβολή υψηλών συχνοτήτων παλμών ευνοούν τη συναπόθεση του ενισχυτικού μέσου TiO₂ στη μήτρα Ni-P. Το

υψηλότερο ποσοστό εγκλεισμού νανοσωματιδίων TiO2 επιτεύχθηκε με επιβολή συχνότητας ν=100 Hz, για 100g/L TiO2 στο λουτρό, προσεγγίζοντας την τιμή ~5 wt.%, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/ TiO2. Σύμφωνα με τους Chen et al. [10], σε παρατεταμένους χρόνους χαλάρωσης Toff (π.χ. χαμηλές συχνότητες) παρατηρήθηκαν χαμηλότερα ποσοστά ενσωμάτωσης των σωματιδίων Al2O3 (διαμέτρου 0.6μm), γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι κάποια από τα σωματίδια, τα οποία ήταν χαλαφά προσροφημένα στην επιφάνεια της καθόδου, είχαν αρκετό χρόνο για να εκροφηθούν εξαιτίας των συνθηκών ανάδευσης στο λουτρό. Έτσι, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι σε υψηλές τιμές συχνοτήτων ευνοούνταν ο εγκλεισμός των σωματιδίων, όπως ακριβώς εξακριβώθηκε και στην παρούσα εργασία. Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να σχετίζεται και με την πρόταση των Podlaha et al., κατά τους οποίους το υψηλότερο ποσοστό ενσωμάτωσης πραγματοποιείται εκεί όπου το πάχος της επικάλυψης ανά περίοδο προσεγγίζει τη διάμετρο των σωματιδίων [11]. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σωματίδια του TiO2 είναι στην κλίμακα των νανομέτοων, είναι λογικό μικροί χρόνοι απόθεσης Τοη να ευνοούν τον εγκλεισμό τους στη μήτρα. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο χρόνο μη απόθεσης Toff, κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η ανανέωση της περιοχής του καθολύτη σε σωματίδια ΤiO₂ [1-2].

5.3 Δομή και μορφολογία σύνθετων επικαλύψεων Ni-P /TiO2

5.3.1 Ποσοστό συναπόθεσης φωσφόρου στη μήτρα των αποθεμάτων Ni-P/TiO2

Στην παφάγφαφο αυτή μελετάται η πεφιεκτικότητα φωσφόφου στη μήτφα παφουσία των ενισχυτικών νανοσωματιδίων TiO₂. Στην παφούσα μεταπτυχιακή εφγασία έγινε διεφεύνηση της επίδφασης του ποσοστού συναπόθεσης TiO₂ στην πεφιεκτικότητα φωσφόφου στη μήτφα Ni-P, έχοντας σταθεφό τον κύκλο φόφτισης-εκφόφτισης duty cycle = 50 %, την ταχύτητα πεφιστφοφής της καθόδου (ω = 700 rpm) και μεταβάλλοντας την ποσότητα TiO₂ στο λουτφό (50 και 100 g/L) καθώς και τις επιβαλλόμενες συνθήκες φεύματος (συνεχές και παλμικό φεύμα διαφοφετικών συχνοτήτων).

Τα σύνθετα αποθέματα $Ni-P/TiO_2$ που παρασκευάστηκαν παρουσιάζουν ποσοστό φωσφόρου στη μήτρα μεταξύ 12 και 16 wt.% για τις αποθέσεις των 50g/L TiO₂ και μεταξύ 9 και 13,5 wt.% για τις αποθέσεις των 100g/L TiO2. Τα αντίστοιχα ποσοστά φωσφόρου για τα αποθέματα καθαφού Ni-P, όπως φαίνεται και από τη βιβλιογραφία κυμαίνονται μεταξύ 12 και 17 % wt [1,5]. Επομένως, διαπιστώνεται μια μείωση του ποσοστού φωσφόρου στη μήτρα Ni-P παρουσία των νανοσωματιδίων TiO2 και για τις δύο περιπτώσεις ποσότητας τιτανίας στο λουτρό. Στο σχήμα 5.2 παρουσιάζεται συνοπτικά το ποσοστό φωσφόρου στη μήτρα Ni-P συναφτήσει του ποσοστού ενσωμάτωσης των σωματιδίων ΤiO2 και του επιβαλλομένου ρεύματος.

Σχήμα 5.2. Συσχέτιση του ποσοστού φωσφόζου στη μήτρα Ni-P με το ποσοστό συναπόθεσης TiO₂ για ποικίλες συνθήκες εφαρμογής τύπου ζεύματος (DC ή PC).



Από το παραπάνω σχήμα γίνεται φανερό ότι, όσο αυξάνεται η ποσότητα TiO² μέσα στο λουτρό και όσο αυξάνεται η συχνότητα των παλμών του ρεύματος τόσο **υψηλότερα ποσοστά συναπόθεσης TiO**² επιτυγχάνονται στις σύνθετες επικαλύψεις και τόσο **μεγαλύτερη μείωση** του ποσοστού του φωσφόρου στη μήτρα παρατηρείται.

Η παφατηφούμενη μείωση του ποσοστού φωσφόφου στη μήτφα Ni-P μποφεί να αποδοθεί στην παφουσία των σωματιδίων TiO₂. Είναι γνωστό ότι σε λουτφά ηλεκτφολυτικής απόθεσης νικελίου που λειτουφγούν σε χαμηλές τιμές pH, μια σημαντική ποσότητα υδφογονοκατιόντων είναι πφοσφοφημένη στην επιφάνεια των σωματιδίων TiO₂ με αποτέλεσμα να οδηγούν σε αυξημένη αναγωγή μοφιακού υδφογόνου [7]. Έτσι, είναι πιθανόν τα νανοσωματίδια TiO₂ να καταλύουν την αναγωγή του υδφογόνου αλλάζοντας τα στάδια του μηχανισμού αναγωγής κατά την ηλεκτφοαπόθεση του κφάματος Ni-P [8] μέσω της ενίσχυσης της παφαγωγής μοφιακού υδφογόνου σε βάφος του ατομικού) [6, 8]. Όμως, σύμφωνα με τον έμμεσο μηχανισμό της ηλεκτροπόθεσης Ni-P το ατομικό υδρογόνο είναι απαραίτητο για την αναγωγή της πηγής φωσφόρου σε φωσφίνη, όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία [1]. Επομένως, η παρουσία των νανοσωματίδων TiO₂ μπορεί να μειώσει το ποσοστό P στη σύνθετη επικάλυψη παρεμποδίζοντας την παραγωγή της φωσφίνης.

5.3.2 Δομή των Ni-P/TiO2 επικαλύψεων

Για τη διεξεύνηση της δομής της μήτρας νικελίου – φωσφόξου στα σύνθετα αποθέματα Ni-P/ TiO₂ διενεξγήθηκαν μετξήσεις πεξίθλασης ακτίνων Χ. Η μελέτη των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/ TiO₂ με την τεχνική πεξίθλασης ακτίνων Χ έδειξε ότι η μήτρα νικελίου – φωσφόξου είναι άμοξφη σε όλες τις πεξιπτώσεις των μη θερμικά κατεξγασμένων αποθεμάτων. Στο σχήμα 5.3 παξουσιάζονται τα ακτινοδιαγξάμματα XRD αποθεμάτων Ni-P/TiO₂ που έχουν παξασκευαστεί για 50 g/L TiO₂ στο λουτξό και σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού ξεύματος (d.c.=50%, ν = 0,1 - 100 Hz). Τα ίδια διαγξάμματα περοέκυψαν και για σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ που παξασκευάσθηκαν με τις ίδιες συνθήκες ξεύματος και για 100 g/L TiO₂ στο λουτξό (βλ. σχήμα 5.4).



Σχήμα 5.3. Διαγφάμματα πεφίθλασης ακτίνων Χ σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂, που παφασκευάστηκαν σε 50g/L TiO₂, σε συνεχές και παλμικό φεύμα (d.c.=50%, v=0.1-100Hz), πφιν τη θεφμική τους επεξεφγασία.



Σχήμα 5.4. Διαγφάμματα πεφίθλασης ακτίνων Χ σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂, που παφασκευάστηκαν σε 100g/L TiO₂, σε συνεχές και παλμικό φεύμα (d.c.=50%, v=0.1-100Hz), πφιν τη θεφμική τους επεξεφγασία.

Σε όλες τις πεφιπτώσεις των μη θεφμικά κατεφγασμένων αποθεμάτων, (σχήματα 5.3 και 5.4) παφατηφείται ότι εμφανίζεται η χαφακτηφιστική πεπλατυσμένη κοφυφή πεφίθλασης του νικελίου, η οποία εκτείνεται στην πεφιοχή 2θ = 39° - 52°, μαζί με τις κοφυφές πεφίθλασης που αντιστοιχούν στα νανοσωματίδια TiO₂, και συγκεκφιμένα στη πεφιοχή 2θ = 26°, όπου η τιτανία εμφανίζεται με τη μοφφή του ανατάση [1,2,5].

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα των σχημάτων με τα αντίστοιχα των απλών επικαλύψεων μήτρας Ni-P (βλ. σχήμα 5.5) από τη βιβλιογραφία [1] φαίνεται ότι η παρουσία των νανοσωματιδίων TiO₂ δεν επηρεάζει τη δομή της άμορφης μήτρας Ni-P.



Σχήμα 5.5. Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ αποθεμάτων Ni-P που έχουν παρασκευαστεί υπό ποικίλες συνθήκες παλμικού και συνεχούς ρεύματος [1].

5.3.3 Μορφολογία Νi-Ρ/ΤiO2 επικαλύψεων

Η μοφφολογία των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂, που παρασκευάστηκαν μελετήθηκε με χρήση της μικροσκοπίας SEM.



Σχήμα 5.6 Μικοοφωτογοαφίες SEM επιφανειών σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ παρασκευασμένων σε λουτρό με 50 g/L TiO₂, πριν τη θερμική τους κατεργασία και συνθήκες (α) συνεχούς ρεύματος, (β) d.c.=50%, ν=0.1 Hz, (γ) d.c = 50%, ν= 10 Hz, (δ) d.c = 50 %, ν= 1Hz και (ε) d.c = 50%, ν=100Hz.

Όπως, παφατηφούμε από τις παφαπάνω εικόνες, η επιβολή παλμικού φεύματος έναντι του συνεχούς, επιφέφει σημαντικές αλλαγές στη μοφφολογία της επιφάνειας των δοκιμίων. Συγκεκφιμένα, το μέγεθος των σφαιφικών σχηματισμών μειώνεται σημαντικά σε σχέση με του συνεχούς. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα των παλμών μειώνεται και η τραχύτητα της επιφάνειας των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂, και η επιφάνεια γίνεται πιο συμπαγής και πιο λεία. Ενδεικτικά η τραχύτητα για σύνθετες επικαλύψεις συνεχούς ρεύματος είναι~0,43 μm ενώ σε συνθήκες παλμικού ρεύματος είναι ~ 0,2 μm.

Τα ίδια αποτελέσματα εξήχθησαν και για τις σύνθετες επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν στις συχνότητες 0.1, 1, 10 και 100 Hz και για ποσότητα ενισχυτικού μέσου μέσα στο λουτρό ίση με 100 g/L. Παρακάτω παρατίθενται αντίστοιχες φωτογραφίες.

Εν συντομία, και σε αυτή την περίπτωση, από τις παραπάνω φωτογραφίες, παρατηρούμε ότι η επιβολή παλμικού ρεύματος, συγκριτικά με το συνεχές, επιφέρει μείωση του μεγέθους των σφαιρικών σχηματισμών. Συνέπεια αυτού είναι πιο ομοιόμορφες λείες επιφάνειες.



Σχήμα 5.7 Μικροφωτογραφίες SEM επιφανειών σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ παρασκευασμένων σε λουτρό με 100 g/L TiO₂, πριν τη θερμική τους κατεργασία και συνθήκες (α) συνεχούς ρεύματος, (β) d.c.=50%, ν=0.1 Hz, (γ) d.c = 50%, v= 1 Hz, (δ) d.c = 50 %, v= 10Hz και (ε) d.c = 50%, v=100Hz.

5.4 Θερμική κατεργασία σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2

Όλες οι παφασκευασμένες σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ υπέστησαν θεφμική κατεφγασία σε ατμόσφαιφα αέφα. Μετά από θερμική κατεργασία στους 400 °C παρατηρήθηκε ότι η άμορφη φάση της μήτρας Ni-P, κρυσταλλώθηκε στις σταθερές φάσεις των Ni και Ni₃P σε όλα τα αποθέματα. Στα παφακάτω σχήματα 5.8 καιν 5.9 παφουσιάζονται τα διαγφάμματα XRD για τις αποθέσεις μετά τη θεφμική τους κατεφγασία, για 50 και 100 g/L TiO₂ στο λουτφό.





Σχήμα 5.8. Διαγράμματα XRD θερμικά κατεργασμένων σύνθετων επικαλύψεων TiO₂, στους 400 ° C για ποσότητα τιτανίας στο λουτρό ίση με 50 g/L.





Σχήμα 5.9. Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ θερμικά κατεργασμένων στους 400°C σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂, για ποσότητα τιτανίας στο λουτρό ίση με 100 g/L.

Σε όλα τα διαγφάμματα XRD των θεφμικών κατεφγασμένων αποθεμάτων εκτός από τις κφυσταλλικές φάσεις των Ni και Ni₃P που δημιουφγήθηκαν, παφατηφούμε και κοφυφές που αντιστοιχούν στις κοφυφές πεφίθλασης της τιτανίας. Συγκεκφιμένα, για γωνία 2θ = 26° ή τιτανία εμφανίζεται με την μοφφή του ανατάση, όπως και στα διαγφάμματα XRD των μη κατεφγασμένων δοκιμίων. Επιπλέον, όμως παρατηρούμε μία κορυφή περίθλασης για γωνία 2θ περίπου 37°, όπου η τιτανία εμφανίζεται και με τη μορφή του ρουτιλίου [9]

Η θερμική κατεργασία των σύνθετων αποθεμάτων έχει επιπτώσεις και στη μορφολογία τους, ιδιαίτερα στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που στα διαγράμματα XRD δεν ανιχνεύονται κορυφές περίθλασης που να αντιστοιχούν σε οξείδια νικελίου, οι μετρήσεις EDS στην επιφάνεια των θερμικά κατεργασμένων αποθεμάτων έδειξαν ποσοστό οξυγόνου περίπου ~10,5 wt.% (σχήμα 5.7) για όλα τα δοκίμια. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η δημιουργία των οξειδίων πιθανόν να περιορίζεται σε ένα πολύ λεπτό φιλμ στην επιφάνεια των αποθεμάτων. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται μικροφωτογραφία SEM θερμικά κατεργασμένης επικάλυψης μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα ανάλυσης EDS.



Σχήμα 5.7. (α) Μικοοφωτογραφία SEM επικάλυψης Ni-P/TiO₂ (d.c.=50%, ν=100Hz) και (β) στοιχειακή ανάλυση EDS της αντίστοιχης επιφάνειας.

5.5 Συμπεράσματα

Τα πειραματικά αποτελέσματα των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO2 έδειξαν πως υπάρχει εξάοτηση του ποσοστού συναπόθεσης νανοσωματιδίων TiO2 από τις επιβαλλόμενες συνθήκες ηλεκτρόλυσης. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση της ποσότητας της τιτανίας μέσα στο λουτρό (από 50 σε 100 g/L) και επιβολή παλμικού ρεύματος και ιδιαίτερα υψηλών συχνοτήτων παλμών, για τις ίδιες τιμές duty cycle και ταχύτητας περιστροφής της καθόδου, ευνοούν τη συναπόθεση του ενισχυτικού μέσου νανοσωματιδίων TiO₂. То υψηλότερο ποσοστό συναπόθεσης νανοσωματιδίων τιτανίας ίσο με ~5 wt.%, παρατηρήθηκε σε συνθήκες ν=100 Hz και 100g/L TiO2. Το ποσοστό φωσφόρου στη μήτρα μειώνεται με την αύξηση του ποσοστού TiO2 στο απόθεμα και μάλιστα, όσο υψηλότερα ποσοστά συναπόθεσης TiO2 επιτυγχάνονται στις σύνθετες επικαλύψεις, μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού φωσφόρου στη μήτρα τόσο παρατηρείται. Η μήτρα Ni-P χαρακτηρίζεται ως άμορφη και το ποσοστό φωσφόρου κυμαίνεται από 9-16% wt. Η θερμική κατεργασία των επικαλύψεων στους 400 °C είχε ως αποτέλεσμα την κουστάλλωση της άμορφης μήτρας Νi-Ρ στις φάσεις Νi και Ni₃P.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 5

[1] Α. Ζωίκης – Καραθανάσης, Διδακτορική διατριβή «Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-Ρ με ηλεκτρολυτική συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC σε συνθήκες παλμικού ρεύματος: σύνθεση, δομή και μηχανικές ιδιότητες», Αθήνα 2010

[2] Σ. Σπανού, Ηλεκτρολυτική συναπόθεση νανοσωματιδίων με βάση ΤιΟ2 επί μεταλλικής μήτρας και μελέτη φωτοκαταλυτικών και αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων τους, ΕΜΠ, 2009

[3] E.A. Pavlatou*, A. Zoikis-Karathanasis, S. Spanou, P. Gyftou in «EAST FORUM – MINDE WORKSHOP 2010»

[4] E.A. Pavlatou*, S. Spanou, A. Zoikis-Karathanasis, P. Gyftou, A.I. Kontos, P. Falaras in
"61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry", Nice, France,
26th September to 1st October, 2010

[5] A. Zoikis-Karathanasis, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis, J. Alloys Compd., 494 (2010) p.396

[6] K.H. Hou, W.H. Hwu, S.T. Ke, M.D. Ger, Mater. Chem. Phys. 100 (2006) p.54

[7] E.A. Pavlatou, M. Stroumbouli, P. Gyftou, N. Spyrellis, J. Appl. Electrochem. (2006) p.385

[8] S.H. Yeh, C.C. Wan, J. Appl. Electrochem., 24 (1994) p.993

[9] J. Novakovich, P. Vasiliou, Kl. Samara, Th. Argyropoulos, Electroless $Ni-P/TiO_2$ composite coatings: Their productions and properties.

[10] Chen, L. Wang, Z. Zeng, T. Xu Surf Coat Technol. 201 (2006) 599

[11] E.J. Podlaha and D. Landolt, J. Electrochem. Soc. 144 (1997) L200

Κεφάλαιο 6° Μηχανικές ιδιότητες σύνθετων επικαλύψεων μήτρας Ni-P

6.1 Μηχανικές ιδιότητες

Οι μηχανικές ιδιότητες, πεφιγφάφουν τον τφόπο με τον οποίο ένα υλικό συμπεφιφέφεται όταν σε αυτό ασκούνται διάφοφα φοφτία και δυνάμεις. Συνήθως, σχετίζονται με την ελαστική ή πλαστική συμπεφιφοφά των υλικών καθώς και με τη δομή τους. Οι μηχανικές ιδιότητες αποτελούν το κφιτήφιο καταλληλότητας ενός υλικού για μηχανικές εφαφμογές (εξαφτήματα στα οποία ασκούνται δυνάμεις, αποφφοφούν δονήσεις κ.τ.λ).

Οι μηχανικές ιδιότητες μποφούν να χωφιστούν στις εγγενείς και στις μη εγγενείς ιδιότητες [1]. Στην πφώτη κατηγοφία ανήκουν οι ιδιότητες, οι οποίες δεν εξαφτώνται από τον τφόπο μέτφησης, την ποσότητα του μετφούμενου υλικού ή άλλες παφαμέτφους. Τέτοιου είδους ιδιότητες είναι η σκληφότητα (με την οποία θα ασχοληθούμε στο παφακάτω υποκεφάλαιο), το μέτφο ελαστικότητας κτλ. Αντίθετα, στη δεύτεφη κατηγοφία ανήκουν εκείνες οι ιδιότητες, οι οποίες εξαφτώνται άμεσα από το πεφιβάλλον της μέτφησης, την ποσότητα του υλικού κ.ά. Παφάδειγμα μη εγγενών ιδιοτήτων αποτελούν η αντοχή στην φθοφά λόγω τφιβής και ο συντελεστής τφιβής, όπου σημαντικό φόλο παίζουν και στις δύο πεφιπτώσεις οι συνθήκες τφιβής (αντίπαλο σώμα, θεφμοκφασία, κ.ά.) [1-5].

6.1.1 Σκληφότητα

Σκληρότητα ενός υλικού είναι το μέτρο της αντίστασης στην παραμόρφωση που προβάλλει το υλικό αυτό, όταν δέχεται πίεση από ένα άλλο σκληρότερο υλικό [6].

Οι μέθοδοι μέτοησης της σκληρότητας, που αναπτύχθηκαν είναι τοείς και είναι οι εξής:

- Σκληρότητα διείσδυσης (indentation hardness): με τη μέθοδο αυτή μετράται η αντίσταση του υλικού στην πλαστική παραμόρφωση, η οποία υφίσταται από την συνεχή πίεση ενός αιχμηρού αντικειμένου. Η σκληρότητα προκύπτει από το λόγο της πίεσης προς την επιφάνεια του αποτυπώματος, το οποίο δημιουργείται από τη διείσδυση του αντικειμένου στο εξεταζόμενο υλικό. Ανάλογα με το σχήμα και το υλικό το οποίο ασκεί την πίεση, προκύπτουν οι σκληρότητες Brinell (ατσάλινη σφαίρα ακτίνας 10 mm), Vickers (τετραεδρική πυραμίδα διαμαντιού), Rockwell (ατσάλινη σφαίρα διαμέτρου 1,6 mm ή κώνος διαμαντιού), ενώ υπάρχουν και άλλες πιο εξειδικευμένες δοκιμές 'όπως οι Shore και Κηοορ, που αφορούν ιξωδοελαστικά ή εύθραυστα υλικά. Η σκληρότητα διείσδυσης χρησιμοποιείται στη μηχανική και τη μεταλλουργία [7].
- Σκληρότητα εγχάραξης (scratch hardness): ονομάζεται το μέτοο αντίστασης του υλικού στην πλαστική παραμόρφωση ή στη θραύση, όταν ένα αιχμηρό αντικείμενο το χαράζει. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στο γεγονός ότι ένα σκληρότερο υλικό χαράζει ένα μαλακότερο. Η κλίμακα στην οποία μετράται αυτού του είδους η σκλήρυνση είναι η κλίμακα του Mohs.

Δυναμική σκληρότητα (rebound hardness): Η σκληφότητα αυτού του είδους σχετίζεται κυφίως με την ελαστικότητα του υλικού. Με τη δοκιμή αυτή μετφάται το ύψος αναπήδησης ενός διαμαντένιου σφυφιού, το οποίο αφήνεται να πέσει στο υλικό από οφισμένο ύψος.

6.1.2 Τοιβή

Τριβή είναι η δύναμη αντίστασης που εκδηλώνεται κατά τη σχετική κίνηση δύο σωμάτων που οι επιφάνειές τους εφάπτονται. Η φορά της εκδηλούμενης τοιβής είναι πάντα αντίθετη ποος την φορά της κίνησης. Η δύναμη τοιβής διακοίνεται σε στατική τοιβή όταν τα σώματα ισοοροπούν και σε τοιβή ολίσθησης (ή κινητική τοιβή) όταν το σώματα κινούνται μεταξύ τους.



Σχήμα 6.1. Απεικόνιση των ανυσμάτων των δυνάμεων: του βάρους (Β), της κάθετης δύναμης (Ν), της τριβής (Τ) και της εξωτερικής δύναμης (F)

Στατική τριβή είναι η δύναμη που εμποδίζει ένα σώμα να κινηθεί όσο ακόμα το σώμα ισορροπεί. Το μέτρο της είναι ίσο με το μέτρο της εφαρμοζόμενης δύναμης που τείνει να κινήσει το σώμα και μπορεί να πάρει τιμές από μηδέν μέχρι μία μέγιστη τιμή που ισούται με μ_s·F_N. Η γενική σχέση της στατικής τριβής είναι η:

(εξίσ. 6.2)

 $T_{f} \leq \mu_{s} \cdot N$,

όπου

Τ_f = δύναμη στατικής τοιβής

μ_s = είναι ένα αδιάστατο μέγεθος που ονομάζεται συντελεστής στατικής τοιβής και εξαοτάται από το πόσο τοαχιά είναι μία επιφάνεια και υπολογίζεται πειοαματικά

N = είναι η κάθετη δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα σώματα που εφάπτονται.

Όταν η εξωτεφική δύναμη ξεπεφάσει την παφαπάνω τιμή τότε το σώμα αφχίζει να ολισθαίνει και πλέον ασκείται σε αυτό τφιβή ολίσθησης. Η τφιβή ολίσθησης είναι λίγο μικφότεφη από το μέγιστο της στατικής τφιβής γιατί όταν το σώμα αποκτήσει ταχύτητα οι δυνάμεις τφιβής ελαττώνονται ελαφφά.

Τριβή ολίσθησης είναι η δύναμη που αντιστέκεται στην σχετική κίνηση των σωμάτων που εφάπτονται και βρίσκονται σε κίνηση. Λέγεται επίσης και κινητική τριβή. Έχει φορά αντίθετη της κίνησης και μέτρο που δίνεται από την παρακάτω σχέση:

 $\mathbf{T}_{\kappa} = \boldsymbol{\mu}_{\kappa} \cdot \mathbf{N}$

Όπου \mathbf{F}_{κ} = τοιβή ολίσθησης

 μ_{κ} = ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

6.1.3 Φθο<u>ρ</u>ά (Wear)

Σύμφωνα με την ASTM (American Society for Testing and Materials), φθορά είναι η ζημιά μιας στερεής επιφάνειας, η οποία κατά κανόνα πεφιλαμβάνει την πφοοδευτική απώλεια υλικού, εξαιτίας της σχετικής κίνησης μεταξύ της επιφάνειας και μίας ή πεφισσότεφων ουσιών που έφχονται σε επαφή [1].

Η φθοφά ενός υλικού μποφεί να οφείλεται σε διάφοφους παφάγοντες, επηφεάζεται από πολλές παφαμέτφους και δεν αποτελεί εγγενές χαφακτηφιστικό ενός υλικού, αλλά εξαφτάται από όλα τα στοιχεία του τφιβοσυστήματος (βλ. Σχήμα 6.2), τα οποία είναι:

- το εξεταζόμενο υλικό,
- το υλικό αναφοράς (αντίπαλο σώμα) ως προς το οποίο μελετάται η φθορά του εξεταζόμενου,
- τα παραμένοντα στο σύστημα προϊόντα της φθοράς, και
- το περιβάλλον, δηλαδή υγρασία, θερμοκρασία, λίπανση κλπ.



Σχήμα 6.2. Τριβοσύστημα .

Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις που αφορούν στους μηχανισμούς της φθοράς. Οι διαφορετικοί μηχανισμοί - τύποι φθοράς αναφέρονται παρακάτω και είναι:

- 1. Φθορά πρόσφυσης (Adhesive wear)
- 2. Φθοφά εκτφιβής (Abrasive wear)

- 3. Επιφανειακή κόπωση (Surface fatigue)
- 4. Τριβοχημική φθορά ή φθορά οξείδωσης (Tribochemical wear)
- 5. Φθορά λόγω παλινδρομικής κίνησης (Fretting wear)
- 6. Μηχανική φθορά (Erosive wear).

Ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι οι παφαπάνω τύποι- μηχανισμοί φθοφάς λειτουφγούν ανεξάφτητα μεταξύ τους σε κάποια εφαφμογή [1]. Μηχανισμοί φθοφάς και\ή υπομηχανισμοί συχνά επικαλύπτονται και εμφανίζονται να ενεφγούν ταυτόχφονα παφάγοντας, έτσι, ένα μεγαλύτεφο ποσοστό φθοφάς σε σχέση με το ποσοστό φθοφάς που δημιουφγεί ο κάθε μηχανισμός ξεχωφιστά.

6.2 Μικοοκληρότητα σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2

6.2.1 Μικοοσκληοότητα ποιν τη θεομική επεξεογασία των επικαλύψεων

Η εισαγωγή σκληφών ενισχυτικών σωματιδίων στη μήτφα ενός μετάλλου ή ενός κφάματος έχει σε γενικές γφαμμές ευεφγετικές επιπτώσεις στη μικφοσκληφότητά του σε σχέση με το απλό μέταλλο ή κφάμα. Ο πφοσδιοφισμός της μικφοσκληφότητας των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ έλαβε μέφος σε σκληφόμετφο τύπου Vickers. Πφοκειμένου να διεφευνηθεί η μικφοσκληφότητα των σύνθετων επικαλύψεων έγινε συσχέτισή της με τον τφόπο παφασκευής των αποθεμάτων και συγκεκφιμένα με το ποσοστό TiO₂ μέσα στο λουτφό (50 και 100 g/L) και με τις συνθήκες επιβολής φεύματος (συνεχές και παλμικό).

Στο σχήμα 6.3, παφουσιάζονται οι τιμές της μικφοσκληφότητας για τα αποθέματα Ni-P/TiO₂ πφιν υποστούν θεφμική κατεφγασία.



Σχήμα 6.3. Διάγραμμα μεταβολής της μικροσκληρότητας των σύνθετων αποθεμάτων σε συνάρτηση με τη συχνότητα των παλμών για σταθερή τιμή d.c = 50% και για διαφορετικές τιμές συγκέντρωσης TiO₂ στο λουτρό. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες τιμές μικροσκληρότητας για τις επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος.

Συγκεκοιμένα, στο παφαπάνω διάγφαμμα παφουσιάζονται οι τιμές της μικφοσκληφότητας των σύνθετων αποθεμάτων σε συνάφτηση με τη συχνότητα των επιβαλλόμενων παλμών. Ακόμα, εμφανίζονται για συγκφιτικούς λόγους οι τιμές της μικφοσκληφότητας των αποθεμάτων που έχουν παφασκευαστεί σε συνθήκες συνεχούς φεύματος και είναι ίσες με ~4,8 GPa και 5,1 GPa για 50 και 100 g/L TiO₂, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι απλές επικαλύψεις Ni-P στις ίδιες συνθήκες ηλεκτφοαπόθεσης εμφανίζουν τη μικφότεφη τιμή μικφοσκληφότητας ~ 4,4 GPa [23,25].

Είναι εμφανές ότι τα σύνθετα αποθέματα που παρασκευάστηκαν στις συγκεκριμένες συνθήκες του παλμικού ρεύματος εμφανίζουν αυξημένη μικροσκληρότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα σύνθετα αποθέματα του συνεχούς ρεύματος. Επιπλέον, παρατηρείται μία μικρή, σταδιακή αύξηση της μικροσκληρότητας με αύξηση της συχνότητας των εφαρμοζόμενων παλμών. Σημειώνεται ότι οι απλές επικαλύψεις Ni-P που

παρασκευάστηκαν στις ίδιες συνθήκες παλμικού ρεύματος παρουσίασαν μικροσκληρότητα στην περιοχή των 4,6 - 4,8 GPa. Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις με διαφορετική τιμή συγκέντρωσης τιτανίας στο λουτρό η μέγιστη τιμή της μικροσκληρότητας εμφανίζεται για τα αποθέματα που παρασκευάστηκαν σε συχνότητα 100Hz. Τέλος, οι σύνθετες επικαλύψεις παρασκευάσθηκαν σε λουτρό συγκέντρωσης 100 g/L TiO2, που παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές μικροσκληρότητας σε σχέση με αυτές των 50 g/L. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 5^{ου} κεφαλαίου (βλ. σχήμα 5.1), αυξανόμενης της ποσότητας της τιτανίας στο λουτρό και αυξανόμενης της συχνότητας των παλμών, αυξάνεται και το % wt. ποσοστό συναπόθεσης των νανοσωματιδίων TiO2 στη μήτρα Ni-P. Έτσι, αναμένεται και αντίστοιχη αύξηση της μικροσκληρότητας των επικαλύψεων μια και ο κύριος μηχανισμός σκλήρυνσης φαίνεται να βασίζεται στη διασπορά των νανοσωματιδίων μέσα στη κραματική άμορφη μήτρα, όπου η μήτρα δέχεται το φορτίο και τα νανοσωματίδια παρεμποδίζουν την ολίσθηση των διαταραχών [26,25].Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί τόσο για μήτρα καθαρού νικελίου ενισχυμένη με νανοσωματίδια TiO2[27] όσο και για την ίδια άμορφη κραματική μήτρα Ni-P με ενίσχυση σωματιδίων SiC και WC [24,25, 28].

6.2.2 Επίδραση θερμικής κατεργασίας στη μικροσκληρότητα των επικαλύψεων Ni-P/TiO2

Σε αντιστοιχία με το σχήμα 6.3 παφουσιάζεται ακολούθως το σχήμα 6.4 που αφοφά στις τιμές μικφοσκληφότητας για τις επικαλύψεις Ni-P/TiO² που υπέστησαν θεφμική κατεφγασία στους 400 °C.



Σχήμα 6.4. Διάγραμμα μεταβολής της μικροσκληρότητας των θερμικά κατεργασμένων στους 400 °C σύνθετων αποθεμάτων σε συνάρτηση με τη συχνότητα των παλμών για σταθερή τιμή d.c = 50% και για διαφορετικές τιμές συγκέντρωσης TiO₂ στο λουτρό. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες τιμές μικροσκληρότητας για τις επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος.

Είναι χαφακτηφιστικό ότι, ενώ οι τιμές μικφοσκληφότητας πφιν τη θεφμική κατεφγασία των σύνθετων επικαλύψεων κυμαινόντουσαν μεταξύ 4,8 και 5,5 GPa, μετά αυξήθηκαν σημαντικά σε σχεδόν διπλάσιες τιμές μεταξύ 6 και 11 GPa. Ο λόγος της σημαντικής αυτής αύξησης οφείλεται στην κρυστάλλωση της άμορφης μήτρας και κυρίως στη δημιουργία των κρυστάλλων Ni και Ni₃P, όπως ανιχνεύθηκαν στα διαγράμματα XRD (βλ. σχήματα 5.8 και 5.9).

Αξίζει να σημειωθεί ότι παφατηφώντας το διάγφαμμα του σχήματος 6.4, για την πλειοψηφία των θεφμικά κατεφγασμένων σύνθετων επικαλύψεων δεν παφουσιάζεται κάποια ξεκάθαφη εξάφτηση της μικφοσκληφότητας από τις συνθήκες του παλμικού φεύματος. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί πιθανότατα στο γεγονός ότι ο μηχανισμός σκλήρυνσης λόγω κατακρήμνισης υπερτερεί του μηχανισμού σκλήρυνσης λόγω της συναπόθεσης σωματιδίων, με αποτέλεσμα η σκληρότητα να μην εξαρτάται άμεσα από το ποσοστό συναπόθεσης νανοσωματίδων ΤiO₂. Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί και για την περίπτωση των μικροσωματιδίων SiC στην κραματική μήτρα Ni-P [24]

6.3 Τοιβολογική συμπεοιφορά σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2

Οι πειφαματικές συνθήκες που εφαφμόστηκαν στις τοιβολογικές δοκιμές των επικαλύψεων NiP/TiO² ήταν ίδιες για όλα τα αποθέματα έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν συγκοίσιμα μεταξύ τους. Συγκεκοιμένα, ως αντίπαλο σώμα χοησιμοποιήθηκε σφαίοα οουμπινιού διαμέτοου 6 mm. Το επιλεγμένο αντίπαλο σώμα παρουσιάζει ιδιαίτεοα υψηλή σκληρότητα (~2300 HV), η οποία ενδείκνυται για την τοιβολογική δοκιμή σκληρών επικαλύψεων. Σε όλες τις πεοιπτώσεις, η γοαμμική ταχύτητα και το φοοτίο διατηρήθηκαν σταθερά και ίσα με 0,1 m/s και 10 Ν, αντίστοιχα. Οι κύκλοι ολίσθησης των δοκιμών ήταν 50.000. Οι τοιβολογικές δοκιμές ποαγματοποιήθηκαν σε πεοιβάλλον με σταθερή θεομοκρασία 27 °C και σχετική υγρασία 40%. Οι δοκιμές τοιβής ποραγματοποιήθηκαν τόσο ποιν, όσο και μετά τη θεομική τους κατεογασία των σύνθετων επικαλύψεων.

6.3.1 Συντελεστής τριβής ολίσθησης

6.3.1.1 Συντελεστής τοιβής ολίσθησης σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2

Στο σχήμα 6.5 παφουσιάζεται ενδεικτικά η εξέλιξη του συντελεστή τοιβής ολίσθησης ορισμένων αποθεμάτων Ni-P/TiO² που έχουν παφασκευαστεί σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού φεύματος ποιν και μετά τη θερμική τους κατεργασία στους 400 °C, τόσο στην περίπτωση της


Σχήμα 6.5. Συντελεστής τοιβής ολίσθησης σύνθετων αποθεμάτων συνεχούς και παλμικού (d.c.=50%, ν= 100Hz) οεύματος, ποιν τη θεομική κατεογασία (α) για 50g/L TiO₂ (γ) 100g/L TiO₂ στο, και μετά τη θεομική τους κατεογασία στους 400 °C, για (β) 50g/L TiO₂ και (δ) 100g/L TiO₂.

συγκέντοωσης νανοσωματιδίων τιτανίας στο λουτο
ό 50 g/L όσο και στην περίπτωση των 100 g/L TiO2.

Σχεδόν σε όλες τις σύνθετες επικαλύψεις παφατηφείται ένα «αφχικό» στάδιο της εξέλιξης του συντελεστή τφιβής- γνωστό και ως running-in phase- όπου παφατηφείται ένα μέγιστο στην τιμή του. Σε οφισμένες πεφιπτώσεις, αυτό το στάδιο εκτείνεται μέχφι και τους 10.000 κύκλους, και είναι σημαντικά μεγαλύτεφο από το αντίστοιχο που παφατηφείται στις απλές επικαλύψεις Ni-P [22], λόγω της υψηλότεφης τφαχύτητας που παφουσιάζουν οι σύνθετες επικαλύψεις. Οι παφατηφούμενες αυξομειώσεις του συντελεστή τφιβής οφείλονται είτε στα πφοϊόντα τφιβής, είτε στις κατά διαστήματα αποκολλήσεις των ενισχυτικών νανοσωματιδίων. Παφόμοια συμπεφιφοφά έχει παφατηφηθεί και στην πεφίπτωση των επικαλύψεων Ni-P/SiC [22].

Πληφέστεφη εικόνα του συντελεστή τφιβής ολίσθησης δίνεται στο σχήμα 6.6 όπου αναπαφιστάται η μέση τιμή του συντελεστή όλων των παφαγόμενων επικαλύψεων πφιν και μετά τη θεφμική κατεφγασία. Οι επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ που έχουν υποστεί θεφμική κατεφγασία στους 400 °C εμφανίζουν μειωμένο συντελεστή τφιβής με τις αντίστοιχες επικαλύψεις πφιν την ανόπτηση. Η διαφοφοποίηση αυτή οφείλεται στη κφυστάλλωση της άμοφφης φάσης Ni-P, η οποία οδηγεί στη σκλήφυνση του αποθέματος.

Δεδομένου ότι στην τριβολογική συμπεριφορά των σύνθετων αποθεμάτων σημαντικός παράγοντας είναι και ο τρόπος κατανομής των ενισχυτικών σωματιδίων στη μήτρα πέρα από το ποσοστό συναπόθεσης τους, διαπιστώθηκε ότι τα νανοσωματίδια TiO₂ είχαν φτωχότερη διασπορά στη μήτρα Ni-P στην περίπτωση των επικαλύψεων συνεχούς ρεύματος σε σχέση με τις αντίστοιχες του παλμικού ρεύματος και επομένως, αναμένονται υψηλότερες τιμές συντελεστή τριβής για τις DC επικαλύψεις.



Σχήμα 6.6. Μεταβολή του συντελεστή τριβής ολίσθησης(μ) επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ σε συνάρτηση με την επιβαλλόμενη συχνότητα παλμικού ρεύματος, πριν και μετά τη θερμική τους κατεργασία στους 400 °C (α) για 50 g/L TiO₂ και (β) 100 g/L TiO₂ . Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες τιμές για τις επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος.

Συνοψίζοντας και στις δύο περιπτώσεις παρασκευής σύνθετων αποθεμάτων (50 και 100g\L TiO2) οι συντελεστές τριβής των επικαλύψεων που έχουν παρασκευαστεί σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές από τους αντίστοιχους των επικαλύψεων παλμικής απόθεσης τόσο ποιν, όσο και μετά τη θερμική τους κατεργασία (βλ. Σχήμα 6.6).

6.3.2 Φθοφά λόγω τριβής ολίσθησης

Ο συντελεστής τοιβής ολίσθησης, ο οποίος εξετάστηκε στη πορηγούμενη παράγραφο, αποτελεί ένδειξη για το τι συμβαίνει κατά τη σχετική κίνηση δύο υλικών. Παρόλα αυτά, δεν παρέχει πληροφορίες για τον υπολογισμό της φθοράς των υλικών αυτών. Προκειμένου να υπολογιστεί η φθορά των υλικών λόγω τοιβής ολίσθησης, στη μεταπτυχιακή αυτή εργασία έγινε προφιλομέτοηση του ίχνους τοιβής.

Στο σχήμα 6.7 παφουσιάζονται αντιπφοσωπευτικές πφοφιλομετφήσεις του ίχνους τφιβής των επικαλύψεων Ni-P/TiO₂, πφιν και μετά τη θεφμική τους κατεφγασία, οι οποίες είχαν υποστεί τφιβολογική δοκιμή 50.000 κύκλων. Γενικά, οι επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ παφουσιάζουν αφκετά ευδιάκφιτα ίχνη τφιβής (πφάσινες πεφιοχές). Εκατέφωθεν του ίχνους τφιβής διακφίνονται υπεφυψωμένες πεφιοχές που αποδίδονται στα πφοϊόντα τφιβής που αποβάλλονται στα άκφα της πίστας τφιβής. Μετά τη θεφμική κατεφγασία των επικαλύψεων, η επιφάνεια των ιχνών τφιβής είναι αισθητά μειωμένη λόγω της αύξησης της σκληφότητας των επικαλύψεων (σχήμα 6.7 β,δ). Με τον ίδιο τφόπο υπολογίστηκαν τα ίχνη τφιβής όλων των σύνθετων επικαλύψεων στην παφούσα μεταπτυχιακή εφγασία.



Σχήμα 6.7. Τοπογραφία ιχνών τριβής μετά από τριβολογική δοκιμή 50.000 κύκλων των επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού ρεύματος (d.c.=50%, v=100 Hz) (α), (γ) πριν τη θερμική κατεργασία και (β), (δ) μετά τη θερμική επεξεργασία στους 400 °C.

Στο σχήμα 6.8 απεικονίζονται οι τιμές του συντελεστή όγκου φθοφάς (όπως υπολογίστηκαν από την εξίσωση 4.9) για τις σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού φεύματος, πφιν και μετά τη θεφμική τους κατεφγασία στους 400 °C.



Σχήμα 6.8. Συντελεστής όγκου φθοράς των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂ σε συνάρτηση με την επιβαλλόμενη συχνότητα παλμικού ρεύματος, πριν και μετά τη θερμική τους κατεργασία στους 400 °C. Για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες τιμές για τις επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος.

Πριν τη θερμική κατεργασία και στις δύο περιπτώσεις ποσότητας του ενισχυτικού μέσου (50 και 100g/L TiO₂) μέσα στο λουτρό, οι επικαλύψεις που παρασκευαστήκαν σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή όγκου φθοράς σε σύγκριση με όλα τα

αποθέματα που παφασκευαστήκαν με την εφαφμογή του παλμικού φεύματος. Η πιθανή αιτία της παφατηφούμενη αυτής υψηλής φθοφάς του αποθέματος μποφεί να συσχετίζεται με τις υψηλότεφες εσωτεφικές τάσεις που εμφανίζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες των PC αποθεμάτων. Οι ενισχυμένες αυτές εσωτεφικές τάσεις φαίνεται ότι μειώνουν την αντιτφιβική ικανότητα της επικάλυψης, πιθανότατα λόγω της αυξημένης ευθφαυστότητας της. Ωστόσο, βάσει της βιβλιογφαφίας, η εφαφμογή του παλμικού φεύματος, η οποία πφοκαλεί σημαντική μείωση των εσωτεφικών τάσεων, οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου φθοφάς λόγω τφιβής [23, 24].

Μετά τη θεφμική κατεφγασία στους 400 °C, τόσο στα 50 όσο και στα 100g/L TiO₂ στο λουτφό, οι σύνθετες επικαλύψεις εμφανίζουν μειωμένους συντελεστές όγκου φθοφάς ανεξάφτητα από τον εφαφμοζόμενο τύπο του φεύματος. Η ενίσχυση της αντοχής στην τφιβή πιθανόν να οφείλεαι οφείλεται στη σκλήφυνση των επικαλύψεων λόγω της κφυστάλλωσης της μήτφας Ni-P, και πιο συγκεκφιμένα στην κατακφήμνιση της σκληφής φάσης Ni₃P.

Ειδικότερα, ανάμεσα στα DC και στα PC αποθέματα, παρατηρείται μείωση του συντελεστή φθοράς (όπως και πριν τη θερμική κατεργασία). Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των εσωτερικών τάσεων κατά τη διαδικασία της κρυστάλλωσης της μήτρας.

Τέλος, συγκοίνοντας τα δύο διαγοάμματα για 50 και 100g/L TiO² στο λουτοό τόσο ποιν όσο και μετά τη θεομική κατεογασία, τη χαμηλότεοη τιμή όγκου φθοοάς και επομένως τη μεγαλύτεοη αντίσταση σε φθοοά τοιβής ολίσθησης εμφάνισαν οι σύνθετες επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν με εφαρμογή παλμικού οεύματος και συγκεκοιμένα σε d.c.=50% και συχνότητα v=100 Hz.

Ποοκειμένου να διεφευνηθεί πεφαιτέφω η φθοφά των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ έγινε συσχέτιση της μικφοσκληφότητας των

αποθεμάτων με τη φθορά που υπέστησαν, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.9.



Σχήμα 6.9. Εξάρτηση του συντελεστή όγκου φθοράς από τη μικροσληρότητα των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO2 πριν και μετά τη θερμική τους κατεργασία στους 400 °C.

Πριν από τη θερμική κατεργασία των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO2 δεν διακρίνεται κάποια εξάρτηση του συντελεστή όγκου φθοράς από την μικροσκληρότητα των αποθεμάτων (σχήμα 6.9). Μετά τη θερμική τους κατεργασία φαίνεται ότι αρχικά αύξηση της σκληρότητα οδηγεί σε φθοράς. Γενικά σχετικά μικρότερο όγκο οι επικαλύψεις που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες παλμικού ρεύματος και με 50g/L TiO₂ στο λουτρό οδηγούν σε επικαλύψεις με υψηλή αντίσταση σε τριβή ολίσθησης τόσο ποιν από τη θεομική όσο και μετά τη θεομική κατεογασία. Γενικά, συγκρίνοντας επικαλύψεις μήτρας Νi [27] και απλών ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων Ni-P καθώς και σύνθετων Ni-P/SiC αποθεμάτων [23] (σχήμα 6.10) προκύπτει καλύτερη ότι την τοιβολογική συμπεριφορά παφουσιάζουν οι επικαλύψεις Ni-P/TiO² που παφασκευάστηκαν σε συνθήκες παλμικού φεύματος και με 50g/L TiO² στο λουτφό.



Σχήμα 6.10. Εξάφτηση του συντελεστή όγκου φθοφάς από τη μικφοσληφότητα των σύνθετων αποθεμάτων Νi, Ni-P και Ni-P/TiO₂ πφιν και μετά τη θεφμική τους κατεφγασία στους 400 °C [23, 27].

Μια λεπτομεφέστεφη διεφεύνηση των παφαγόντων που επηφεάζουν τη φθοφά των σύνθετων υλικών, οδηγεί στη συσχέτιση του συντελεστή όγκου φθοφάς με το ποσοστό συναπόθεσης των ενισχυτικών σωματιδίων. Λαμβάνοντας υπόψη το σχήμα 6.9 και 5.1 φαίνεται ότι η φθοφά των επικαλύψεων μειώνεται με αύξηση του ποσοστού συναπόθεσης νανοσωματιδίων ΤiO₂. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στην πεφίπτωση των θεφμικά κατεφγασμένων επιακλυψεων που εμφανίζουν και τις μικφότεφες τιμές όγκου φθοφάς. Πιθανότατα η πιο σκληφή μήτφα που πφοκύπτει από τη κφυστάλλωση της άμοφφη φάσης Ni-P, έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη υποστήριξη και συγκράτηση των νανοσωματιδίων και ως εκ τούτου τις καλύτερες αντιτριβικές ιδιότητες.

6.3.3 Μηχανισμοί φθοράς τριβής λόγω ολίσθησης

Προκειμένου ολοκληρωθεί να η μελέτη της τοιβολογικής συμπεριφορά, πέρα από τη μελέτη του συντελεστή τριβής και του προσδιορισμού του όγκου φθοράς των επικαλύψεων, έγινε και διερεύνηση του μηχανισμού τοιβής. Συγκεκοιμένα, ποαγματοποιήθηκε οπτική παρατήρηση των ιχνών τριβής και του αντιπάλου σώματος στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο SEM, καθώς και ταυτόχρονες ποσοτικές αναλύσεις στα δύο εξεταζόμενα σώματα με τη μέθοδο EDS. Σημειώνεται ότι για το σύνολο των δειγμάτων που υποβλήθηκαν σε τοιβολογικές δοκιμές το πλάτος και η μορφολογία της πίστας τριβής κάθε αποθέματος που παρουσιάζεται στις μικροφωτογραφίες SEM είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του ίχνους φθοράς για όλη την περίμετρο της κάθε πίστας.

6.3.3.1 Μηχανισμοί φθοράς επικαλύψεων Ni-P/TiO2

6.3.3.1 α) Μη θερμικά κατεργασμένες επικαλύψεις Ni-P/TiO2

Στο σχήμα 6.11 παφουσιάζονται μικφοφωτογφαφίες SEM των ιχνών τφιβής σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO₂, που παφασκευάστηκαν με 50g/L TiO₂ στο λουτφό και σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού φεύματος (d.c = 50%) μετά από τφιβολογικές δοκιμές 50.000 κύκλων ολίσθησης.



Σχήμα 6.11. Μικροφωτογραφίες SEM ιχνών τριβής επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ που παρασκευάστηκαν σε λουτρό με 50g/L TiO₂ και σε συνθήκες (α) DC (β) ν=0,1Hz, (γ) ν =1 Hz (δ) ν = 10 (ε) ν =10Hz.

Ακολούθως, στο σχήμα 6.12 παρουσιάζονται αντίστοιχες μικροφωτογραφίες SEM για την περίπτωση των 100g/L TiO2 στο λουτρό.



Σχήμα 6.12. Μικροφωτογραφίες SEM ιχνών τριβής επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ που παρασκευαστήκαν με 100g/L TiO₂ στο λουτρό και σε συνθήκες (α) DC (β) v=0,1Hz, (γ) v =1 Hz (δ) v = 10 (ε) v =100Hz.

Είναι φανεφό, από τα παφαπάνω σχήματα, ότι τα ίχνη τφιβής (πίστες) μετά από δοκιμές 50.000 κύκλων ολίσθησης παφουσιάζουν παφόμοια χαφακτηφιστικά για όλα τα σύνθετα αποθέματα Ni-P/TiO₂, τόσο για 50 όσο και για 100 g/L TiO₂ στο λουτφό, ανεξάφτητα από τις συνθήκες επιβολής του τύπου φεύματος. Επιπλέον, οπό τις εικόνες, παφατηφούμε ότι διακφίνονται πφοσκολλημένα πφοϊόντα τφιβής, μέσα στην «πίστα» γεγονός που δηλώνει την ύπαφξη του μηχανισμού φθοφάς λόγω πρόσφυσης.

Επιπλέον, στα ίχνη τοιβής είναι ευδιάκοιτες παράλληλες γραμμές προς τη φορά κίνησης του αντιπάλου σώματος, οι οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη του μηχανισμού εκτριβής.

Επίσης, μέσα στα ίχνη τοιβής διακοίνονται σκουοόχοωμες και ανοιχτόχοωμες πεοιοχές (σχήμα 6.13). Η στοιχειακή ανάλυση που έγινε στα ίχνη τοιβής έδειξε ότι οι σκουοόχοωμες πεοιοχές αποτελούνται κυοίως από οξείδια των ποοϊόντων τοιβής όπως υποδεικνύεται από το πολύ υψηλό ποσοστό οξυγόνου (περίπου 30 wt. %).



Σχήμα 6.13. Φωτογραφία SEM ίχνους τριβής επικάλυψης Ni-P/TiO₂ ($\nu = 10$ Hz – 100g/L TiO₂), και αντίστοιχες στοιχειακές αναλύσεις για τις περιοχές (1) και (2).

Ακόμα, ανιχνεύθηκε και ποσότητα αλουμινίου, όπως βλέπουμε από τις παφαπάνω στοιχειακές αναλύσεις του σχήματος 6.13, το οποίο πφοέφχεται από τη φθοφά της σφαίφας φουμπινιού. Επομένως, τα πφοϊόντα φθοφάς (επικάλυψης και αντιπάλου σώματος) σχηματίζουν ένα λεπτό πφοστατευτικό στφώμα στην πίστα τφιβής. Στις ανοιχτόχφωμες πεφιοχές της πίστας τφιβής, φαίνεται ότι έχει αποκολληθεί το πφοστατευτικό στφώμα οξειδίου.

Ενδιαφέφον παφουσιάζει και η παφατήφηση του αντίπαλου σώματος μετά από τις τφιβολογικές δοκιμές 50.000 κύκλων ολίσθησης των επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ (βλ. Σχήμα 6.14)



Σχήμα 6.14. (α) Μικοοφωτογοαφία SEM αντιπάλου σώματος μετά από τοιβολογική δοκιμή 50.000 κύκλων σε επικάλυψη Ni-P/TiO₂ (ν=1Hz – 50g/L TiO₂) (β) λεπτομέσεια της ποώτης φωτογοαφίας (Το μαύοο βέλος υποδεικνύει τη φορά της κίνησης της σφαίρας).

Στο ίχνος τοιβής της σφαίοας υπάοχουν παράλληλες γραμμές, ένδειξη του μηχανισμού φθοράς εκτριβής που υφίσταται η σφαίρα κατά την επαφή της με τη σύνθετη επικάλυψη Ni-P/TiO₂. Επίσης, παρατηρούνται διάφορες αποκολλήσεις που προσφύονται στο ίχνος (βλ. Σχήμα 6.14β), για τα οποία η στοιχειακή ανάλυση έδειξε ότι αντιστοιχούν σε σύσταση όμοια με αυτή του αποθέματος Ni-P/TiO₂.

Συνολικά, τα αποθέματα Ni-P/TiO² που δεν έχουν υποστεί θερμική κατεργασία παρουσιάζουν τους εξής μηχανισμούς φθοράς τριβής ολίσθησης: εκτριβή, πρόσφυση και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε ο σχηματισμός προστατευτικού στρώματος, το οποίο συντίθεται από τα οξειδωμένα προϊόντα τριβής.

<u>6.3.3.1.β Θερμικά κατεργασμένες επικαλύψεις Ni-P/TiO</u>2

Μετά τη θεομική τους κατεογασία, οι σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ πέοα από τη σημαντική ενίσχυση της μικοοσκληρότητάς τους παρουσιάζουν και σχετικά μεγαλύτεοη αντοχή στη φθορά. Στο σχήμα 6.15 παρουσιάζονται ενδεικτικά μικορφωτογραφίες SEM των ιχνών φθοράς θεομικά κατεογασμένων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού ρεύματος τόσο σε 50 όσο και σε 100g/L TiO₂ στο λουτρό.

Μετά από τοιβολογική δοκιμή 50.000 κύκλων ολίσθησης, η μοοφολογία των ίχνους τοιβής όλων των θεομικά κατεογασμένων αποθεμάτων είναι σχεδόν παοόμοια με τις αντίστοιχες των αποθεμάτων ποιν τη θεομική κατεογασία. Παοόλα αυτά, οι γραμμές άροσης είναι πιο έντονες στη περίπτωση των θερμικά κατεργασμένων αποθεμάτων.



Σχήμα 6.15. Μικοοφωτογραφίες SEM ίχνους τριβής θερμικά κατεργασμένων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ μετά από 50.000 κύκλους τριβής (α) 50g/L TiO₂ στο λουτρό και συνθήκες DC, (β) 100g/L TiO₂ στο λουτρό και DC, (γ) 50 g/L TiO₂ και ν = 10Hz, (δ)100g/L TiO₂ και 10Hz, (ε) 50 g/L TiO₂ και ν = 100Hz , και (ζ) 100g/L TiO₂ και ν = 100Hz.

Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στην επιφανειακή οξείδωση της επικάλυψης που πραγματοποιήθηκε κατά τη θερμική κατεργασία, όπου τα εύθραυστα επιφανειακά στρώματα των οξειδίων καταστρέφονται γρήγορα κατά την επαφή τους με τη σφαίρα ρουμπινιού, οδηγώντας στο σχηματισμό ευδιάκριτης πίστας τριβής. Έτσι, ενώ πριν την ανόπτησή τους οι πίστες τριβής χαρακτηριζόντουσαν από προσφύσεις των προϊόντων τριβής, μετά τη θερμική κατεργασία παρατηρούνται αποκλειστικά παράλληλες γραμμές προς τη φορά της κίνησης του αντίπαλου σώματος.

Από τη μελέτη του αντίπαλου σώματος των τριβολογικών δοκιμών στα θερμικά κατεργασμένα σύνθετα αποθέματα Ni-P/TiO² παρατηρήθηκαν προσφύσεις της επικάλυψης (σχήμα 6.16). Τα σωματίδια αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως τρίτο σώμα μεταξύ της διεπιεφάνειας επικάλυψης και αντιπάλου σώματος, με αποτέλεσμα να ενισχύουν το μηχανισμό φθοράς άροσης.



Σχήμα 6.16. (α) Μικοοφωτογοαφία SEM αντιπάλου σώματος μετά από τοιβολογική δοκιμή 50.000 κύκλων σε επικάλυψη Ni-P/TiO² που παρασκευάστηκε με 50g/L TiO² στο λουτρό και σε συνθήκες d.c.=50%, v=1Hz (β) λεπτομέρεια της πρώτης φωτογραφίας. (Το μαύρο βέλος υποδεικνύει τη φορά της κίνησης της σφαίρας).

Συνολικά, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί φθοράς λόγω τριβής ολίσθησης που απαντώνται στα σύνθετα αποθέματα Ni-P/TiO² πριν τη θερμική κατεργασία είναι η εκτριβής, πρόσφυσης και η οξείδωση με ταυτόχρονη δημιουργία προστατευτικού στρώματος οξειδίων των προϊόντων τριβής, ενώ μετά τη θερμική τους κατεργασία επικρατεί ο μηχανισμός φθοράς της άροσης.

6.4 Συμπεράσματα

Οι σύνθετες επικαλύψεις Ni-P/TiO2 που παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας λουτρό που περιείχε 50g/L TiO2 και σε συνθήκες συνεχούς και παλμικού ρεύματος για τις συχνότητες 0,1 ,1, 10 και 100 Hz, παρουσιάζουν μικροσκληρότητα μεταξύ 4,8 και 5,3 GPa, πριν τη θερμική τους κατεργασία. Οι αντίστοιχες τιμές μικροσκληρότητας για τα σύνθετα αποθέματα Ni-P/TiO2 που παρασκευάστηκαν σε λουτρό σύστασης 100g/L TiO2 κυμαίνονται μεταξύ 5,1 και 5,5 GPa. Η θεομική κατεογασία και η οεύματος έχει ευεογετική εφαρμογή παλμικού επίδραση στην μικροσκληρότητα των σύνθετων αποθεμάτων και στις δύο περιπτώσεις (50 και 100g/L TiO2) που συνοδεύονται από την κουστάλλωση της μήτρας Ni-P και δημιουργίας κρύσταλλων Ni και Ni3P με αποτέλεσμα η μικροσκληρότητα να λαμβάνει μέγιστη τιμή ~10.49 GPa -στην περίπτωση των 50g/L TiO₂ στο λουτοό, και ~10,00 GPa για ποσότητα TiO₂ στο λουτοό ίση με 100g/L.

Όσον αφορά στον συντελεστή τριβής ολίσθησης των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ σε τριβολογικές δοκιμές με αντίπαλο σώμα σφαίρας ρουμπινιού, η εφαρμογή παλμικού ρεύματος και η θερμική κατεργασία είχαν ως αποτέλεσμα την μείωσή του σε σχέση με αυτόν του συνεχούς ρεύματος, και στις δυο περιπτώσεις παρασκευής των σύνθετων αποθεμάτων (50 και 100g/L).

Γενικά, συγκρίνοντας επικαλύψεις μήτρας Νi και απλών ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων Ni-P καθώς και σύνθετων Ni-P/SiC

αποθεμάτων ποοκύπτει ότι την μεγαλύτεοη αντίσταση σε φθοοά εκτοιβής παρουσιάζουν οι επικαλύψεις Ni-P/TiO² που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες παλμικού ρεύματος και με 50g/L TiO² στο λουτρό. Γενικά, η φθορά εκτοιβής διαπιστώθηκε ότι συνδέεται με το ποσοστό συναπόθεσης νανοσωματιδίων τιτανίας στην κραματική μήτρα, όπου παρατηρήθηκε ότι υψηλά ποσοστά συναπόθεσης συνοδεύονται από μεγαλύτερη αντίσταση στη φθορά τοιβής ολίσθησης.

Τα αποθέματα Ni-P/TiO² που δεν έχουν υποστεί θερμική κατεργασία παρουσιάζουν τους εξής μηχανισμούς φθοράς λόγω τριβής ολίσθησης: εκτριβής, πρόσφυσης και οξείδωσης. Μετά την ανόπτηση των σύνθετων επικαλύψεων στους 400°C ο κυρίαρχος μηχανισμός είναι αυτός της άροσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή παλμικού ρεύματος στην παρασκευή σύνθετων επικαλύψεων επιδρά ευεργετικά στη τριβολογική τους συμπεριφορά.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 6

[1] Williams, J. A. (2005). "Wear and wear particles - Some fundamentals." Tribology International 38(10): 863-870

[2] Rabinowicz, E. (1995). Friction and Wear of Materials. New York, John Wiley and Sons.

[3] Bisson, Edmond E. (1968). Various Modes of Wear and their Controlling Factors. NASA Technical Memorendum TM X-52426.

[4] Chattopadhyay, R. (2001). Surface Wear - Analysis, Treatment, and Prevention. OH, USA: ASM-International. ISBN 0-87170-702-0

[5] Chattopadhyay, R. (2004). Advanced Thermally Assisted Surface Engineering Processes. MA, USA: Kluwer Academic Publishers. ISBN 1-4020-7696-7

[6] Jones, M., H., and D. Scott, Eds. (1983). Industrial Tribology: the practical aspects of friction, lubrication, and wear. New York, Elsevier Scientific Publishing Company.

[7] Stachowiak, G. W., and A. W. Batchelor (2005). Engineering Tribology. Burlington, Elsevier Butterworth-Heinemann

[8] Glaeser, W. A., Ed. (1993). Characterization of Tribological Materials. Materials Characterization Series. Boston, Butterworth-Heinemann.

[9] Standard Terminology Relating to Wear and Erosion, Annual Book of Standards, Vol 03.02, ASTM, 1987, p 243-250

[10] ASM Handbook Committee (2002). ASM Handbook. Friction, Lubrication and Wear Technology. U.S.A., ASM International. Volume 18.

[11] Mamata, K. P. (2008). "A review on silt erosion in hydro turbines." Renewable & sustainable energy reviews 12(7): 1974.

[12] Sinmazcelik, T. and I. Taskiran (2007). "Erosive wear behaviour of polyphenylenesulphide (PPS) composites." Materials in engineering 28(9): 2471-2477.

[13] K. Holberg, A. Matthews, Coating Tribology, Properties, Techniques and Applications in Surface Engineering, 1994

[14] K.G. Budinski, M.K. Budinski, Engineering Materials: Properties and Selection (7th Edition), chapter 3, Prentice Hall, 2007

[15] http://www.stle.org/resources/lubelearn/wear/default.aspx

[16] http://www.tribology.co.kr/tribology/tribology_theory_3.htm

[17] Alfons Ficher, Introduction to tribosystems and the nature of contacts, 2007

[18] <u>http://el.wikipedia.org/wiki/Μαρτενσίτης</u>

[19] B. Bhushan, B.K. Gupta, Handbook of tribology : materials, coatings, and surface treatments, (1st Edition), McGraw-Hill, 1991

[20] ASTM Standard G40-01, 2002b. Standard Technology Relating to Wear and Erosion. Annual Book of ASTM Standards, Vol. 03.02, p. 161–168.

[21] K.G. Budinski, M.K. Budinski, Engineering Materials: Properties and Selection (7th Edition), Prentice Hall, 2007

[22] I.R. Aslanyan, J.-P. Bonino, J.-P. Celis, Surf. Coat. Technol. 200 (2006) p. 2909

[23] Α. Ζωίκης – Καραθανάσης, Διδακτορική διατριβή «Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Ni-P με ηλεκτρολυτική συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC σε συνθήκες παλμικού ρεύματος: σύνθεση, δομή και μηχανικές ιδιότητες», Αθήνα 2010

[24] K.H. Hou, M.C. Jeng, M.D.Ger, Wear, 262 (2007) p.833

[25] A. Zoikis Karathanasis, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis, Electrochim. Acta, (2009), **54** 2563-2570,

[26] P. Gyftou, M. Stroumbouli, E.A. Pavlatou, P. Asimidis and N. Spyrellis, Electrochim. Acta, (2005), 50 4544-4550,]

[27] S. Spanou, E.A. Pavlatou Zeitschrift fur Physikalische Chemie, (2011), 225(3) 313-324

[28] A. Zoikis-Karathanasis, E. A. Pavlatou, N. Spyrellis J. Alloys and Compds. (2010), 494 396-403,

Κεφάλαιο 7° Φωτοκατάλυση

7.1 Γενικές Πειραματικές Αρχές.

Οι πειραματικές πορείες που ακολουθήθηκαν και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση τηρήθηκαν οι απαραίτητοι κανόνες εργασίας και ασφαλείας σε ένα χημικό εργαστήριο [1].

Τα υδατικά διαλύματα παρασκευάστηκαν από υπερκάθαρο νερό (18 MΩ.cm⁻¹). Όλα τα υάλινα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν, πλύθηκαν με κοινό απορρυπαντικό και μετά από διαδοχικές εκπλύσεις άφθονου νερού, απομακρύνθηκαν τα ιόντα με απεσταγμένο νερό. Μία τελική έκπλυση με ακετόνη ή αιθανόλη αναλυτικού βαθμού καθαρότητας βοηθά στην απομάκρυνση τυχόν οργανικών υπολειμμάτων.

7.2 Φωτοκατάλυση και αναλυτικός προσδιορισμός ρύπων

Η αξιολόγηση της Φωτοκαταλυτικής δράσης έλαβε χώρα σε ειδικές κυψελίδες (Σχήμα 7.1) με στρογγυλή βάση (εσωτερική διάμετρος 4 cm, συνολική χωρητικότητα 30 mL). Οι κυψελίδες δεν απορροφούν την ακτινοβολία με την προϋπόθεση ότι το μήκος κύματός της δεν είναι χαμηλότερο από τα 320 nm (γυαλί Pyrex).

Το σύστημα τοποθετείται σε ειδικό χώρο, εξοπλισμένο με 4 παράλληλους λαμπτήρες εγγύς υπεριώδους (Sylvania GTE, F15W/T8) με μέγιστο φασματικής κατανομής τα 350 nm. Η ισχύς της φωτεινής ακτινοβολίας προσδιορίστηκε με τη βοήθεια πυρανόμετρου (28-0925 Ealing

Research Radiometer-Photometer, 28- 0982 silicon detector, 28-0727 flat response filter) στην τιμή 71.7 μWcm⁻² και σε κάθετη απόσταση 25 cm από την διάταξη των λαμπτήρων.



Σχήμα 7.1. Πειραματική διάταξη αξιολόγησης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας. Επάνω απεικονίζεται ο χώρος με τους λαμπτήρες εγγύς υπεριώδους. Κάτω απεικονίζεται η κυψελίδα φωτοκατάλυσης.

Κατά τη φωτοκαταλυτική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ως μόριο – στόχος το πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου (C14H14N3NaO3S, Methyl Orange, Mr = 327.33 g.mole-1, Aldrich, Analytical Grade). Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κορεσμένα σε οξυγόνο. Ο κορεσμός έλαβε χώρα με διοχέτευση υπερκάθαρου οξυγόνου (99.999%) στα διαλύματα των ρύπων, για 2 ώρες πριν την έναρξη των φωτοκαταλυτικών πειραμάτων. Ο αναλυτικός προσδιορισμός του πορτοκαλόχρου του μεθυλίου έγινε φωτομετρικά στα 466.5 nm (εMethyl Orange = 25,100M⁻¹.cm⁻¹).

7.3 Φωτοκαταλυτική Αποικοδόμηση της Χοωστικής Ποοτοκαλόχοουν του Μεθυλίου (Methyl Orange) με μεταλλικές επικαλύψεις Ni-P/TiO2

7.3.1. Επιλογή του ούπου

Τα ουπογόνα παράγωγα της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας είναι ένα πρόβλημα, το οποίο την τελευταία δεκαετία έχει λάβει απροσδόκητα μεγάλες διαστάσεις [2]. Τα παραπροϊόντα βαφής περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις χρωμάτων, τα οποία λόγω της χημικής δομής τους δεν βιοδιασπώνται και περιγράφονται από μεγάλους χρόνους ημιζωής στο περιβάλλον [3]. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και οι κίνδυνοι υγείας που ελλοχεύουν, αλλά και κοινωνικοί, αφού η ούπανση είναι ορατή από τον άνθρωπο (χρωματισμός υδάτων). Γενικότερα, τα αζωχρώματα αποτελούν περισσότερο από 50% των χρωστικών που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία και η δημιουργία σχετικών αποβλήτων δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα στις βιομηχανίες αυτές [4]. Δραστική παρέμβαση και κοινοτική νομοθεσία οδήγησε στην υιοθέτηση λύσεων όπως ο βιολογικός καθαρισμός, η χρήση υπερδιηθητικών μεμβρανών και η καύση σε κλιβάνους των ούπων [5]. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή κρίνεται ασύμφορη οικονομικά και πρακτικά (μεταβλητή χημική σύσταση των ούπων μπορεί να καταστρέψει τους βιολογικούς καθαρισμούς, οι μεμβράνες προκαλούν πτώση πίεσης σε διεργασίες εν σειρά, η καύση των ούπων απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις), αφού αδυνατεί να συμβιβάσει την βιομηχανική βιωσιμότητα με την κοινωνική ευαισθησία.

Η επιλογή του Πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου (Methyl Orange, MO) βασίζεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο αζώχρωμα αποτελεί

χαφακτηφιστικό εκπφόσωπο των χφωμάτων που χφησιμοποιούνται στη βιομηχανία βαφής και στην κλωστοϋφαντουφγία. Η ύπαφξη του συγκεκφιμένου φύπου στο πεφιβάλλον συνδέεται με ανάπτυξη νεοπλασιών τόσο από την ίδια τη χφωστική, όσο και από τα βενζολικά παφάγωγα διάσπασής της [6].



Σχήμα 7.2 . Συντακτικός τύπος του Πορτοκαλόχρουν Μεθυλίου (Methyl Orange, MO).

Η αξία της επιλογής του συγκεκοιμένου ούπου δεν υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη εξάλειψης των αζωχοωμάτων από τα φυσικά ύδατα και το περιβάλλον, αλλά επιπλέον από την ανάγκη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων κατά την αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης σύνθετων επικαλύψεων με ενισχυτικό μέσο την ΤίΟ2. Το συγκεκριμένο αζώχρωμα έχει αξιολογηθεί ως μόριο μοντέλο της οικογένειας των αζωχρωμάτων και τα προϊόντα του φωτοκαταλυτικού αποχρωματισμού έχουν διευκρινισθεί με τη βοήθεια φασματοσκοπίας μάζας [7-8]. Οι χημικές ιδιότητες κατατάσσουν το μόριο στην οικογένεια των δεικτών με pK_α = 3.75. Η ευκολία που παρέχει στην φωτοκαταλυτική διεργασία βασίζεται στον εύκολο φωτομετοικό προσδιορισμό του, αφού ο δείκτης αυτός παρουσιάζει υψηλό συντελεστή μοριακής απορροφητικότητας σε ορατό μήκος κύματος (ε = 25100 cm⁻¹. M^{-1} σε λ = 466.5 nm). Επιπλέον, επιδεικνύει υψηλή διαλυτότητα στο νερό ώστε να παρασκευάζονται εύκολα διαλύματα με μεγάλη οπτική απορρόφηση.

Το χοώμα του δείκτη οφείλεται στο εκτεταμένο συζυγιακό σύστημα των π-τοοχιακών των βενζολικών δακτυλίων μαζί με τον ακόφεστο διαζωνιακό δεσμό. Ο τελευταίος μάλιστα είναι επιοφεπής στην ποοσβολή από οξειδωτικές οίζες που παράγονται από την φωτοκαταλυτική διεργασία. Έτσι, ο αποχρωματισμός των διαλυμάτων του ούπου δεν συνοδεύεται από ανάπτυξη άλλων κορυφών στο υπεριώδες - ορατό φάσμα. Επομένως τα ενδιάμεσα προϊόντα της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης δεν ανταγωνίζονται φωτομετοικά το μητοικό μόριο, και τελικά ο φωτομετοικός προσδιορισμός του ΜΟ γίνεται χωρίς σφάλμα.

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα κατά την επιλογή του δείκτη αποδεικνύεται η ελάχιστη απορρόφησή του στην εγγύς υπεριώδη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, σε μήκη κύματος δηλαδή της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται ώστε να λάβει χώρα η διέγερση του ημιαγωγού τιτανίας.



Σχήμα 7.3. Φάσμα της απορρόφησης της χρωστικής Πορτοκαλόχρουν Μεθυλίου και φασματική κατανομή της ακτινοβολίας της πηγής που χρησιμοποιείται στις φωτοκαταλυτικές διεργασίες.

Στο σχήμα 7.3 φαίνεται ότι η χρωστική δεν εμπλέκεται στην φασματική κατανομή των λυχνιών φωτοκατάλυσης, παρουσιάζει δηλαδή ελάχιστο απορρόφησης στην περιοχή των 350 nm. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην διερεύνηση του φωτοκαταλυτικού μηχανισμού αφού άμεσα αποκλείεται ο μηχανισμός που περιλαμβάνει του ούπου (sensitized φωτοδιεγερμένη μορφή photocatalysis, ευαισθητοποιημένη φωτοκατάλυση). Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτό [9-11], ο ούπος απορροφάει τα φωτόνια και μεταβαίνει σε διεγερμένη κατάσταση. Η διεγερμένη μορφή αποδίδει ηλεκτρόνια στην ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού, ενώ η ίδια υπόκειται σε οξείδωση. Ο μηχανισμός αυτός λαμβάνει χώρα συνήθως με χρωστικές οι οποίες φέρουν κατάλληλες λειτουργικές ομάδες (καρβοξυλικές, φωσφονικές) ώστε να χημειορροφούνται στα επιφανειακά υδροξύλια του υμενίου της τιτάνιας. Η τελευταία προϋπόθεση είναι απαραίτητη για την απευθείας έγχυση ηλεκτρονίου στη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού. Με την επιλογή του κατάλληλου ούπου (χρωστική MO) αποκλείεται ο μηχανισμός αυτός. Η χρωστική που επιλέχθηκε για την αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας δεν απορροφά στην περιοχή φωτοβόλησης του ημιαγωγού, ούτε φέρει λειτουργικές ομάδες από τις οποίες μπορεί να προσροφηθεί χημικά στην επιφάνεια του διοξειδίου του τιτανίου. Η φωτοκαταλυτική διεργασία λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω της αλληλεπίδρασης του ημιαγωγού με την ακτινοβολία, προκαλώντας την δημιουργία φωτοεπαγόμενων ζευγών ηλεκτρονίων και θετικών οπών (e-/h+). Τα φωτοεπαγόμενα φορτία είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την δημιουργία οξειδωτικών ριζών που προσβάλλουν το αζώχρωμα, προκαλώντας την αποικοδόμησή του.

7.4 Βελτιστοποίηση παφαμέτφων παφασκευής μεταλλικών επικαλύψεων Ni-P/TiO2

Η φωτοκαταλυτική ικανότητα μεταλλικών επικαλύψεων Ni-P με ενσωμάτωση νανοσωματιδίων TiO₂ αρχικά αξιολογήθηκε ως συνάρτηση της ποσότητας του TiO₂, της θερμικής κατεργασίας, του τύπου του ρεύματος που εφαρμόστηκε, και της συχνότητας αυτού.



Σχήμα 7.4. Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ΜΟ ως συνάφτηση του τύπου φεύματος, της ποσότητας ΤiO₂ και της θεφμικής κατεφγασίας.

Από τα παφαπάνω αποδεικνύεται ότι την καλυτεφη φωτοκαταλυτική δφάση παφουσιάζουν οι επικαλύψεις οι οποίες παφασκευάστηκαν ηλεκτφοχημικά με χφήση παλμικού φεύματος σε συχνότητα παλμών ν=100 Hz, το λουτφό πεφιείχε 100g/L TiO₂ και ήταν θεφμικά κατεφγασμένα. Το συμπέφασμα αυτό δεν είναι ανεξάφτητο της συγκέντφωσης του TiO₂ στην κφαματική μήτφα. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται αφενός στην υψηλή συγκέντφωση του ημιαγωγού TiO₂ που εναποτίθενται στη μεταλλική επιφάνεια (δες σχήμα 5.1) και αφετέφου στην κφυσταλλική δομή της μήτφας και στην πυφοσυσσωμάτωση των νανοσωματιδίων τιτανίας που αποκτάται μετά τη θεφμική κατεφγασία υπογφαμμίζοντας την συνέφγια μετάλλου και τιτάνιας στη φωτοκαταλυτική δφάση.

7.5 Κινητική φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης Πορτοκαλόχρουν Μεθυλίου (Methyl Orange).

Στο σχήμα 7.5 παφουσιάζεται η κινητική αποχφωματισμού του διαλύματος του αζωχφώματος – φύπου, παφουσία των παφασκευασμένων φωτοκαταλυτών. Επισημαίνεται ότι η κινητική αποικοδόμησης είναι ψευδοπφώτης τάξης, όπως ακφιβώς αναμένεται από το μοντέλο Langmuir – Hinshelwood. Η επικάλυψη που παφασκευάστηκε σε λουτφό σύστασης 100g/L TiO₂ και με την εφαφμογή παλμικό φεύματος με συχνότητα ν= 100Hz, το οποίο υπέστη θεφμική κατεφγασία, επιδεικνύει σχεδόν τη διπλάσια ικανότητα αποικοδόμησης φύπου σε σχέση με την επικάλυψη που παφασκευάστηκε με λουτφό σύστασης 50g/L TiO₂ σε συνθήκες συνεχούς φεύματος χωφίς να υποστεί θεφμική κατεφγασία.



Σχήμα 7.5α: Επί της εκατό ποσοστό αρχικής [MO] σε συνάρτηση με το χρόνο για τις μεταλλικές επιφάνειες που παρασκευάστηκαν σε λουτρό 50gr/L TiO₂ και δεν υπέστησαν θερμική κατεργασία



Σχήμα 7.5β: Επί της εκατό ποσοστό αρχικής [MO] συναρτήσει με το χρόνο για μεταλλικές επιφάνειες που παρασκευάστηκαν σε λουτρό 50g/L TiO₂ και υπέστησαν θερμική κατεργασία.



Σχήμα 7.5γ: Επί της εκατό ποσοστό αρχικής [MO] συναρτήσει του χρόνου για μεταλλικές επιφάνειες που παρασκευάστηκαν σε λουτρό 100g/L TiO₂ και δεν υπέστησαν θερμική κατεργασία



Σχήμα 7.5δ: Επί της εκατό ποσοστό αρχικής [MO] συναρτήσει με το χρόνο για μεταλλικές επιφάνειες που παρασκευάστηκαν σε λουτρό 100g/L TiO₂ και υπέστησαν θερμική κατεργασία

Κατά τη φωτοκαταλυτική διεργασία αποικοδόμησης του ούπου χρησιμοποιήθηκε εγγύς υπεριώδης ακτινοβολία (UV-A, 350 nm). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το MO: (α) παρουσιάζει μέγιστο απορρόφησης στο ορατό (συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας ε = 25100 M⁻¹·cm⁻¹ στα 466.5 nm) και ελάχιστο απορρόφησης στο υπεριώδες, ενώ (β) δεν φέρει λειτουογικές ομάδες που επιτοέπουν την χημειοορόφηση στα επιφανειακά υδροξύλια της τιτάνιας, συμπεραίνεται ότι ο μηχανισμός της ευαισθητοποιημένης φωτοκατάλυσης (sensitized photocatalysis) αποορίπτεται (παράγραφος 7.3.1, [12-14]).

7.6 Συμπεράσματα

Απ' όσα αναφέφθηκαν παφαπάνω γίνεται σαφές ότι η χφήση ενσωματωμένων νανοσωματιδίων TiO₂ σε μεταλλικές επιφάνειες μόνο θετικά αποτελέσματα μποφεί να αποφέφει. Τα πειφαματικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι σύνθετες επικαλύψεις με αυξημένη συγκέντφωση TiO₂ στην κφαματική μήτφα, με εφαφμογή παλμικού φεύματος σε συχνότητα ν=100Hz και θεφμική κατεφγασία παφουσιάζουν τα καλύτεφα αποτελέσματα όσον αφοφά τη φωτοκαταλυτική δφάση της μεταλλικής επικάλυψης.

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 7

[1] A.I. Vogel, B.S. Furniss, A.J. Hannaford, P.W.G. Smith, Textbook of Practical Organic Chemistry, Prentice Hall, 1989.

[2] V.M. Correia, T. Stephenson, S.J. Judd, *Environ. Technol.*, 15 (1994) 917.

[3] P. Grau, Water Sci. Technol., 24 (1991) 97.

[4] H. Zollinger, "Color Chemistry: Synthesis, Properties and Applications of Organic Dyes and Pigments", VCH Publishers, New York, 1987.

[5] A. Erswell, C.J. Brouckaert, C.A. Buckley, *Desalination*, 70 (1988) 157.

[6] K.-T. Chung, C.E. Cerniglia, *Mutat. Res.* 277 (1992) 201.

[7] S. Al-Qaradawi, S.R. Salman, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 148 (2002) 161.

[8] C. Baiocchi, M.C. Brussino, E. Pramauro, A. Bianco Prevot, L. Palmisano, G. Marcì, *Int. J. of Mass Spect.* 214 (2002) 247.

[9] F. Kiriakidou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, *Catal. Today* 54 (1999) 119.

[10] F. Zhang, J. Zhao, T. Shen, H. Hidaka, E. Pelizzetti, N. Serpone, *Appl. Catal. B Environ.* 15 (1998) 147.

[11] F. Chen, Y. Xie, J. Zhao, G. Lu, Chemosphere 44 (2001) 1159.

[12] F. Kiriakidou, D.I. Kondarides, X.E. Verykios, *Catal. Today* 54 (1999) 119.

[13] F. Zhang, J. Zhao, T. Shen, H. Hidaka, E. Pelizzetti, N. Serpone, *Appl. Catal. B Environ.* 15 (1998) 147.

[14] F. Chen, Y. Xie, J. Zhao, G. Lu, Chemosphere 44 (2001) 1159.

Κεφάλαιο 8° Συμπεράσματα – Προοπτικές

8.1 Συμπεράσματα

Τα πειραματικά αποτελέσματα των σύνθετων αποθεμάτων Ni-P/TiO2 έδειξαν πως υπάρχει εξάοτηση του ποσοστού συναπόθεσης νανοσωματιδίων TiO2 από τις επιβαλλόμενες συνθήκες ηλεκτρόλυσης. Πιο συγκεκοιμένα, αύξηση της ποσότητας της τιτανίας μέσα στο λουτοό (από 50 σε 100 g/L) και επιβολή παλμικού ρεύματος και ιδιαίτερα υψηλών συχνοτήτων παλμών, για τις ίδιες τιμές duty cycle και ταχύτητας περιστροφής της καθόδου, ευνοούν τη συναπόθεση του ενισχυτικού μέσου TiO2. Το υψηλότερο ποσοστό συναπόθεσης νανοσωματιδίων τιτανίας ίσο με ~5 wt.%, παρατηρήθηκε σε συνθήκες v=100 Hz και 100g/L TiO2. Η μήτρα Ni-P των σύνθετων επικαλύψεων χαρακτηρίζεται ως άμορφη πριν τη θεομική κατεογασία τους, ενώ μετά τη θεομική κατεογασία στους 400°C κουσταλλώνεται στις φάσεις Νί και Νί3Ρ. Επιπλέον, παρατηρείται στα διαγράμματα XRD ότι η τιτανία εμφανίζεται με την μορφή του ανατάση.

Όσον αφορά στη μικροσκληρότητα των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO2, διαπιστώθηκε ότι η επιβολή παλμικού gεύματος επιφέgει αύξησή της και στις δύο περιπτώσεις ποσότητας ενισχυτικού μέσου στο λουτρό, 50 και 100g/L. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 4,8- 5,3 GPa και 5,1-5,5 GPa, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση. Η θερμική κατεργασία έχει ευεργετική επίδραση στη μικροσκληρότητα των σύνθετων αποθεμάτων και στις δύο περιπτώσεις (50 και 100g/L TiO2) καθώς η μήτρα Ni-P κρυσταλλώνεται και δημιουργούνται κούσταλλοι Ni και Ni₃P αποτέλεσμα με η μικροσκληρότητα να λαμβάνει μέγιστη τιμή ~10.49 GPa -στην περίπτωση των 50g/L TiO₂ στο λουτοό, και ~10,00 GPa για ποσότητα TiO₂ στο λουτοό ίση με 100g/L.

Όσον αφορά στον συντελεστή τριβής ολίσθησης των σύνθετων επικαλύψεων Ni-P/TiO₂ η εφαρμογή παλμικού ρεύματος και η θερμική κατεργασία είχαν ως αποτέλεσμα την μείωσή του σε σχέση με αυτόν του συνεχούς ρεύματος, και στις δυο περιπτώσεις παρασκευής των σύνθετων αποθεμάτων (50 και 100g/L).

Γενικά, συγκρίνοντας επικαλύψεις μήτρας Νi και απλών ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων Ni-P καθώς και σύνθετων Ni-P/SiC αποθεμάτων προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη αντίσταση σε φθορά εκτριβής παρουσιάζουν οι επικαλύψεις Ni-P/TiO₂ που παρασκευάστηκαν σε συνθήκες παλμικού ρεύματος και με 50g/L TiO₂ στο λουτρό. Γενικά, η φθορά εκτριβής διαπιστώθηκε ότι συνδέεται με το ποσοστό συναπόθεσης νανοσωματιδίων τιτανίας στην κραματική μήτρα, όπου παρατηρήθηκε ότι υψηλά ποσοστά συναπόθεσης συνοδεύονται από μεγαλύτερη **αντίσταση στη φθορά τριβής ολίσθησης**.

Και στις δυο περιπτώσεις παρασκευής των σύνθετων αποθεμάτων (50 και 100g/L) οι μηχανισμοί φθοράς λογω τριβής ολίσθησης που παρατηρούνται πριν τη θερμική τους κατεργασία είναι οι : εκτριβής, πρόσφυσης και οξείδωσης. Μετά την ανόπτησή τους στους 400°C ο μηχανισμός που κυριαρχεί είναι ο μηχανισμός άροσης.

Τα πειραματικά αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι σύνθετες επικαλύψεις με αυξημένη συγκέντρωση TiO₂ στην κραματική μήτρα, με εφαρμογή παλμικού ρεύματος σε συχνότητα ν=100Hz και θερμική κατεργασία παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη φωτοκαταλυτική δράση της μεταλλικής επικάλυψης.

8.2 Προοπτικές

Μετά τη διεξαγωγή της συγκεκοιμένης εργασίας γίνεται φανερό πως υπάρχει αρκετός χώρος για προέκταση της τόσο ενδιαφέρουσας αυτής έρευνας στην περιοχή της σύγχρονης νανοτεχνολογίας.

- Ενδείκνυται η μελέτη της αντοχής σε διάβρωση των σύνθετων επικαλύψεων καθώς και σε συνθήκες διάβρωσης με ταυτόχρονη μηχανική καταπόνηση (tribocorrosion).
- Προτείνεται μελέτη του αυτοαποστειοούμενου η και αντιμικοοβιακού χαρακτήρα των σύνθετων μεταλλικών επικαλύψεων μήτρας Ni-P με ενίσχυση νανοσωματιδίων TiO2, έτσι ώστε οι επικαλύψεις αυτές να μπορούν να βρουν εφαρμογή στην κατασκευή χειοουογικών εργαλείων και άλλων αποστειρωμένων επιφανειών.
- Στις σύνθετες αυτές επικαλύψεις εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη της συνδυασμένης επίδρασης δύο διαφορετικών ειδών νανοσωματιδίων στα δομικά χαρακτηριστικά τους με τις μετρούμενες ιδιότητες (ενισχυμένες μηχανικές και από τα δύο είδη SiC/ TiO₂ αλλά & τις φωτοεπαγόμενες από τα νανοσωματίδια TiO₂).
- Μελέτη της συμπεριφοράς του εγκλεισμού των νανοσωματιδίων ΤiO² και σε άλλες μήτρες, όπως για παράδειγμα σε Al καθώς και διεύρυνση των εφαρμογών που μπορούν να έχουν σύνθετες οι μεταλλικές επικαλύψεις σε σύγχρονες χαμηλού βάρους κατασκευές, όπου απαιτείται αυξημένη αντοχή στη διάβρωση.